Rec'd PCT/PTO 07 DEC 2004

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際

10/517139

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年1月29日(29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/010129 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 27/409,

27/419, 27/41, F02D 41/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/003956

(22) 国際出願日:

2003 年3 月28 日 (28.03.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-212891

2002年7月22日(2267,2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 本 田技研工業株式会社 (HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒107-8556 東京都 港 区 南青山二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 安井 裕司(YA-SUI,Yuji) [JP/JP]; 〒351-0193 埼玉県 和光市 中央 1 丁 目4番1号株式会社本田技術研究所内 Saitama (JP). 岩城 喜久 (IWAKI, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒351-0193 埼玉 県和光市中央1丁目4番1号株式会社本田技術研 究所内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 佐藤 辰彦, 外(SATO, Tatsuhiko et al.); 〒 151-0053 東京都 渋谷区 代々木 2-1-1 新宿マイン ズタワー16階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

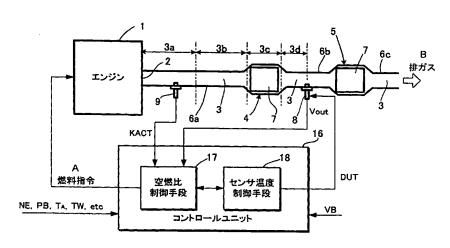
添付公開書類:

国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: TEMPERATURE CONTROLLER FOR EXHAUST GAS SENSOR, ITS TEMPERATURE CONTROL METHOD, AND MEDIUM ON WHICH PROGRAM FOR TEMPERATURE CONTROL OF EXHAUST GAS SENSOR IS RECORDED

(54) 発明の名称: 排ガスセンサの温度制御装置およびその温度制御方法、並びに排ガスセンサの温度制御用プログ ラムの記録媒体



1...ENGINE

A...FUEL COMMAND

17...AIR-FUEL RATIO CONTROL MEANS

18...SENSOR TEMPERATURE CONTROL METHOD

16...CONTROL UNIT

B...EXHAUST GAS

(57) Abstract: A control input (DUT) for controlling a heater (13) for heating an element part (10) of an exhaust gas sensor (8) includes at least one of another component corresponding to the difference between the temperature data on the element part (10) and the target temperature, a component corresponding to the target temperature, and a component corresponding the temperature data on the element part (10). The control input is



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

determined by an optimal control algorithm. The component corresponding to the temperature of the exhaust gas and the component corresponding the target component are determined by a preview control algorithm. In such a way, the temperature of the element part (10) of the exhaust gas sensor (8) can be stably controlled at a desired one.

(57) 要約:

排ガスセンサ(8)の素子部(10)を加熱するヒータ(13)を操作するための制御入力(DUT)に、素子部(10)の温度データと目標温度との偏差に応じた他の成分、目標温度に応じた成分、素子部(10)の温度データに応じた成分のうちの少なくとも一つ以上の成分を含める。制御入力は、最適制御アルゴリズムにより求める。排ガスの温度に応じた成分と目標温度に応じた成分は、予見制御のアルゴリズムに基づいて求める。これにより、排ガスセンサ(8)の素子部(10)の温度を安定して所望の温度に制御する。

明細書

排ガスセンサの温度制御装置およびその温度制御方法、並びに排ガス センサの温度制御用プログラムの記録媒体

技術分野

5 本発明は、内燃機関の排気通路に備えた排ガスセンサの温度制御装置 およびその温度制御方法、並びに排ガスセンサの温度制御用プログラム の記録媒体に関する。

背景技術

20

10 内燃機関の排気通路には、内燃機関の運転制御や排ガス浄化システムの状態監視等を目的として、排ガスの成分濃度等、排ガスの成分状態に関する物理量を検出する排ガスセンサが備えられることが多々ある。該排ガスセンサは、検出しようとする排ガスの成分状態に感応する素子部が排気通路を流れる排ガスに接触するようにして該排気通路の所要の箇所に配置される。例えば排気通路に備えた排ガス浄化用の触媒の浄化性能を良好に保つように内燃機関の空燃比を制御することを目的として、O2センサ等の空燃比センサが触媒の上流側や下流側に配置される。

また、この種の排ガスセンサは、その素子部の本来の機能を発揮させるための昇温・活性化や、素子部に付着した異物の除去等を目的として該素子部を加熱するためのヒータを内蔵したものもある。例えば、前記 O₂ センサ等の空燃比センサには、通常、その素子部を加熱する電熱ヒータが備えられ、内燃機関の運転開始後、該電熱ヒータにより O₂ センサの素子部を昇温して活性化し、その活性状態に維持することが行われている。

10

15

20

25

 ε_{\bullet}

ところで、前記 O_2 センサは、後に説明する図3に示すように、その素子部が感応する排ガスの酸素濃度が表す排ガスの空燃比の極めて狭い範囲 Δ (理論空燃比近傍の範囲)においてのみ、該空燃比の変化に対して出力電圧V out が大きな傾きで変化する(空燃比の変化に対する感度が高感度なものとなる)。そして、その高感度な範囲 Δ よりもリッチ側の空燃比域とリーン側の空燃比域とでは、 O_2 センサの出力電圧V outの変化(空燃比に対する傾き)は微小なものとなる。また、 O_2 センサの出力特性(上記の高感度な部分の傾き等)は、素子部の温度の影響を受けて変化する。従って、このような O_2 センサの出力を用いて空燃比制御を行うような場合には、 O_2 センサの出力特性をできるだけ所要の特性に安定して維持し、ひいては空燃比制御を良好に行うために、 O_2 センサの素子部の温度をできるだけ安定に所望の温度に維持することが望まれる。

また、O₂ センサに限らず、多くの排ガスセンサは、その出力特性が素子部の温度の影響を受けるため、該排ガスセンサの出力を用いて内燃機関等の制御を行う場合、その制御を良好に行うために、該排ガスセンサの素子部の温度を所望の温度にできるだけ安定に維持することが好ましい。さらに、排ガスセンサの素子部のクリーニングを行うために該素子部をヒータで加熱するような場合であっても、そのクリーニングを良好に行うためには、該排ガスセンサの素子部の温度を所望の温度に維持することが好ましい。

一方、例えば特開 2000-304721 号公報に本願出願人が開示したように、排ガスセンサ(同公報のものでは空燃比センサ)の素子部の温度を推定し、その推定した素子部の温度に応じてヒータ(電熱ヒータ)の通電制御を行うことで、素子部の温度が所望の温度になるようにして、該排ガスセンサの好適な出力特性が得られるようにしたものが知られてい

10

15

25

る。尚、同公報のものでは、ヒータの通電電流及び印加電圧を検出して それらの検出値からヒータの抵抗値を把握すると共に、該ヒータの抵抗 値に基づいて排ガスセンサの素子部の温度を推定するようにしている。

しかしながら、前記公報のものでは、排ガスセンサの素子部の温度の推定値から、データテーブルによりヒータへの供給電力を規定するデューティを一義的に決定するようにしているものに過ぎないため、排ガスの温度変化、外気温等の影響によって、排ガスセンサの素子部の温度を所望の温度に安定して制御することが困難であった。また、排ガスセンサの素子部の温度が低い状態では、ヒータのデューティを一定の最大値に維持するため、必用以上にヒータが電力を消耗したり、ヒータや素子部の実際の温度が過熱状態となって、それらの損傷を生じる虞れがあった。

本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、排ガスセンサの素子部の温度を安定して所望の温度に制御することができる排ガスセンサの温度制御装置及び温度制御方法を提供することを目的とする。さらに、排ガスセンサの素子部の温度を安定して所望の温度に制御することができる排ガスセンサの温度制御用プログラムを記憶保持した記録媒体を提供することを目的とする。

20 発明の開示

本発明の排ガスセンサの温度制御装置は、内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置に関するものである。そして、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第1の態様は、前記の目的を達成するために、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得

10

15

20

25

9 0

する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法は、内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法に関するものである。そして、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第1の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体は、 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する 素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の 温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プロ グラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関するも のである。そして、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの第

10

15

20

25

1の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表すますの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第1の態様によれば、前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含む制御入力(制御対象の操作量)、換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に応じてヒータを制御するので、素子部の温度が目標温度に対して変動したときに、ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力の過大な変動を抑えながら、素子部の温度を目標温度に収束させることが可能となる。その結果、排ガスセンサの素子部の温度を安定に目標温度に制御することができる。

尚、本発明の第1の態様では、素子部の温度を表す素子温度データは、 温度センサを用いて直接的に検出して取得するようにしてもよく、ある いは、適宜のパラメータやモデルに基づいて推定して取得するようにし てもよい。このことは、ヒータの温度を表すヒータ温度データについて も同様である。

10

15

20

25

また、前記制御入力における素子部の温度と目標温度との偏差に応じた入力成分は、例えば該偏差に比例した成分、該偏差の所定時間毎の累積加算値(積分値)に比例した成分、あるいはこれらの成分を加え合わせたもの等である。このことは、後述する本発明の第2の態様、第3の態様、第4の態様でも同様である。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第2の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第2の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の

10

15

20

第2の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す 素子温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取 得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温 度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータ への発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理 を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御 入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少な くとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差 に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じ た入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるよう に構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第2の態様によれば、素子温度データが表す素子部の 温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む制御入力、換言すれば、 少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に応じてヒータ を制御するので、素子部の温度に対する排ガスの温度の変動の影響を補 償しつつ、素子部の温度を目標温度に収束させることが可能となる。換 言すれば、排ガスの温度の変動による素子部の温度の変動を抑えつつ素 子部の温度を目標温度に制御することが可能となる。その結果、排ガス センサの素子部の温度を安定に目標温度(所望の温度)に制御すること ができる。

尚、本発明の第2の態様では、素子部の温度を表す素子温度データは、 前記第1の態様と同様、温度センサを用いて直接的に検出して取得する 25 ようにしてもよく、あるいは、適宜のパラメータやモデルに基づいて推 定して取得するようにしてもよい。このことは、排ガスの温度を表す排

20

25

ガス温度データについても同様である。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第3の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

10 同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第3の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第3の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温

15

20

25

度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第3の態様によれば、前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む制御入力、換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に応じてヒータを制御するので、素子部の温度の目標温度への追従を速やかに行うことができる。その結果、排ガスセンサの素子部の温度を安定に目標温度に制御することができる。

10 尚、本発明の第3の態様では、素子部の温度を表す素子温度データは、 第1の態様と同様、温度センサを用いて直接的に検出して取得するよう にしてもよく、あるいは、適宜のパラメータやモデルに基づいて推定し て取得するようにしてもよい。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第4の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第4の態様は、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成す

10

15

20

るとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第4の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第4の態様によれば、前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分に加えて、該素子部の目標温度に応じた入力成分を含む制御入力、換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に応じてヒータを制御するので、素子部の温度が目標温度に対してオーバシュートを生じるのを低減し、素子部の温度を目標温度に滑らかに追従させることができる。その結果、排ガスセンサの素子部の温度を安定に目標温度に制御することができる。

25 尚、本発明の第4の態様では、素子部の温度を表す素子温度データは、 第1の態様と同様、温度センサを用いて直接的に検出して取得するよう

にしてもよく、あるいは、適宜のパラメータやモデルに基づいて推定して取得するようにしてもよい。

ところで、前述の第1~第4の態様の発明は、素子部の温度を直接的に目標温度に制御するものであるが、一般に、ヒータの温度と素子部の温度とはそれらの温度がほぼ一定となるような定常状態では高い相関性を有する。従って、ヒータの温度をある目標温度に制御するようにすれば、素子部の温度は、間接的にヒータの目標温度に対応した温度に制御できることとなる。

そこで、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第5の態様は、前記 素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御 手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第5の態様は、前記 20 素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得しつつ、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記 25 ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分

10

15

とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第5の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第5の態様は、前記第1の態様に対応するものであり、 ヒータの温度を目標温度に制御することに関して、該第1の態様と類似 の効果を奏することができる。すなわち、本発明の第5の態様によれば、 前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度(ヒータの温 度の目標値)との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す 素子部の温度に応じた入力成分とを含む制御入力(制御対象の操作量)、 換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に 応じてヒータを制御するので、ヒータの温度が目標温度に対して変動し たときに、制御入力の過大な変動を抑えながら、ヒータの温度を目標温 度に収束させることが可能となる。その結果、排ガスセンサのヒータの 温度を安定に目標温度に制御することができ、ひいては、素子部の温度

10

15

20

25



を該ヒータの目標温度に対応した温度に安定に制御することができる。

尚、本発明の第5の態様で、素子部の温度を表す素子温度データや、 ヒータの温度を表すヒータ温度データは、前記第1の態様と同様、温度 センサで検出・取得するようにしてもよく、あるいは、推定して取得す るようにしてもよい。

また、前記制御入力におけるヒータの温度と目標温度との偏差に応じた入力成分は、例えば該偏差に比例した成分、該偏差の所定時間毎の累積加算値(積分値)に比例した成分、あるいはこれらの成分を加え合わせたもの等である。このことは、後述する本発明の第6の態様、第7の態様、第8の態様でも同様である。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第6の態様は、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第6の態様は、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス 温度データとを逐次取得しつつ、前記ヒータ温度データが表すヒータの 温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供 給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを 制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前

10

15

20

25



記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第6の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第6の態様は、前記第2の態様に対応するものであり、 ヒータの温度を目標温度に制御することに関して、該第2の態様と類似 の効果を奏することができる。すなわち、本発明の第6の態様によれば、 前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応 じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入 力成分とを含む制御入力、換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成 して生成される制御入力に応じてヒータを制御するので、素子部の温度、 ひいてはヒータの温度に対する排ガスの温度の変動の影響を補償しつつ、 ヒータの温度を目標温度に収束させることが可能となる。換言すれば、

排ガスの温度の変動によるヒータの温度の変動を抑えつつヒータの温度 を目標温度に制御することが可能となる。その結果、排ガスセンサのヒ ータの温度を安定に目標温度に制御することができ、ひいては、排ガス センサの素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度に安定に制御 することができる。

尚、本発明の第6の態様で、ヒータの温度を表すヒータ温度データや、 排ガスの温度を表す排ガス温度データは、前記第2の態様と同様、温度 センサで検出・取得するようにしてもよく、あるいは、推定して取得す るようにしてもよい。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第7の態様は、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第7の態様は、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得しつつ、前記ヒータ温 度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータ への発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その 制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生 成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前 記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分 とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とするもの である。

10

15

20

25

 $\theta = \theta^{-1}$

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第7の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第7の態様は、前記第3の態様に対応するものであり、 ヒータの温度を目標温度に制御することに関して、該第3の態様と類似 の効果を奏することができる。すなわち、本発明の第7の態様によれば、 前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応 じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む制御入力、換言 すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に応じ てヒータを制御するので、ヒータの温度の目標温度への追従を速やかに 行うことができる。その結果、排ガスセンサのヒータの温度を安定に目 標温度に制御することができ、ひいては、素子部の温度をヒータの目標 温度に対応した温度に安定に制御することができる。

尚、本発明の第7の態様で、ヒータの温度を表すヒータ温度データは、 第3の態様と同様、温度センサで検出・取得するようにしてもよく、あ るいは、推定して取得するようにしてもよい。

また、本発明の排ガスセンサの温度制御装置の第8の態様は、前記ヒ

10

15

20

25

PCT/JP2003/003956

ータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ 温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒー タへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、そ の制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒー タ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが 表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該ヒー タの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とするものである。

同様に、本発明の排ガスセンサの温度制御方法の第8の態様は、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得しつつ、前記ヒータ温 度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータ への発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その 制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生 成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前 記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該ヒータの温度に応じた入力 成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする ものである。

さらに、本発明の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体の第8の態様は、前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該ヒータの温度

10

15

20

25

に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とするものである。

かかる本発明の第8の態様は、前記第4の態様に対応するものであり、 ヒータの温度を目標温度に制御することに関して、該第4の態様と類似 の効果を奏することができる。すなわち、本発明の第8の態様によれば、 前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応 じた入力成分と、該ヒータの温度に応じた入力成分とを含む制御入力、 換言すれば、少なくとも上記入力成分を合成して生成される制御入力に 応じてヒータを制御するので、ヒータの温度が目標温度に対してオーバ シュートを生じるのを低減し、ヒータの温度を目標温度に滑らかに追従 させることができる。その結果、排ガスセンサのヒータの温度を安定に 目標温度に制御することができる。

尚、本発明の第8の態様では、前記第4の態様と同様、ヒータの温度 を表すヒータ温度データは、温度センサを用いて直接的に検出して取得 するようにしてもよく、あるいは、適宜のパラメータやモデルに基づい て推定して取得するようにしてもよい。

前述した本発明の第1~第4の態様は、温度制御装置、温度制御方法、及び記録媒体のいずれにおいても、それらの二つ以上の態様を複合させることが好ましい。第1の態様及び第2の態様の温度制御装置を複合させる場合には、前記第1の態様の温度制御装置において、前記排ガスセンサの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段を備え、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分を含む。同様に、第1の態様及び第2の態様のの温度制御方法を複合させる場合には、前記第1の態様の温度制御方法において、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得するス

15

20

25

テップをさらに備え、前記制御入力を生成するとき、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成する。さらに、第1の態様の及び第2の態様の記録媒体を複合させる場合には、前記第1の態様の記録媒体において、前記温度制御用プログラムは、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムをさらに含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成する。

10 このように第1の態様と第2の態様とを複合させることにより、それらの態様による効果が重畳されて、素子部の温度をより安定に目標温度に制御することができる。

さらに、前記第1の態様の温度制御装置、あるいは、これに第2の態様の温度制御装置を複合させたものにおいて、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記目標温度に応じた入力成分を含めることにより、第1の態様及び第3の態様の温度制御装置を複合させた発明、あるいは、第1~第3の態様の温度制御方法、あるいは、これに第2の態様の温度制御方法、あるいは、これに第2の態様の温度制御方法を複合させたものにおいて、前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御方法を複合させた発明、あるいは、第1~第3の態様の温度制御方法を複合させた発明、あるいは、第1~第3の態様の温度制御方法を複合させた発明、あるいは、第1~第3の態様の記録媒体、あるいは、第1~第3の態様の記録媒体、あるいは、定れに第2の態様の記録媒体を複合させたものにおいて、前記制御入力を対して、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成する

10

15

20

25

ことにより、第1の態様及び第3の態様の記録媒体を複合させた発明、 あるいは、第1~第3の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

上記のように第1の態様と第3の態様とを複合させた場合には、それらの効果が重畳されて、素子部の温度をより安定に目標温度に制御することができる。特に、第1~第3の態様を複合させた場合には、第1~第3の各態様の効果が重畳されて、素子部の温度の目標温度に対する安定性を好適に高めることができる。

さらに、前記第1の態様の温度制御装置、あるいは、これに第2及び 第3の態様の温度制御装置のうちの一つ以上の態様を複合させたものに おいて、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記素子温度デー 夕が表す素子部の温度に応じた入力成分を含めることにより、第1の態 様及び第4の態様の温度制御装置を複合させた発明、あるいは、さらに 第2及び第3の態様のうちの一つ以上の態様の温度制御装置を複合させ た発明を構成できる。同様に、前記第1の態様の温度制御方法、あるい は、これに第2及び第3の態様の温度制御方法のうちの一つ以上の態様 を複合させたものにおいて、前記制御入力を生成するとき、前記素子温 度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を 前記制御入力として生成することにより、第1の態様及び第4の態様の 温度制御方法を複合させた発明、あるいは、さらに第2及び第3の態様 のうちの一つ以上の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。 さらに、前記第1の態様の記録媒体、あるいは、これに第2及び第3の 態様の記録媒体のうちの一つ以上の態様を複合させたものにおいて、前 記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表 す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コン ピュータに生成させるように構成することにより、第1の態様及び第4 の態様の記録媒体を複合させた発明、あるいは、さらに第2及び第3の

10

15

20

25

態様のうちの一つ以上の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。 このように第1~第4の態様の2つ以上の態様を複合させることにより、それらの各態様の効果が重畳されて、素子部の温度の目標温度に対する安定性を高めることができる。

また、前記第2の態様の温度制御装置において、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記目標温度に応じた入力成分を含めることにより、本発明の第2の態様及び第3の態様の温度制御装置を複合させた発明を構成できる。同様に、第2の態様の温度制御方法において、前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することにより、第2の態様及び第3の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、第2の態様の記録媒体において、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、本発明の第2の態様及び第3の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

このようにすることにより、第2の態様と第3の態様の効果が重畳されて、素子部の温度をより安定に目標温度に制御することができる。

さらに、前記第2の態様の温度制御装置、あるいは、これに第3の態様の温度制御装置を複合させたものにおいて、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分を含めることにより、第2の態様及び第4の態様の温度制御装置を複合させた発明、あるいは、第2~第4の態様の温度制御装置を複合させた発明を構成できる。同様に、前記第2の態様の温度制御方法、あるいは、これに第3の態様の温度制御方法を複合させたものにおいて、前記制御入力を生成するとき、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成する

15

20

ことにより、第2の態様及び第4の態様の温度制御方法を複合させた発明、あるいは、第2~第4の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、前記第2の態様の記録媒体、あるいは、これに第3の態様の記録媒体を複合させたものにおいて、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第2の態様及び第4の態様の記録媒体を複合させた発明、あるいは、第2~第4の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

10 そして、それらの態様の複合により、それらの各態様の効果が重畳されて、素子部の温度の目標温度に対する安定性を高めることができる。

さらに、前記第3の態様の温度制御装置において、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分を含めることにより、第3の態様及び第4の態様の温度制御装置を複合させた発明を構成できる。同様に、前記第3の態様の温度制御方法において、前記制御入力を生成するとき、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することにより、第3の態様及び第4の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、前記第3の態様の記録媒体において、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第3の態様及び第4の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

この複合により第3及び第4の態様の効果が重畳されて、素子部の温 25 度の目標温度に対する安定性を高めることができる。

なお、本発明では、第1~第3の態様の全てを複合させ、もしくは、

10

15

20

25

第1~第4の態様の全てを複合させることが特に好適である。そして、第1~第3の態様の全てを複合させた場合には、前記素子部の温度と目標温度との偏差に応じた入力成分は、例えばその偏差の所定時間毎の累積加算値(積分値)に比例する成分と該偏差に比例する成分とで構成することが好ましい。また、第1~第4の態様の全てを複合させた場合には、前記素子部の温度と目標温度との偏差に応じた入力成分は、例えばその偏差の所定時間毎の累積加算値(積分値)に比例する成分により構成することが好ましい。

上述した第1~第4の態様の発明の複合に関しては、前記第5~第8 の態様の発明についても同様であり、それらの二つ以上の態様を複合さ せることが好ましい。すなわち、第5の態様及び第6の態様の温度制御 装置を複合させる場合には、前記第5の態様の温度制御装置において、 前記排ガスセンサの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段を 備え、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、該排ガス温度データ が表す排ガスの温度に応じた入力成分を含む。同様に、第5の態様及び 第6の態様の温度制御方法を複合させる場合には、前記第5の態様の温 度制御方法において、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次 取得するステップをさらに備え、前記制御入力を生成するとき、該排ガ ス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入 力を前記制御入力として生成する。さらに、第5の態様及び第6の態様 の記録媒体を複合させる場合には。前記第5の態様の記録媒体において、 前記温度制御用プログラムは、前記排ガスの温度を表す排ガス温度デー 夕を逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムをさ らに含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、該排ガス温 度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入 力を前記コンピュータに生成させるように構成する。

10

15

20

このように第5の態様と第6の態様とを複合させることにより、それらの態様による効果が重畳されて、ヒータの温度をより安定に目標温度に制御することができ、ひいては、素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度により安定に制御することができる。

さらに、前記第5の態様の温度制御装置、あるいは、これに第6の態 様の温度制御装置を複合させたものにおいて、前記ヒータ制御手段が生 成する制御入力に、前記目標温度(ヒータの温度の目標値)に応じた入 力成分を含めることにより、第5の態様及び第7の態様の温度制御装置 を複合させた発明、あるいは、第5~第7の態様の温度制御装置を複合 させた発明を構成できる。同様に、前記第5の態様の温度制御方法、あ るいは、これに第6の態様の温度制御方法を複合させたものにおいて、 前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分をさらに 含む制御入力を前記制御入力として生成することにより、第5の態様及 び第7の態様の温度制御方法を複合させた発明、あるいは、第5~第7 の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、前記第 5の態様の記録媒体、あるいは、これに第6の態様の記録媒体を複合さ せたものにおいて、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前 記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュ ータに生成させるように構成することにより、第5の態様及び第7の態 様の記録媒体を複合させた発明、あるいは、第5~第7の態様の記録媒 体を複合させた発明を構成できる。

上記のように第5の態様と第7の態様とを複合させた場合には、それらの効果が重畳されて、ヒータの温度をより安定に目標温度に制御することができ、ひいては、素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度により安定に制御できる。特に、第5~第7の態様を複合させた場合には、第5~第7の各態様の効果が重畳されて、ヒータの温度、ひいて

10

15

20

25

は、素子部の温度の安定性を好適に高めることができる。

さらに、前記第5の態様の温度制御装置、あるいは、これに第6及び 第7の態様の温度制御装置のうちの一つ以上の態様を複合させたものに おいて、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記ヒータ温度デ ータが表すヒータの温度に応じた入力成分を含めることにより、第5の 態様及び第8の態様の温度制御装置を複合させた発明、あるいは、さら に第6及び第7の態様の温度制御装置のうちの一つ以上の態様を複合さ せた発明を構成できる。同様に、前記第5の態様の温度制御方法、ある いは、これに第6及び第7の態様の温度制御方法のうちの一つ以上の態 様を複合させたものにおいて、前記制御入力を生成するとき、前記ヒー タ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入 力を前記制御入力としてい生成することにより、第5の態様及び第8の 態様の温度制御方法を複合させた発明、あるいは、さらに第6及び第7 の態様の温度制御方法のうちの一つ以上の態様を複合させた発明を構成 できる。さらに、前記第5の態様の記録媒体、あるいは、これに第6及 び第7の態様の記録媒体のうちの一つ以上の態様を複合させたものにお いて、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記ヒータ温度 データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力 を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第5の態 様及び第8の態様の記録媒体を複合させた発明、あるいは、さらに第6 及び第7の態様の記録媒体のうちの一つ以上の態様を複合させた発明を 構成できる。

それらの態様の複合により、それらの各態様の効果が重畳されて、ヒータの温度の目標温度に対する安定性を高めることができる。ひいては、素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度により安定に制御できる。

10

15

20

25

また、前記第6の態様の温度制御装置において、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記目標温度(ヒータの温度の目標値)に応じた入力成分を含むようにすることにより、本発明の第6の態様及び第7の態様の温度制御装置を複合させた発明を構成できる。同様に、前記第6の態様の温度制御方法において、前記制御入力を生成するとき、前記第日標温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することにより、第6の態様及び第7の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、前記第6の態様の記録媒体において、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第6の態様及び第7の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

このようにすることにより、第6の態様と第7の態様の効果が重畳されて、ヒータの温度をより安定に目標温度に制御することができ、ひいては、素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度により安定に制御することができる。

さらに、第6の態様の温度制御装置、あるいは、これに第7の態様の温度制御装置を複合させたものにおいて、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分を含めることにより、第6の態様及び第8の態様の温度制御装置を複合させた発明、あるいは、第6~第8の態様の温度制御方法、あるいは、これに第7の態様の温度制御方法を複合させたものにおいて、前記制御入力を生成するとき、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することにより、第6の態様及び第8の態様の温度制御方法を複合させた発明、あ

15

20

25

るいは、第6~第8の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、第6の態様の記録媒体、あるいは、これに第7の態様の記録媒体を複合させたものにおいて、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第6の態様及び第8の態様の記録媒体を複合させた発明、あるいは、第6~第8の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

そして、それらの複合により、それらの各態様の効果が重畳されて、 10 ヒータの温度の目標温度に対する安定性を高めることができる。ひいて は素子部の温度を、ヒータの目標温度に対応する温度に安定に制御する ことができる。

さらに、前記第7の態様の温度制御装置において、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力に、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分を含めることにより、第7の態様及び第8の態様の温度制御装置を複合させた発明を構成できる。同様に、前記第7の態様の温度制御方法において、前記制御入力を生成するとき、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力としてい生成することにより、第7の態様及び第8の態様の温度制御方法を複合させた発明を構成できる。さらに、前記第7の態様の記録媒体において、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記しータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成することにより、第7の態様及び第8の態様の記録媒体を複合させた発明を構成できる。

そして、この複合により第7及び第8の態様の効果が重畳されて、ヒ

10

15

20

25

一夕の温度の目標温度に対する安定性を高めることができ、ひいては、 素子部の温度を、ヒータの目標温度に対応する温度に安定に制御するこ とができる。

なお、第5~第7の態様の全てを複合させ、もしくは、第5~第8の 態様の全てを複合させることが特に好適である。そして、第5~第7の 態様の全てを複合させた場合には、前記ヒータの温度と目標温度との偏 差に応じた入力成分は、例えばその偏差の所定時間毎の累積加算値(積 分値)に比例する成分と該偏差に比例する成分とで構成することが好ま しい。また、第5~第8の態様の全てを複合させた場合には、前記ヒー タの温度と目標温度との偏差に応じた入力成分は、例えばその偏差の所 定時間毎の累積加算値(積分値)に比例する成分により構成することが 好ましい。

10

15

20

25

入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成することが好ましい。さらに、前記制御入力の入力成分として排ガスの温度に応じた入力成分を含む第2の態様の記録媒体、あるいは第1、第3及び第4の態様の記録媒体のうちの一つ以上の態様と第2の態様の記録媒体とを複合させた発明では、前記制御入力に含まれる前記排ガスの温度に応じた入力成分は、該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値とを含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであることが好ましい。

このことは、ヒータの温度が目標温度になるように制御入力を生成する本発明の温度制御装置、温度制御方法、及び記録媒体のいずれであっても、前記第6の態様の発明、あるいは第5、第7及び第8の態様のうちの一つ以上の態様と第6の態様とを複合させた発明についても、同じである。

これによれば、前記制御入力に含まれる入力成分のうち、排ガスの温度に応じた入力成分は、排ガスの温度の現在値だけでなく、少なくとも第1所定時間後の分の未来値を含む排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分である。このため、前記第2の態様の発明もしくはこれを含む発明では、排ガスの温度の変化に対する素子部の温度の変化を最小限に留めることができる。従って、排ガスの温度の変動によらずに、素子部の温度の目標温度への制御の安定性を効果的に高めることができる。同様に、第6の態様の発明もしくはこれを含む発明では、排ガスの温度の変化に対するヒータの温度の変化を最小限に留めることができる。従って、排ガスの温度の変動によらずに、ヒータの温度の目標温度への制御の安定性を効果的に高めることができ、ひいては、素子部の温度をよ

り安定にヒータの目標温度に対応した温度に制御できる。尚、上記時系列データには、排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の未来値だけでなく、現在から第1所定時間後の時点までの間の排ガスの温度の未来値が複数含まれていてもよい。

5 上記のように排ガスの温度の未来値を考慮した予見制御のアルゴリズ ムにより制御入力を生成する場合、その生成に必用な排ガスの温度の未 来値は、例えば適宜のアルゴリズムにより推測して得るようにしてもよ いが、該排ガスの温度の変化は、一般に、さほど急激には生じない。そ こで、本発明の第2の態様もしくは第6の態様を含む温度制御装置では、 前記ヒータ制御手段は、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来 10 値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を生成 するようにしてもよい。同様に、第2の態様もしくは第6の態様を含む 温度制御方法では、前記予見制御のアルゴリズムは、前記排ガスの温度 の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であ 15 るとして前記制御入力を生成するアルゴリズムであってもよい。さらに、 第2の態様もしくは第6の態様を含む記録媒体では、前記制御入力生成 プログラムのアルゴリズムは、前記排ガスの温度の第1所定時間後まで の未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力 を前記コンピュータに生成させるように構成されていてもよい。

20 このようにすることにより、排ガスの温度の現在値を逐次把握できれば良いので、排ガスの温度の把握(排ガスの温度を表すデータの取得) を含めた排ガスセンサの温度制御のアルゴリズムの構築が容易になる。

また、前記制御入力の入力成分として素子部の目標温度に応じた入力 成分を含む第3の態様の温度制御装置、あるいは第1、第2及び第4の 態様の温度制御装置のうちの一つ以上の態様と第3の態様の温度制御装 置とを複合させた発明では、前記ヒータ制御手段が逐次生成する前記目

10

15

標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後にお ける該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入 力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御アルゴリズ ムにより前記ヒータ制御手段が生成することが好ましい。同様に、第3 の態様の温度制御方法、あるいは第1、第2及び第4の態様の温度制御 方法のうちの一つ以上の態様と第3の態様の温度制御方法とを複合させ た発明では、前記制御入力に含ませた前記目標温度に応じた入力成分は、 該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを 含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分 を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成することが好 ましい。さらに、第3の態様の記録媒体、あるいは第1、第2及び第4 の態様の記録媒体のうちの一つ以上の態様と第3の態様の記録媒体とを 複合させた発明では、前記制御入力に含まれる前記目標温度に応じた入 力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の 未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、そ の入力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制 御入力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであ ることが好ましい。

このことは、ヒータの温度が目標温度になるように制御入力を生成す 20 る本発明の温度制御装置、温度制御方法、及び記録媒体のいずれであっ ても、前記第7の態様の発明、あるいは第5、第6、第8の態様のうち の一つ以上の態様と第7の態様とを複合させた発明についても同じであ る。

これによれば、前記制御入力に含まれる入力成分のうち、目標温度に 25 応じた入力成分は、目標温度の現在値だけでなく、少なくとも第2所定 時間後の未来値を含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であ

10

15

20

£,

る。このため、前記第3の態様の発明もしくはこれを含む発明では、素子部の目標温度を変更したときに、素子部の温度がその目標温度に対してオーバーシュートを生じるのが防止される。また、素子部の温度の目標温度への収束速度も高めることができる。その結果、素子部の温度を目標温度に迅速且つ滑らかに追従させることができ、特に、内燃機関の始動直後に、素子部の温度を目標温度に向かって速やかに収束させて、安定化させることができる。従って、内燃機関の始動直後に、速やかに素子部の出力特性を所望の特性に安定化できる。また、素子部の目標温度の変更に対する素子部の温度の追従性が良くなることから、素子部の目標温度を内燃機関の運転状態等に適した値に適宜可変的に設定することもできる。

同様に、前記第7の態様の発明もしくはこれを含む発明では、ヒータの目標温度を変更したときに、ヒータの温度がその目標温度に対してオーバーシュートを生じるのが防止される。また、ヒータの温度の目標温度への収束速度も高めることができる。その結果、ヒータの温度を目標温度に迅速且つ滑らかに追従させることができ、特に、内燃機関の始動直後に、ヒータの温度を目標温度に向かって速やかに収束させて、安定化させることができるいいでは、素子部の温度をヒータの目標温度に対応した温度に速やかに収束させて安定化させることができる。従って、内燃機関の始動直後に、速やかに素子部の出力特性を所望の特性に安定化できる。また、ヒータの目標温度の変更に対するヒータの温度の追従性が良くなることから、ヒータの目標温度、ひいては素子部の所望の温度を内燃機関の運転状態等に適した値に適宜可変的に設定することもできる。

25 尚、上記目標温度の時系列データには、目標温度の現在値と第2所定時間後の未来値だけでなく、現在から第2所定時間後の時点までの間の

10

目標温度の未来値が複数含まれていてもよい。

前述した本発明の第1~第4の態様の温度制御装置では、前記ヒータ制御手段は、最適制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成することが好適である。同様に、第1~第4の態様の温度制御方法では、前記制御入力を、最適制御のアルゴリズムにより生成することが好ましい。さらに、第1~第4の態様の記録媒体では、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、最適制御のアルゴリズムであることが好ましい。

これによれば、前記第1~第4の態様では、素子部の温度の目標温度への収束性と、制御入力の変動(ヒータへの発熱用エネルギーの変動)とのバランスを採りながら、該素子部の温度及び制御入力の変動を極力小さくするように制御入力を生成することが可能となる。その結果、素子部の温度を目標温度(所望の温度)に、より安定に制御することができると同時に、ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を必要限に留めることができる。

15 尚、本発明の第1~第4の態様で最適制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成するときには、例えば素子部の温度と目標温度との偏差と、該偏差の所定時間当たりの変化量(偏差の変化速度)と、ヒータの温度の所定時間当たりの変化量(ヒータの温度の変化速度)とを制御対象の状態量として持つと共に、少なくとも前記制御入力の所定時間当たりの変化量(制御入力の変化速度)を入力量として持つ制御対象モデルをあらかじめ定めておき、この制御対象モデルに基づいて前記最適制御のアルゴリズムを構築することが好ましい。あるいは、例えば素子部の温度と目標温度との偏差と、素子部の温度の所定時間当たりの変化量(素子部の温度の変化速度)と、ヒータの温度の所定時間当たりの変化
25 量(ヒータの温度の変化速度)とを制御対象の状態量として持つと共に、少なくとも前記制御入力の所定時間当たりの変化量(制御入力の変化速度)とないの変化量(制御入力の変化速度)とを制御対象の状態量として持つと共に、少なくとも前記制御入力の所定時間当たりの変化量(制御入力の変化速

10

15

20

25

PCT/JP2003/003956

度)を入力量として持つ制御対象モデルをあらかじめ定めておき、この制御対象モデルの基づいて前記最適制御のアルゴリズムを構築するようにしてもよい。いずれの場合でも、該制御対象モデルの評価関数(これは上記の各状態量の2乗値と、前記制御入力の所定時間当たりの変化量の2乗値との重み付き加算値の積分値(累積加算値)として表される)を最小化し得る制御入力が求められることとなる。このようにすることにより、素子部の温度と目標温度との偏差を解消するだけでなく、制御対象モデルの各状態量と制御入力との変動をそれらの好適なバランスを保ちながら抑制するようにして制御入力を生成することができる。 素子部の温度の目標温度に対する安定性を高めることができる。

3 4

また、第1~第4の態様における最適制御アルゴリズムの基礎となる 制御対象モデルが、上記のように素子部の温度と目標温度との偏差と、 該偏差の所定時間当たりの変化量と、ヒータの温度の所定時間当たりの 変化量とを制御対象の状態量として持つ場合には、素子部の温度と目標 温度との偏差に応じた入力成分と、ヒータの温度に応じた入力成分とを 含む制御入力を生成できる。また、制御対象モデルが、素子部の温度と 目標温度との偏差と、素子部の温度の所定時間当たりの変化量と、ヒー 夕の温度の所定時間当たりの変化量とを制御対象の状態量として持つ場 合には、素子部の温度と目標温度との偏差に応じた入力成分と、ヒータ の温度に応じた入力成分と、素子部の温度に応じた入力成分とを含む制 御入力を生成できる。そして、例えばこれらの制御対象モデルの入力量 として、前記制御入力の所定時間当たりの変化量に加えて、排ガスの温 度の所定時間当たりの変化量や、素子部の温度の目標温度の所定時間当 たりの変化量を含ませることで、排ガスの温度に応じた入力成分や、素 子部の目標温度に応じた入力成分を含む制御入力を生成することが可能 となる。

10

15

20

25

上記と同様に、本発明の第5~第8の態様の温度制御装置にあっても、前記ヒータ制御手段は、最適制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成することが好適である。同様に、第5~第8の態様の温度制御方法にあっても、前記制御入力を、最適制御のアルゴリズムにより生成することが好ましい。さらに、第5~第8の態様の記録媒体では、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、最適制御のアルゴリズムであることが好ましい。

これによれば、ヒータの温度の目標温度への収束性と、制御入力の変動とのバランスを採りながら、該ヒータの温度及び制御入力の変動を極力小さくするように制御入力を生成することが可能となる。その結果、ヒータの温度を目標温度により安定に制御することができ、ひいては素子部の温度をヒータの目標温度に対応する温度(所望の温度)により安定に制御できる。同時に、ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を必要限に留めることができる。

尚、本発明の第5~第8の態様で最適制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成するときには、例えばヒータの温度と目標温度との偏差と、該偏差の所定時間当たりの変化量(偏差の変化速度)と、素子部の温度の所定時間当たりの変化量(素子部の温度の変化速度)とを制御対象の状態量として持つと共に、前記制御入力の所定時間当たりの変化量(制御入力の変化速度)を入力量として持つ制御対象モデルをあらかじめ定めておき、この制御対象モデルに基づいて前記最適制御のアルゴリズムを構築することが好ましい。あるいは、例えばヒータの温度と目標温度との偏差と、素子部の温度の所定時間当たりの変化量(素子部の温度の変化速度)と、ヒータの温度の所定時間当たりの変化量(ヒータの温度の変化速度)とを制御対象の状態量として持つと共に、少なくとも前記制御入力の所定時間当たりの変化量(制御入力の変化速度)を入力

10

15

20

量として持つ制御対象モデルをあらかじめ定めておき、この制御対象モデルの基づいて前記最適制御のアルゴリズムを構築するようにしてもよい。いずれの場合でも、該制御対象モデルの評価関数を最小化し得る制御入力が求められることとなる。このようにすることにより、ヒータの温度と目標温度との偏差を解消するだけでなく、該偏差や素子部の温度、制御入力の変動をそれらの好適なバランスを保ちながら抑制するようにして制御入力を生成することができるので、ヒータの温度の目標温度に対する安定性、ひいては素子部の温度の安定性を高めることができる。

また、第5~第8の態様における最適制御アルゴリズムの基礎となる 制御対象モデルが、上記のようにヒータの温度と目標温度との偏差と、 該偏差の所定時間当たりの変化量と、素子部の温度の所定時間当たりの 変化量とを制御対象の状態量として持つ場合には、ヒータの温度と目標 温度との偏差に応じた入力成分と、素子部の温度に応じた入力成分とを 含む制御入力を生成できる。また、制御対象モデルが、ヒータの温度と 目標温度との偏差と、素子部の温度の所定時間当たりの変化量と、ヒー 夕の温度の所定時間当たりの変化量とを制御対象の状態量として持つ場 合には、ヒータの温度と目標温度との偏差に応じた入力成分と、ヒータ の温度に応じた入力成分と、素子部の温度に応じた入力成分とを含む制 御入力を生成できる。そして、例えばこれらの制御対象モデルの入力量 として、前記制御入力の所定時間当たりの変化量に加えて、排ガスの温 度の所定時間当たりの変化量や、ヒータの温度の目標温度の所定時間当 たりの変化量を含ませることで、排ガスの温度に応じた入力成分や、ヒ 一夕の目標温度に応じた入力成分を含む制御入力を生成することが可能 となる。

25 また、本発明の第1~第4の態様で最適制御のアルゴリズムを用いる ものと、排ガスの温度あるいは目標温度に係わる予見制御アルゴリズム

10

15

20

とを組合わせたときには、最適予見制御のアルゴリズムにより制御入力を生成することとなる。この最適予見制御のアルゴリズムにより制御入力を生成したときには、最適制御アルゴリズムの基礎となる制御対象モデルの状態量と入力量との変動をバランスよく抑えながら、高い安定性で素子部の温度を目標温度に制御することができる。この場合における最適予見制御のアルゴリズムは、例えば第1~第4の態様に関して前記に例示した制御対象モデルの入力量として、前記制御入力の所定時間当たりの変化量に加えて、排ガスの温度の所定時間当たりの変化量、及び/又は素子部の目標温度の所定時間当たりの変化量を含めた制御対象モデルに基づいて構築することが可能である。

このことは、本発明の第5~第8の態様で最適制御のアルゴリズムを用いるものと、排ガスの温度あるいは目標温度に係わる予見制御アルゴリズムとを組合わせた場合についても同様であり、この場合の制御入力は最適予見制御のアルゴリズムにより制御入力を生成したときには、最適制御アルゴリズムの基礎となる制御対象モデルの状態量と入力量との変動をバランスよく抑えながら、高い安定性でヒータの温度を目標温度に制御することができる。この場合における最適予見制御のアルゴリズムは、例えば前記第5~第8の態様に関して前記に例示した制御対象モデルの入力量として、前記制御入力の所定時間当たりの変化量に加えて、排ガスの温度の所定時間当たりの変化量、及び/又は目標温度の所定時間当たりの変化量を含めた制御対象モデルに基づいて構築することが可能である。

以上説明した本発明の温度制御装置、温度制御方法、及び記録媒体で 25 は、いずれの態様においても、前記内燃機関の始動後、第3所定時間が 経過するまでの始動直後期間における前記目標温度(素子部又はヒータ

の目標温度)は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い 温度に設定されるように構成されていることが好ましい。

すなわち、内燃機関の始動直後に、素子部あるいはヒータの目標温度が高温であると、排ガスセンサの素子部に排気通路中の水分が付着していた場合に、該素子部の急激な加熱に伴う熱応力等により該素子部が破損してしまう虞れがある。このため、本発明では、前記始動直後期間における素子部あるいはヒータの目標温度を始動直後期間の経過後よりも低い温度に設定する。これにより、排ガスセンサの素子部が熱応力等により破損してしまうような事態を回避することができる。

10 また、以上説明した本発明の温度制御装置では、いずれの熊様であっ ても、前記ヒータが、パルス幅制御(PWM制御)によってバッテリか ら通電することにより発熱する電熱ヒータであると共に、前記ヒータ制 御手段が生成する制御入力が、前記パルス幅制御におけるデューティ (パルス幅制御で用いるパルス信号の1周期当たりのパルス幅の割合) 15 である場合には、該デューティを前記バッテリの電圧に応じて補正する 手段を備えることが好ましい。同様に、本発明の温度制御方法では、い ずれの態様であっても、前記ヒータは、パルス幅制御(PWM制御)に よってバッテリから通電することにより発熱する電熱ヒータであると共 に、前記生成する制御入力は、前記パルス幅制御におけるデューティで あり、該デューティを前記バッテリの電圧に応じて補正するステップを 20 備えることが好ましい。さらに、本発明の記録媒体では、いずれの態様 であっても、前記ヒータは、パルス幅制御(PWM制御)によってバッ テリから通電することにより発熱する電熱ヒータであると共に、前記制 御入力生成プログラムにより前記コンピュータに生成させる前記制御入 力はは、前記パルス幅制御におけるデューティであり、前記温度制御用 25 プログラムは、前記制御入力生成プログラムにより生成させた該デュー

10

ティを前記バッテリの電圧に応じて補正する処理を前記コンピュータに 実行させるプログラムをさらに含むことが好ましい。

すなわち、バッテリの電圧がほぼ一定であるような場合には、上記デューティはヒータへの発熱用エネルギーの供給量としての供給電力を規定するものとなるが、バッテリの電圧がオルタネータ等の影響で変動を生じるような場合には、ヒータへの供給電力は、上記デューティだけでなくバッテリの電圧の影響も受ける。従って、前記制御入力としてのデューティをバッテリの電圧に応じて補正することにより、素子部あるいはヒータの温度を目標温度に制御する上でのバッテリの電圧の変動の影響を補償することができる。この結果、バッテリの電圧の変動の影響を受けることなく、素子部の温度あるいはヒータの温度を目標温度に安定して制御することができる。ひいては、素子部の温度の安定性を高めることができる。

尚、本発明では、排ガスセンサとしては、例えば排ガス浄化用の触媒 装置の下流側に配置した O_2 センサが挙げられる。この場合、触媒装置 による所要の浄化性能を確保するために、 O_2 センサの出力電圧を所定 値に維持するように排ガスの空燃比を制御するような場合には、その空 燃比制御を良好に行う上で、該 O_2 センサの素子部の温度を基本的には 75.0 \mathbb{C} 以上の温度(例えば800 \mathbb{C})に制御することが好適である。 20 この場合、素子部の目標温度を決めてヒータを制御するときには、その

この場合、素子部の目標温度を決めてヒータを制御するときには、その目標温度を750 ℃以上の温度(例えば800 ℃)に設定すればよく、ヒータの目標温度を決めてヒータを制御するときには、その目標温度を例えば850 ℃以上の温度(例えば900 ℃)に設定すればよい。

さらに、内燃機関の始動直後(内燃機関の始動後、第3所定時間(例 25 えば15秒)が経過するまでの期間)では、前述したようにO₂センサ の素子部の破損を防止するために、素子部の温度を上記の温度よりも低

い温度(例えば600℃)に制御することが好適である。この場合、素子部の目標温度を決めてヒータを制御するときには、内燃機関の始動直後における素子部の目標温度を例えば600℃に設定すればよく、ヒータの目標温度を決めてヒータを制御するときには、内燃機関の始動直後におけるヒータの目標温度を例えば700℃に設定すればよい。

図面の簡単な説明

5

10

15

20

図1は本発明の第1実施形態の装置の全体構成を示すプロック図、図2は図1の装置に備えた〇2センサ(排ガスセンサ)の構造を示す断面図、図3は図2の〇2センサの出力特性を示すグラフ、図4は図1の装置に備えたセンサ温度制御手段の機能的構成を示すプロック図、図5は図4のセンサ温度制御手段に備えた排気温オブザーバの処理を説明するための断面図、図6は図5のセンサ温度制御手段に備えた排気温オブザーバの機能的構成を示すプロック図、図7は図5のセンサ温度制御手段に備えたヒータコントローラの機能的構成を示すブロック図である。図8は図1の装置に備えたセンサ温度制御手段の全体的処理を示すフローチャート、図9〜図11は図8のフローチャートのサブルーチン処理を示すフローチャート、図12及び図13は第1実施形態のシミュレーション結果を示すグラフである。図14は本発明の第2実施形態におけるセンサ温度制御手段の機能的構成を示すプロック図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の第1実施形態を図1~図13を参照して説明する。図1は、 本実施形態の装置の全体構成を模式的に示すプロック図である。同図中、 25 1は例えば自動車やハイブリッド車に搭載されるエンジン(内燃機関) であり、このエンジン1が燃料及び空気の混合気を燃焼させて生成する

10

15

20

25

排ガスは、該エンジン1の排気ポート2に連通する排気通路3を介して大気側に排出される。排気通路3には、排ガスを浄化するための触媒装置4,5が上流側から順次介装されている。排気通路3のうち、触媒装置4の上流側の部分(排気ポート2と触媒装置4の間の部分)と、両触媒装置4,5の間の部分と、触媒装置5の下流側の部分とはそれぞれ管状の通路形成物である排気管6a,6b,6cにより構成されている。

各触媒装置 4,5 はそれぞれ触媒 7 (本実施形態では三元触媒)を内蔵するものである。この触媒 7 は、ハニカム構造の通路形成物であり、その内部を排ガスが流れるようになっている。尚、触媒装置 4,5 は一体構造のもの(例えば同一のケース内に三元触媒からなる二つの触媒床を上流部と下流部とに内蔵したもの)であってもよい。

本実施形態の装置では、特に触媒装置4の良好な浄化性能(触媒装置

4によるCO、HC、NOx の浄化性能)を確保するようにエンジン1 の排ガスの空燃比を制御する。そして、この空燃比制御を行うために、触媒装置 4,5 の間の排気通路 3 (排気管 6 bにより形成される排気通路)に O_2 センサ 8 が配置され、触媒装置 4 の上流側の排気通路 3 (排気管 6 aにより形成される排気通路)に広域空燃比センサ 9 が配置されている。尚、触媒装置 4,5 が前述のように一体構造で、二つの触媒床を内蔵したものである場合には、 O_2 センサ 8 は、上流側の触媒床と下流側の触媒床との間に配置するようにすればよい。

ここで、 O_2 センサ8は、本発明における排ガスセンサに相当するものであり、その基本構造や特性等をさらに説明する。この O_2 センサ8は、図 $_2$ に模式的に示すように、酸素イオンを通しやすい固体電解質、例えば安定ジルコニア($_2$ + Y $_2$ O $_3$)を主材質とする有底筒形状の素子部 $_1$ 0(感応部)を備え、この素子部 $_1$ 0 の外面及び内面には、それぞれ、多孔質の白金電極 $_1$ 1、 $_1$ 2 がコーティングされている。また、

10

15

20

この素子部 10 の内部には、該素子部 10 の昇温・活性化や温度制御等を行うために電熱ヒータとしての棒状のセラミックヒータ 13 が挿入されると共に、セラミックヒータ 13 の周囲の空間には一定酸素濃度(一定の酸素分圧)の空気が充填されている。そして、この 02 センサ 8 は、その素子部 10 の先端部の外面が排気管 6 b内の排ガスに接触するようにセンサ筐体 14 を介して排気管 6 bに装着されている。

尚、図2中、15は、排気管6b内の素子部10に異物等が当たらないようにするための筒状のプロテクタであり、排気管6b内の素子部10は、プロテクタ15に穿設されている複数の孔(図示省略)を介して排ガスに接触するようになっている。

かかる構造の O_2 センサ 8 では、素子部 1 0 の先端部外面に接触する排ガスの酸素濃度と素子部 1 0 の内部の空気の酸素濃度との差によって、前記白金電極 1 1 1 2 間に排ガスの酸素濃度に応じた起電力が生じる。そして、該 O_2 センサ 8 は、その起電力を図示しない増幅器で増幅してなる出力電圧V out を外部に出力する。

この場合、排ガスの酸素濃度、あるいは該酸素濃度から把握される排ガスの空燃比に対するO₂ センサ8の出力電圧 Vout の特性(出力特性)は、基本的には図3に実線のグラフαで示すような特性(所謂 Zカーブ特性)となる。尚、図3の実線のグラフαは、より詳しくは、素子部10の温度が800℃であるときのO₂ センサ8の出力特性を示すグラフである。素子部10の温度とO₂ センサ8の出力特性との関係については後述する。

図3のグラフαに見られるように、 O_2 センサ8の出力特性は、一般的に、排ガスの酸素濃度により表わされる空燃比が理論空燃比近傍の狭25 い空燃比域 Δ に存する状態でのみ、出力電圧V out が排ガスの空燃比に対してほぼリニアに高感度な変化を示す。つまり、その空燃比域 Δ (以

10

15

20

25

下、高感度空燃比域 Δという)において、空燃比の変化に対する出力電圧 Vout の変化の傾き(出力特性のグラフの傾き)が大きなものとなる。そして、その高感度空燃比域 Δよりもリッチ側の空燃比域とリーン側の空燃比域とでは、排ガスの空燃比の変化に対する出力電圧 Vout の変化の傾き(出力特性のグラフの傾き)が微小なものとなる。

尚、前記広域空燃比センサ9は、ここでの詳細な説明は省略するが、例えば特開平4-369471 号公報にて本願出願人が開示した空燃比センサであり、 O_2 センサ8よりも広い空燃比域において、排ガスの空燃比に対してリニアに変化する出力電圧 KACT を発生するセンサである。以下の説明では、 O_2 センサ8の出力電圧 Vout、広域空燃比センサ9の出力電圧 KACT をそれぞれ単に出力 Vout、KACT ということがある。

本実施形態の装置は、さらに排ガスの空燃比制御や〇っセンサ8の素

子部10の温度制御等の処理を実行するコントロールユニット16を備えている。このコントロールユニット16は、図示を省略するCPU、RAM、ROMを含むマイクロコンピュータにより構成されたものであり、後述の制御処理を実行するために、前記〇2センサ8、広域空燃比センサ9からそれらの出力Vout, KACTが入力されると共に、エンジン1に備えられたセンサ(図示省略)からエンジン1の回転数 NE(回転速度)、吸気圧 PB(詳しくはエンジン1の吸気管内圧の絶対圧)、大気温度 TA、機関温度 TW(詳しくはエンジン1の冷却水温)等の検出値を示すデータが与えられる。さらに、コントロールユニット16には、エンジン1の点火装置(図示省略)やコントロールユニット16には、エンジン1の点火装置(図示省略)やコントロールユニット16、前記セラミックヒータ13等の電装品の電源としてのバッテリ(図示省略)の電圧 VB(以下、バッテリ電圧 VBという)の検出値を示すデータが図示しないセンサから与えられる。なお、コントロールユニット16に備えたROMは、本発明の記録媒体に相当するものである。

10

15

20

25

 \mathcal{L}_{i}

上記コントロールユニット16は、その処理の機能的手段として、エンジン1の排ガスの空燃比を制御する空燃比制御手段17と、O2センサ8の素子部10の温度を制御するセンサ温度制御手段18とを具備している。

空燃比制御手段17は、触媒装置4によるCO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)、NOx(窒素酸化物)の良好な浄化性能(浄化率)を確保するように、触媒装置4にエンジン1から供給される排ガスの空燃比を制御する処理を実行するものである。ここで、前述のような出力特性のO₂センサ8を触媒装置4の下流側に配置したとき、触媒装置4に供給する排ガスの空燃比(触媒装置4の上流側の排ガスの空燃比)を、O₂センサ8の出力Voutがある所定値Vop(図3参照)に整定するような空燃比状態に制御することにより、触媒装置4によるCO、HC、NOxの良好な浄化性能を該触媒装置4の劣化状態によらずに確保できる。

そこで、空燃比制御手段17は、上記所定値VopをO₂センサ8の出力Voutの目標値とし、この目標値VopにO₂センサ8の出力Voutを整定・維持するようにエンジン1から触媒装置4に供給される排ガスの空燃比を制御する。この空燃比制御は、例えば、O₂センサ8の出力Voutを目標値Vopに収束させるように、フィードバック制御処理により触媒装置4に供給する排ガスの目標空燃比を決定し、この目標空燃比に広域空燃比センサ9の出力 KACT(空燃比の検出値)を収束させるように、フィードバック制御処理によりエンジン1の燃料供給量を調整することで実行される。尚、空燃比制御手段17のより具体的な処理は、本願発明の本質をなすものではないので、ここでの詳細な説明は省略するが、例えば本願出願人が特開平11−324767号公報にて公開した明細書の段落番号[0071]~[0362]、あるいは米国特許6188953号に記載されているように行われる。

10

15

20

25

ところで、 O_2 センサ8の出力特性は、素子部10の温度の影響を受けて変化する。例えば、素子部10の温度が800℃、750℃、700℃、600℃であるときの O_2 センサ8の出力特性は、それぞれ図3の実線のグラフa、破線のグラフb、一点鎖線のグラフb、二点鎖線のグラフdで示すような特性となる。この場合、図3を参照して明らかなように、特に750℃よりも低い温度域で素子部10の温度が変化すると、理論空燃比近傍(前記高感度空燃比域 Δ)における O_2 センサ8の出力Voutの変化の傾き(感度)や、該高感度空燃比域 Δ よりもリッチ側における出力Voutのレベル等が変化しやすい。尚、素子部10の温度が750℃以上である場合には、素子部10の温度変化に対する O_2 センサ8の出力特性の変化は微小になり、該出力特性がほぼ一定になる。

 O_2 センサ8の出力特性が上記のように素子部10の温度状態によって変化するため、その温度状態によっては、前記空燃比制御手段17による制御性(安定性や速応性)が悪化する虞れがある。これは、 O_2 センサ8の出力 V out をある目標値V op に維持するように排ガスの空燃比を制御する上では、特に、理論空燃比近傍での O_2 センサ8の出力特性、すなわち、前記高感度空燃比域 Δ における出力特性が制御性に大きな影響を及ぼしやすいからである。また、触媒装置4の触媒7による排ガスの浄化性能が良好に保たれるような O_2 センサ8の出力V out の目標値V op も、特に、750 C よりも低い温度域における素子部10の温度状態によって変化する。従って、空燃比制御手段17による空燃比の制御(O_2 センサ8の出力V out を目標値V op に維持する制御)を良好に行い、また、触媒装置4の浄化性能を良好に確保するためには、 O_2 センサ8の素子部10の温度は、基本的には一定温度に維持されていることが好ましい。

この場合、O2 センサ8では、素子部10の温度を750℃以上の温

 $\phi = \phi^{-1}$

5

10

15

20

25

度に維持すると、前述のようにO2センサ8の出力特性がほぼ一定になって安定する。また、本願発明者等の知見によれば、素子部10の温度を750℃以上の温度で、例えば800℃に維持すると、触媒装置4の触媒7による排ガスの浄化性能が良好に保たれるようなO2センサ8の出力Voutの目標値Vopが、図3のグラフαにおいて参照符号Yを付した部分、すなわち、O2センサ8の出力特性のグラフαの傾きが空燃比のリッチ化に伴い大きな傾きから微小な傾きに切替る変曲点部分Yに存するようになる。そして、このとき、この目標値VopにO2センサ8の出力Voutを維持するような空燃比制御を良好に行うことができる。これは、変曲点部YにおけるO2センサ8の出力Voutの空燃比に対する感度が過大でも過小でもない適正な感度になるためと考えられる。

このため、本実施形態では、前記センサ温度制御手段18により、 O_2 センサ8の素子部10の温度を前記セラミックヒータ13を介して所望の温度に制御するようにしている。その所望の温度は、基本的には750 \mathbb{C} 以上の温度で、例えば800 \mathbb{C} である。このセンサ温度制御手段18の制御処理を以下に詳説する。

センサ温度制御手段18は、その主要な機能を分類すると、図4に示すように、排気通路3でのO2センサ8の配置箇所近傍(排気管6bの中間部分の箇所)の排ガス温度Tgdを逐次推定する排気温オブザーバ19と、その排ガス温度Tgdの推定値等を用いてO2センサ8の素子部10の温度To2及びセラミックヒータ13の温度Thtを推定する素子温オブザーバ20(温度推定手段)と、素子部10の温度の目標値R(目標温度)を設定する目標値設定手段21と、素子部10の温度To2及びセラミックヒータ13の温度Thtの推定値、目標値R、並びに排ガス温度Tgdの推定値等を用いてセラミックヒータ13の通電制御(セラミックヒータ13への供給電力の制御)を行うヒータコントロー

10

15

20

25

ラ22 (ヒータ制御手段) とを備えている。尚、排気温オブザーバ19 には、排ガス温度 T gd の推定処理を行うために、エンジン1の回転数 NE、吸気圧 PB、及び大気温度 T_A の検出データが与えられる。また、ヒータコントローラ22と、素子温オブザーバ20とには、それらの演算処理を後述するように行うために、前記バッテリ電圧 VB の検出データが与えられる。

ここで、本実施形態では、セラミックヒータ13は、図示を省略するヒータ通電回路にパルス電圧を付与することにより通電制御(PWM制御)されるものであり、該セラミックヒータ13への供給電力は、そのパルス電圧のデューティ DUT(パルス電圧の1周期に対するパルス幅の割合)を調整することによって制御できる。このため、ヒータコントローラ22は、上記ヒータ通電回路に付与するパルス電圧のデューティDUTをセラミックヒータ13を制御するための制御入力(操作量)として逐次求め、このデューティ DUTを調整することにより、該セラミックヒータ13への供給電力、ひいては、該ヒータ13の発熱量を制御するようにしている。尚、ヒータコントローラ22が生成するデューティ DUTは、素子温オブザーバ20の演算処理でも使用される。

排気温オブザーバ19は、本実施形態では、エンジン1の排気ポート2からO2センサ8の配置箇所までの排気通路3(O2センサ8の上流側の排気通路3)を該排気通路3の延在方向(排ガスの流れ方向)に沿って複数(本実施形態では例えば4個)の部分排気通路3a~3dに区分けしておき、所定のサイクルタイム(周期)で、排気ポート2(排気通路3の入り口部分)における排ガスの温度と、各部分排気通路3a~3dにおける排ガスの温度(詳しくは各部分排気通路3a~3dの下流端における排ガスの温度)とを上流側のものから順番に推定するものである。これらの部分排気通路3a~3dのうち、部分排気通路3a、3

10

15

bは、触媒装置4の上流側の排気通路3(排気管6aにより形成された排気通路)を2つに区分けしてなる部分排気通路であり、部分排気通路3 c は、触媒装置4の入り口から出口までの部分排気通路(触媒装置4の触媒7の内部に形成された排気通路)、部分排気通路3 d は、触媒装置4の出口からO2 センサ8の配置箇所までの排気管6bにより形成された部分排気通路である。この排気温オブザーバ19のアルゴリズムは次のように構築されている。

まず、エンジン1の排気ポート2における排ガス温度は、エンジン1の定常的な運転状態(詳しくはエンジン1の回転数 NE 及び吸気圧 PB が一定に維持される運転状態で)では、基本的にはエンジン1の回転数 NE と吸気圧 PB とに応じたものとなる。従って、排気ポート2における排ガス温度は、基本的にはエンジン1の運転状態を表すパラメータとしての回転数 NE 及び吸気圧 PB の検出値から例えばあらかじめ実験等に基づいて定めたマップに基づいて推定することができる。但し、エンジン1の運転状態(回転数 NE や吸気圧 PB)が変動する場合には、排ガスと排気ポート2の近傍の壁部やエンジン1の燃焼室等との熱交換によって、排気ポート2における排ガス温度は、上記のようにマップにより求められる排ガス温度(以下、基本排ガス温度 TMAP(NE、PB)という)に対して応答遅れを生じる。

20 そこで、本実施形態では、排気温オブザーバ19は、所定のサイクルタイム(演算処理周期)毎に、エンジン1の回転数 NE 及び吸気圧 PB の検出値(最新の検出値)から基本排ガス温度 TMAP(NE, PB)をマップにより求めた後に、さらに排気ポート2における排ガス温度 Texg を、次式(1)のように基本排ガス温度 TMAP(NE, PB)に対して遅れ(一次遅れ)を伴って追従する値として逐次推定する。

10

 $Texg(k) = (1 - Ktex) \cdot Texg(k-1) + Ktex \cdot TMAP(NE, PB) \cdots (1)$

ここで、式(1)中の k は、排気温オブザーバ19の演算処理周期の番数である。また、Ktex はあらかじめ実験等に基づき定められた係数(遅れ係数)であり、0 < Ktex < 1である。尚、本実施形態では、エンジン1の吸気圧 PB は、エンジン1の吸入空気量を表すパラメータとしての意味をもつものである。従って、例えば吸入空気量を直接的に検出するフローセンサが備えられている場合には、そのフローセンサの出力(吸入空気量の検出値)を吸気圧 PB の検出値の代わりに用いてもよい。また、排ガス温度 T exg の推定値の初期値 T exg(0)は、本実施形態では、後述するように、エンジン1の運転開始時(エンジン1の始動時)に大気温度センサ(図示省略)により検出された大気温度 T_A 、あるいは、機関温度センサ(図示省略)により検出された機関温度 TW(エンジン1の冷却水温)に設定される。

このようにして求められる排気ポート2の排ガス温度 Texg の推定値を用いて、各部分排気通路3a~3dにおける排ガスの温度は以下に説明するように推定される。まず、説明の便宜上、一般的に、図5に示すように、大気中でZ軸方向に延びる円管23内を流体が円管23の管壁と熱交換しながら流れる場合における熱伝達に関して説明する。ここで、流体温度Tg、管壁の温度Tw(以下、円管温度Twという)が時刻t20とZ軸方向の位置zとの関数Tg(t,z)、Tw(t,z)であるとし、円管23の管壁の熱伝導率は径方向に無限大で、且つZ軸方向には「0」であると仮定する。また、流体と円管23の管壁との間の熱伝達、並びに、円管23の管壁とその外部の大気との間の熱伝達は、ニュートンの冷却則に従ってそれぞれの温度差に比例するものとする。このとき、次式(2

WO 2004/010129

5

-1)、(2-2) か成立する。

Sg·
$$\rho$$
g·Cg· $\left(\frac{\partial Tg}{\partial t} + V \cdot \frac{\partial Tg}{\partial z}\right) = \alpha_1 \cdot U \cdot (Tw - Tg) \cdots (2-1)$
Sw· ρ w·Cw· $\frac{\partial Tw}{\partial t} = \alpha_1 \cdot U \cdot (Tg - Tw) + \alpha_2 \cdot U \cdot (TA - Tw) \cdots (2-2)$

ここで、Sg、 ρg 、Cg はそれぞれ流体の密度、比熱、流路断面積、Sw、 ρw 、Cw はそれぞれ円管 2 3 の管壁の密度、比熱、断面積、V は円管 2 3 を流れる流体の流速、 T_A は円管 2 3 の外部の大気温度である。また、Uは円管 2 3 の内周長、 α_1 は流体と円管 2 3 の管壁との間の熱伝達率、 α_2 は円管 2 3 の管壁と大気との間の熱伝達率である。尚、大気温度 T_A は、円管 2 3 の周囲で一定に維持されているとする。

これらの式(2-1)、(2-2)を整理すると、次式 (3-1)、(3 10 -2) が得られる。

$$\frac{\partial Tg}{\partial t} = -V \cdot \frac{\partial Tg}{\partial z} + a \cdot (T_W - T_g) \quad \dots (3-1)$$

$$\frac{\partial Tw}{\partial t} = b \cdot (T_g - T_w) + c \cdot (T_A - T_w) \quad \dots (3-2)$$

但し、これらの式(3-1)、(3-2)において、a, b, c は定数 であり、 $a=\alpha_1\cdot U$ / ($Sg\cdot \rho g\cdot cg$)、 $b=\alpha_1\cdot U$ / ($Sw\cdot \rho$ W・cw)、 $c=\alpha_2\cdot U$ / ($Sw\cdot \rho w\cdot cw$) である。

式(3-1)の右辺第1項は、位置zでの流体の流れ方向の温度勾配 と流体の流速とに応じた流体温度Tgの時間的変化率(単位時間当たり の温度変化量)を表す移流項である。また、式(3-1)の右辺第2項

10

15

は、位置 z での流体温度 Tg と円管温度 Tw との偏差に応じた流体温度 Tg の時間的変化率(単位時間当たりの温度変化量)、すなわち、流体 と円管 2 3 の管壁との間の熱伝達に伴う流体温度 Tg の時間的変化率を 表す熱伝達項である。従って、この式(3-1)は、位置 z での流体温度 Tg の時間的変化率 ∂ Tg ∂ t が、上記移流項の温度変化成分と、上記熱伝達項の温度変化成分とに応じたもの(それらの温度変化成分の総和)になるということを示すものである。

また、式(3-2)の右辺第1項は、位置 z での円管温度 T w と流体温度 T g との偏差に応じた円管温度 T w の時間的変化率(単位時間当たりの温度変化量)、すなわち、位置 z での流体と円管 2 3 の管壁との間の熱伝達に伴う円管温度 T w の時間的変化率を表す熱伝達項である。また、式(3-2)の右辺第 2 項は、位置 z での円管温度 T w と外部の大気温度 T A との偏差に応じた円管温度 T w の時間的変化率(単位時間当たりの温度変化量)、すなわち、位置 z での円管 2 3 の管壁から大気への放熱に応じた円管温度 T w の時間的変化率を表す放熱項である。そして、式(3-2)は、位置 z での円管温度 T w の時間的変化率 ∂ T w / ∂ t が、上記熱伝達項の温度変化成分と放熱項の温度変化成分とに応じたもの(それらの温度変化成分の総和)になるということを示すものである。

20 これらの式 (3-1)、(3-2) を差分法によって書き改めて整理すると次式 (4-1), (4-2) が得られる。

10

15

20

$$Tg(t+\Delta t, z) = Tg(t, z) - \frac{V \cdot \Delta t}{\Delta z} \cdot (Tg(t, z) - Tg(t, z-\Delta z))$$

$$+ a \cdot \Delta t \cdot (Tw(t, z) - Tg(t, z)) \qquad \cdots (4-1)$$

$$Tw(t+\Delta t, z)=Tw(t, z)+b\cdot \Delta t\cdot (Tg(t, z)-Tw(t, z))$$

$$+c\cdot \Delta t\cdot (T_A-Tw(t, z))$$

$$\cdots (4-2)$$

この場合、位置 z での流体温度 T g(t,z)は、所定時間毎に、流速 V と位置 z での温度勾配とに応じた温度変化成分(式(4-1)の第 2 項が表す温度変化成分)と、位置 z での流体温度 T g と P 管温度 T w との偏差に応じた温度変化成分(式(4-1)の第 3 項が表す温度変化成分)とを、初期値 T g(0,z)に累積加算(積分)することにより算出できる。他の位置 z+Δz、z+2Δz、…についても同様である。また、位置 z での円管温度 T w(t,z)は、所定時間毎に、位置 z での流体温度 T g と P 管温度 T w との偏差に応じた温度変化成分(式(4-2)の第 2 項が表す温度変化成分)と、位置 z での円管温度 T w と大気温度 T a と 偏差に応

10

15

20

25

じた温度変化成分(式 (4-2) の第 3 項が表す温度変化成分)を、初期値 Tw(0,z)に累積加算(積分) することにより算出できる。

そこで、本実施形態では、排気温オブザーバ19は、式(4-1)、(4-2)のモデル式を基本式として用い、各部分排気通路 $3a\sim3d$ における排ガスの温度を次のようにして求める。

まず、部分排気通路3a~3dのうち、部分排気通路3a,3bは、いずれも排気管6aを通路形成物として形成されている。そして、本実施形態では、これらの部分排気通路3a,3bにおける排ガスの温度を推定するために、前記円管23に関して説明した場合と同様に、排ガスの流速と温度勾配(排ガスの流れ方向での温度勾配)とに応じた温度変化と、排ガスと排気管6aとの間の熱伝達と、排気管6aから大気への放熱とを考慮する。

この場合、部分排気通路3aにおける排ガス温度Tgaの推定値は、部分排気通路3aにおける排気管6aの温度Twa(以下、排気管温度Twaという)の推定値と併せて、排気温オブザーバ19の処理のサイクルタイム毎に、次のモデル式(5-1)、(5-2)により求められる。また、部分排気通路3bにおける排ガスの温度Tgbの推定値は、部分排気通路3bにおける排気管温度Twbの推定値と併せて、排気温オブザーバ19の処理のサイクルタイム毎に、次のモデル式(6-1)、(6-2)により求められる。尚、式(5-1)、(5-2)により求められる排ガス温度Tga及び排気管温度Twaはより詳しくは、部分排気通路3aの下流端近傍における温度の推定値である。同様に、式(6-1)、(6-2)により求められる排ガス温度Tgb及び排気管温度Twbはより詳しくは、部分排気通路3bの下流端近傍における温度の推定値である。

10

$$Tga(k+1) = Tga(k) - Vg \cdot \frac{dt}{La} \cdot (Tga(k) - Texg(k)) + Aa \cdot dt \cdot (Twa(k) - Tga(k)) + Constant \cdot (Tga(k) - Tga(k)) + Con$$

$$Twa(k+1) = Twa(k) + Ba \cdot dt \cdot (Tga(k) - Twa(k)) + Ca \cdot dt \cdot (TA(k) - Twa$$

$$Tgb(k+1) = Tgb(k) - Vg \cdot \frac{dt}{Lb} \cdot (Tgb(k) - Tga(k)) + Ab \cdot dt \cdot (Twb(k) - Tgb(k)) + C(b) \cdot (C(b) - Tgb(k)) + C(b) \cdot$$

$$Twb(k+1) = Twb(k) + Bb \cdot dt \cdot (Tgb(k) - Twb(k)) + Cb \cdot dt \cdot (TA(k) - Twb(k))$$

$$\cdots (6-2)$$

これらの式(5-1)、(5-2)、(6-1)、(6-2) 中の dt は、排気温オブザーバ19の処理の周期(サイクルタイム)であり、前記式(4-1)、(4-2) の Δ t に相当する。この dt の値はあらかじめ定められている。また、式(5-1)、(6-1) 中のLa,Lbはそれぞれ部分排気通路3a,3bの長さ(固定値)であり、前記式(4-1) の Δ z に相当する。また、式(5-1)、(5-2) 中のAa,Ba,Ca、並びに式(6-1)、(6-2) 中のAb,Bb,Cbは、それぞれ式(4-1)、(4-2) のa,b,cに相当するモデル係数であり、それらの値はあらかじめ実験やシミュレーションに基づいて設定(同定)される。また、式(5-1)、(6-1) 中のVg は排ガスの流速を示すパラメータ(これは後述するように求められる)であり、式(4-1) のVに相当するものである。

15 ここで、式(5-1)により排ガス温度T ga の新たな推定値T ga(k+1)を算出するために必要な排ガス温度T exg(k)(排気ポート 2 に おける排ガス温度)は、基本的には前記式(1)により求められた最新値が用いられる。同様に、式(6-1)により排ガス温度T gb の新た

な推定値 T gb(k+1)を算出するために必要な排ガス温度 T ga(k)(部分排気通路 3 a における排ガス温度)は、基本的には前記式(5-1)により求められた最新値が用いられる。また、式(5-2)、(6-2)の演算に必要な大気温度 $T_A(k)$ は、図示しない大気温度センサ(これは本実施形態ではエンジン1に備えらたセンサが代用的に用いられる)により検出された大気温度 T_A の最新値が用いられる。さらに、式(5-1)、(6-1)の演算に必要な流速パラメータ V g は、本実施形態では、エンジン1の回転数 NE 及び吸気圧 PB の最新の検出値から、次式(7)により算出された値が用いられる。

$$V_g = \frac{NE}{NEBASE} \cdot \frac{PB}{PBBASE} \cdots (7)$$

10

15

20

5

この式(7)中の NEBASE、PBBASE は、それぞれあらかじめ定めた所定回転数、所定吸気圧であり、それぞれ例えばエンジン1の最大回転数、 $760 \, \text{mmHg}$ ($=101 \, \text{kPa}$) に設定されている。この式(7)により算出される流速パラメータVg は排ガスの流速に比例し、また、 $Vg \leq 1$ となる。

尚、排ガス温度Tga 及び排気管温度Twa、並びに排ガス温度Tgb 及び排気管温度Twb のそれぞれの推定値の初期値Tga(0)、Twa(0)、Tgb(0)、Twb(0)は、本実施形態では、後述するように、エンジン1の運転開始時(エンジン1の始動時)に前記大気温度センサ(図示省略)により検出された大気温度T_A、あるいは、機関温度センサ(図示省略)により検出された機関温度 TW (エンジン1の冷却水温)に設定される。

次に、部分排気通路3 c は、触媒装置4の触媒7を通路形成物として

10

形成された排気通路である。そして、この触媒7はその排ガス浄化作用 (詳しくは酸化・還元反応)によって自己発熱を伴い、その発熱量(単位時間当たりの発熱量)は概ね排ガスの流速に比例する。これは、排ガスの流速が大きい程、単位時間当たりに触媒7と反応する排ガス成分が多くなるためである。

そこで、本実施形態では、部分排気通路3cにおける排ガス温度の推定に関しては、その推定を精度よく行うために、排ガスの流速と温度勾配とに応じた温度変化と、排ガスと触媒装置4の触媒7との間の熱伝達と、該触媒7から大気への放熱とを考慮することに加えて、さらに、該触媒7の自己発熱を考慮する。

この場合、部分排気通路3cにおける排ガス温度Tgcの推定値は、部分排気通路3cを形成する触媒7の温度Twc(以下、触媒温度Twcという)の推定値と併せて、排気温オブザーバ19の処理のサイクルタイム毎に、次のモデル式(8-1)、(8-2)により求められる。尚、式(8-1)により求められる排ガス温度Tgc及び触媒温度Twcはより詳しくは、部分排気通路3aの下流端(触媒装置4の出口近傍)における温度の推定値である。

$$Tgc(k+1) = Tgc(k) - Vg \cdot \frac{dt}{Lc} \cdot (Tgc(k) - Tgb(k)) + Ac \cdot dt \cdot (Twc(k) - Tgc(k)) + C \cdot dt \cdot (Twc(k) - Tgc(k))$$

$$\cdots (8-1)$$

$$Twc(k+1) = Twc(k) + Bc \cdot dt \cdot (Tgc(k) - Twc(k))$$

$$+ Cc \cdot dt \cdot (TA(k) - Twc(k)) + Dc \cdot dt \cdot Vg$$

$$\cdots (8-2)$$

式(8-1)中のLcは部分排気通路3cの長さ(固定値)であり、

10

15

前記式(4-1)のΔ z に相当する。また、式(8-1)、(8-2)中のA c, B c, C c は、それぞれ式(4-1)、(4-2)のa, b, c に相当するモデル係数であり、それらの値はあらかじめ実験やシミュレーションに基づいて設定(同定)される。また、式(8-2)の右辺第4項は、触媒装置4の触媒7の自己発熱による触媒7の温度変化成分(排気温オブザーバ19の処理の1周期当たりの温度変化量)を示すものであり、流速パラメータVg に比例する。そして、この第4項のD c は、前記A c ~ C c と同様に、その値があらかじめ実験やシミュレーションに基づいて設定(同定)されるモデル係数である。従って、式(8-2)は、前記式(4-2)の右辺に、さらに通路形成物(ここでは触媒7)の自己発熱に伴う温度変化成分を付加したものに相当する。

尚、式(8-1)、(8-2) 中の dt、Vg の意味及びその値は、前記式(5-1)~(6-2)のものと同一である。また、式(8-2)の演算で用いる TA の値は、前記式(5-2)、(6-2)で用いるものと同一である。さらに、排ガス温度 Tgc 及び触媒温度 Twc の初期値 Tgc(0)、Twc(0)は、本実施形態では、式(5-1)~(6-2)の場合と同様、エンジン1の運転開始時における大気温度 T_A の検出値、あるいは機関温度 TW の検出値である。

次に、部分排気通路 3 d は、それを形成する通路形成物が、前記部分 20 排気通路 3 a , 3 b と同様の排気管 6 b である。従って、この部分排気 通路 3 d の排気温度 T g d 及び排気管温度 T w d (より詳しくは部分排気 通路 3 d の下流端における温度)は、前記式(5-1)~(6-2)と 同様の次のモデル式(9-1)、(9-2)により求められる。

10

9 0

$$Tgd(k+1) = Tgd(k) - Vg \cdot \frac{dt}{Ld} \cdot (Tgd(k) - Tgc(k)) + Ad \cdot dt \cdot (Twd(k) - Tgd(k))$$

$$\cdots \cdot (9-1)$$

$$Twd(k+1) = Twd(k) + Bd \cdot dt \cdot (Tgd(k) - Twd(k)) + Cd \cdot dt \cdot (TA(k) - Twd(k))$$

$$\cdots (9-2)$$

式(9-1)中のLdは部分排気通路 3 dの長さ(固定値)であり、前記式(4-1)の Δ z に相当する。また、式(9-1)、(9-2) 中のAd, Bd, Cdは、それぞれ式(4-1)、(4-2) のa, b, cに相当するモデル係数であり、それらの値はあらかじめ実験やシミュレーションに基づいて設定(同定)される。

尚、式 (9-1)、(9-2) 中の dt、Vg の意味及びその値は、前記式 (5-1) ~ (6-2) のものと同一である。また、式 (9-2) の演算で用いる TA の値は、前記式 (5-2)、(6-2)、(8-2) で用いるものと同一である。さらに、排ガス温度 Tgd 及び触媒温度 Twd の推定値の初期値 Tgd(0)、Twd(0)は、式 (5-1) ~ (6-2) の場合と同様、エンジン1の運転開始時における大気温度 T_A の検出値、あるいは機関温度 TW の検出値である。

以上説明した排気温オブザーバ19の処理によって、各サイクルタイ15 ム毎に、エンジン1の排気ポート2及び各部分排気通路3a~3dの排ガス温度Texe、Tga、Tgb、Tgc、Tgd の推定値が上流側から順番に求められる。この場合、最下流側の部分排気通路3dの排ガス温度Tgd の推定値は、O2センサ8の配置箇所近傍での排ガスの温度に相当するものとなり、該排ガス温度Tgd の推定値がO2センサ8の配置箇の近傍での排ガス温度の推定値として得られる。本実施形態では、この排ガス温度Tgd の推定値が、本発明における排ガス温度データに相当するものである。

10

15

上記排気温オブザーバ19の推定処理のアルゴリズムをプロック図で 表すと、図6に示すように表される。同図6では、前記式(1)のモデ ル式を排気ポート熱モデル24、前記式(5-1)及び(5-2)のモ デル式と、式(6-1)及び(6-2)のモデル式とをそれぞれ CAT 前排気系熱モデル25,26、式(8-1)及び(8-2)のモデル式 を CAT 部排気系熱モデル27、式(9-1)及び(9-2)のモデル 式を CAT 後排気系熱モデル28と称している。同図示のように、各熱 モデル24~28には、エンジン1の回転数 NE 及び吸気圧 PB の検出 値が与えられる。尚、排気ポート熱モデル24に与えられる NE、PB は、基本排ガス温度 TMAP を求めるためのものであり、排気系熱モデ ル 2 5 ~ 2 8 に与えられる NE、PB は、前記流速パラメータ V g の値を 求めるためのものである。さらに、排気系熱モデル25~28には、大 気温度TΑの検出値が与えられる。そして、CAT 前排気系熱モデル25、 CAT 前排気系熱モデル26、CAT 部排気系熱モデル27、CAT 後排気 系熱モデル28には、それぞれの一つ上位側の熱モデル24,25,2 6, 27の出力としての排ガス温度Texg、Tga、Tgb、Tgc の推定 値がそれぞれ与えられ、最終的に CAT 後排気系熱モデル28により、 O。センサ8の配置箇所近傍での排ガス温度Tgd の推定値(排ガス温 度データ)が得られる。

20 尚、本実施形態では、各部分排気通路3a~3dの通路形成物(排気管6a、触媒装置4の触媒7、排気管6b)の温度を推定するために、エンジン1に備えた大気温度センサの検出値を代用するようにしたが、排気通路3の外方に大気温度センサを別途配置しておき、その大気温度センサの検出値を用いるようにしてもよい。

25 次に前記素子温オブザーバ20について説明する。素子温オブザーバ20は、本実施形態では、O2センサ8の素子部10とこれに接触する

10

排ガスとの間の熱伝達、素子部10からその内部の空気への放熱、並びに、該素子部10とこれを加熱するセラミックヒータ13(以下、単にヒータ13という)との間の熱伝達を考慮して素子部10の温度Tの2を所定のサイクルタイムで逐次推定するものである。そして、この推定を行うためにヒータ13の温度Tht の推定も併せて行うようにしている。この場合、ヒータ13の温度Tht の推定処理においては、該ヒータ13と素子部10との間の熱伝達、並びにヒータ13から素子部10の内部の空気への放熱を考慮すると共に、該ヒータ13への電力供給に伴う該ヒータ13の発熱を考慮する。このような推定処理を行う素子温オブザーバ20の推定アルゴリズムは以下に説明するように構築されている。

すなわち、素子温オブザーバ20は、 O_2 センサ8の素子部10の温度 T_{02} (以下、素子温度 T_{02} という)の推定値と、ヒータ13の温度 T_{02} (以下、上一タ温度 T_{02} という)の推定値とを、それぞれ次のモジル式 (10-1)、(10-2)によりそれぞれ所定のサイクルタイムで逐次求める。式 (10-1)は、素子温モデルの式であり、式 (10-2)はヒータ温モデルの式である。

 $To₂(k+1) = To₂(k) + Ax \cdot dt \cdot (Tgd(k) - To₂(k))$

 $Tht(k+1) = Tht(k) - Cx \cdot dt \cdot (Tht(k) - To_2(k))$

$$-Fx\cdot dt\cdot (Tht(k)-TA'(k))+Dx\cdot dt\cdot DUT(k)\cdot \frac{VB(k)^2}{NVB^2}$$

$$\cdots (10-2)$$

式(10-1)は、サイクルタイム毎の素子部10の温度変化量が、

10

15

20

 O_2 センサ 8 の配置箇所近傍での排ガス温度 T_{gd} (前記部分排気通路 3 d の排ガス温度)と素子温度 T_{O2} との偏差に応じた温度変化成分(式 (10-1) の右辺第 2 項)、すなわち、素子部 10 とこれに接触する排ガスとの間の熱伝達に伴う温度変化成分と、素子温度 T_{O2} とヒータ温度 T_{O2} とヒータ温度 T_{O3} たの偏差に応じた温度変化成分(式 (10-1) の右辺第 3 項)、すなわち、素子部 10 とセラミックヒータ 13 との間の熱伝達に伴う温度変化成分と、素子温度 T_{O2} と素子部 10 の内部の空気の温度 T_{A} との偏差に応じた温度変化成分(式 (10-1) の右辺第 4 項)、すなわち、素子部 10 からその内部の空気への放熱に伴う温度変化成分とに応じたもの(それらの温度変化成分の総和)になるということを示している。

また、式(10-2)は、サイクルタイム毎のヒータ13の温度変化量が、素子温度 T_{02} とヒータ温度Tht との偏差に応じた温度変化成分(式(10-2)の右辺第2項)、すなわち、素子部10とヒータ13との間の熱伝達に伴う温度変化成分と、ヒータ温度Tht と素子部10の内部の空気の温度 T_A 、との偏差に応じた温度変化成分(式(10-2)の右辺第3項)、すなわちヒータ13から素子部10の内部の空気への放熱に伴う温度変化成分と、ヒータコントローラ22が後述するように生成するデューティ DUT(より正確には、ヒータコントローラ22がヒータ13の通電を制御するために実際に用いるデューティ DUT)とバッテリ電圧 VB の2乗値 VB2との積に応じた温度変化成分(式(10-2)の右辺第4項)、すなわちヒータ13への電力供給による該ヒータ13の発熱に伴う温度変化成分とに応じたもの(それらの温度変化成分の総和)になるということを示している。

25 尚、式(10-1)、(10-2)中のAx, Bx, Cx, Dx, Ex, Fx は、その値があらかじめ実験やシミュレーションに基づいて設定

10

15

(同定) されるモデル係数である。また、dt は素子温オブザーバ20の処理の周期(サイクルタイム)であり、本実施形態では前述の排気温オブザーバ19の処理のサイクルタイム(前記式(5-1)~(9-2)の dt)と同一の値に設定されている。また、式(10-2)中のNVBは、バッテリ電圧 VBのあらかじめ定めた基準値(例えば14V)である。該基準値は、基本的にはバッテリ電圧 VBの標準的な電圧(通常的に採り得る電圧)で任意に設定すればよい。

ここで、式(10-2)の右辺第4項に関して補足説明をしておくと、ヒータ13のPWM制御のデューティを一定とし、また、ヒータ13の通電抵抗値が一定であるとしたとき、ヒータ13の供給電力は、ヒータ13の印加電圧の2乗に比例し、該印加電圧は、バッテリ電圧 VB に比例する。また、デューティ DUT は、PWM制御用のパルス電圧の1周期当たりのヒータ13の通電時間を規定するものである。従って、このデューティ DUT とバッテリ電圧 VB の2乗値 VB² との積がヒータ13への供給電力に比例するものとなる。そして、バッテリ電圧 VB は、例えば、バッテリの充電用のオルタネータの ON/OFF 等によって変動する。そこで、式(10-2)では、ヒータ13への電力供給による該ヒータ13の発熱に伴う温度変化成分を得るために、デューティ DUT とバッテリ電圧 VB の2乗値 VB² とを乗算するようにしている。

30 尚、式(10-2)の演算に必要なデューティ DUT(k)は、ヒータコントローラ22がヒータ13の通電制御(PWM制御)を行うために実際に使用したデューティ DUT の最新値が用いられる。また、式(10-1),(10-2)の演算に必用な素子部10内の空気の温度T_A'(k)は、本実施形態では、前記大気温度センサにより検出された大気温度T
 25 Aの最新値が代用的に用いられる。従って、本実施形態ではT_A'(k)=T_A(k)である。さらに、素子温度T_{O2}及びヒータ温度Thtの推定値の

10

15

20

25

初期値 $T_{02}(0)$ 、 $T_{ht}(0)$ は、本実施形態では、後述するように、エンジン1の運転開始時における大気温度 T_A の検出値あるいは機関温度 TWの検出値である。

以上説明したアルゴリズムにより、素子温オブザーバ20は、素子温度 T_{02} 及びヒータ温度Tht の推定値を逐次算出する。尚、素子温度 T_{02} の推定値、ヒータ温度Tht の推定値は、それぞれ本発明における素子温度データ、ヒータ温度データに相当するものである。

次に前記ヒータコントローラ22について説明する。ヒータコントローラ22は、基本的には、最適予見制御アルゴリズムによりヒータ13に対する制御入力(操作量)としてのデューティ DUT を逐次生成し、そのディーティ DUT でヒータ13への供給電力を制御するものである。

この場合、本実施形態では、素子温度 T_{02} とそれに対する目標値との偏差と、その偏差の所定時間毎の変化量(これは偏差の変化速度に相当する)と、ヒータ温度T ht の所定時間毎の変化量(これはヒータ温度T ht の変化速度に相当する)とに着目し、これらをヒータコントローラ22の制御対象に係わる状態量として、該制御対象のモデル式を導入している。そして、ヒータコントローラ22のアルゴリズム(最適予見制御アルゴリズム)は以下に説明するように構築されている。尚、本実施形態では、以下に説明する最適予見制御アルゴリズムにより生成するデューティ(制御入力)は、より正確に言えば、バッテリ電圧 V B が前記式(10-2)に示した基準値 N VB に一定に維持されているとした場合に素子温度 T_{02} を目標値に制御するために要求されるデューティである。そこで、以下に説明する最適予見制御アルゴリズムにより生成するデューティを基本デューティ S DUT もしくは基本制御入力 S DUT と称する。

まず、制御対象のモデル式について説明する。素子温度To2及びヒ

 $2 = \theta$

$$\Delta \operatorname{To2(k+1)} = \Delta \operatorname{To2(k)} + \operatorname{Ax-dt} \cdot (\Delta \operatorname{Tgd(k)} - \Delta \operatorname{To2(k)})$$

$$+ \operatorname{Bx-dt} \cdot (\Delta \operatorname{Tht(k)} - \Delta \operatorname{To2(k)}) - \operatorname{Ex-dt} \cdot \Delta \operatorname{To2(k)}$$

$$= (1 - \operatorname{Ax-dt} - \operatorname{Bx-dt} - \operatorname{Ex-dt}) \cdot \Delta \operatorname{To2(k)}$$

$$+ \operatorname{Ax-dt} \cdot \Delta \operatorname{Tgd(k)} + \operatorname{Bx-dt} \cdot \Delta \operatorname{Tht(k)}$$

$$\cdots \cdot (11 - 1)$$

$$\Delta \operatorname{Tht}(k+1) = \Delta \operatorname{Tht}(k) - \operatorname{Cx} \cdot \operatorname{dt} \cdot (\Delta \operatorname{Tht}(k) - \Delta \operatorname{To2}(k))$$

$$- \operatorname{Fx} \cdot \operatorname{dt} \cdot \Delta \operatorname{Tht}(k) + \operatorname{Dx} \cdot \operatorname{dt} \cdot \Delta \operatorname{SDUT}(k)$$

$$= (1 - \operatorname{Cx} \cdot \operatorname{dt} - \operatorname{Fx} \cdot \operatorname{dt}) \cdot \Delta \operatorname{Tht}(k) + \operatorname{Cx} \cdot \operatorname{dt} \cdot \Delta \operatorname{To2}(k)$$

$$+ \operatorname{Dx} \cdot \operatorname{dt} \cdot \Delta \operatorname{SDUT}(k) \qquad \cdots \cdots (11-2)$$

10

5

尚、これらの式(1 1-2)、(1 1-2) において、 Δ T $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ 、 Δ T $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ 、 Δ T $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ 、 Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ 、 Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k+1)-T$ $_{02}(k)$ Δ $_{02}(k)=T$ $_{02}(k)$ Δ $_{02}$

次に、素子温度 T₀₂ の目標値(目標温度)を R とし、それらの間の 15 偏差 e (所定のサイクルタイム毎の偏差。以下、素子温偏差 e という) を次式(12)により定義する。

$$e(k) = To_2(k) - R(k)$$
(12)

このとき、この素子温偏差 e のサイクルタイム毎の変化量 Δ e (以下、素子温偏差変化量 Δ e という)は、前記式(1 1 - 1)、(1 2)に基づいて、次式(1 3)により与えられる。

$$\Delta e(k+1) = \Delta To_2(k+1) - \Delta R(k+1)$$

$$= (1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt) \cdot \Delta e(k) + Ax \cdot dt \cdot \Delta Tgd(k)$$

$$+ Bx \cdot dt \cdot \Delta Tht(k) - \Delta R(k+1) + (1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt) \cdot \Delta R(k)$$

$$\cdots (13)$$

5 尚、式(13)において、 Δ e(k)=e(k+1)-e(k)、 Δ R(k)=R(k+1)-R(k)である。また、この式(13)の導出過程においては、 Δ To2= Δ e(k)+ Δ R(k)という関係式(これは式(12)に基づく)が用いられている。

さらに、前記式(11-2)に、 $\Delta T_{02} = \Delta e(k) + \Delta R(k)$ という関 10 係式を適用して整理すると、次式(14)が得られる。

$$\Delta \operatorname{Tht}(k+1) = (1 - \operatorname{Cx-dt} - \operatorname{Fx-dt}) \cdot \Delta \operatorname{Tht}(k) + \operatorname{Cx-dt} \cdot \Delta \operatorname{e}(k) + \operatorname{Dx-dt} \cdot \Delta \operatorname{SDUT}(k) + \operatorname{Cx-dt} \cdot \Delta \operatorname{R}(k) \cdots (14)$$

ここで、状態量ベクトル $XO(k)=(e(k), \Delta e(k), \Delta Tht(k))^T$ を導入すると(T は転置を意味する)、前記式(14),(15)と、 e15 $(k+1)=e(k)+\Delta e(k)$ という関係式とから、次式(15)が得られる。

 $XO(k+1) = \Phi \cdot XO(k) + G \cdot \Delta SDUT(k) + Gd \cdot \Delta Tgd(k) + Gr \cdot RO(k+1)$

·····(15)

但し、 $X0(k) = (e(k), \Delta e(k), \Delta Tht(k))^T$ $R0(k+1) = (\Delta R(k+1), \Delta R(k))^T$ $G = (0, 0, Dx \cdot dt)^T$ $Gd = (0, Ax \cdot dt, 0)^T$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt & Bx \cdot dt \\ 0 & Cx \cdot dt & 1 - Cx \cdot dt - Fx \cdot dt \end{bmatrix}$$

$$Gr = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt \\ 0 & Cx \cdot dt \end{bmatrix}$$

尚、式(15)中の RO、G、Gd は、それぞれ同式(15)の但し書きで定義されたベクトルであり、 Φ 、Gr はそれぞれ同式(15)の但し書きで定義された行列である。

5 この式(15)が、ヒータコントローラ 22の制御処理に係わる制御 対象のモデルの基本式である。

ところで、上述の説明は、ヒータコントローラ22による制御処理の周期を前記排気温オブザーバ19や素子温オブザーバ20の演算処理の周期 dt と同一として行っている。このため式(15)のベクトルG, Gd並びに行列Φ, Grでは、dtが用いられている。この場合、排気温オブザーバ19や素子温オブザーバ20の演算処理は、温度推定の精度を高めるために、比較的早い周期(例えば20~50msecの周期)で行うことが望ましい。しかるに、ヒータコントローラ22の制御処理に関しては、制御入力(デューティ DUT)に対する素子温度の変化の応15 答速度が比較的遅い(周波数換算で数Hz程度)ため、該制御処理の周期は、排気温オブザーバ19や素子温オブザーバ20の演算処理の周期

PCT/JP2003/003956

dt よりも長くてよい。また、後述する本実施形態の最適予見制御では、素子温度 T₀₂ の目標値 R の未来値を一定時間分、記憶保持しておく必要があるため、ヒータコントローラ 2 2 の制御処理の周期が短いと、目標値 R に対するメモリの記憶容量が大きくなる。

5 そこで、本実施形態では、ヒータコントローラ22の制御処理の周期 (サイクルタイム)は、排気温オブザーバ19や素子温オブザーバ20 の演算処理の周期 dt よりも長い値 dtc (例えば300~500 msec) に設定している。

このため、本実施形態では、ヒータコントローラ22の制御対象のモ 10 デル式は、ヒータコントローラ22の制御処理の周期 dtc を用いて、 前記式(15)から次式(16)に書き改められる。

$$X0(n+1) = \Phi \cdot X0(n) + G \cdot \Delta SDUT(n) + Gd \cdot \Delta Tgd(n) + Gr \cdot R0(n+1)$$
.....(16)

但し、 $XO(n) = (e(n), \Delta e(n), \Delta Tht(n))^T$ $RO(n+1) = (\Delta R(n+1), \Delta R(n))^T$ $G = (0, 0, Dx \cdot dtc)^T$ $Gd = (0, Ax \cdot dtc, 0)^T$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 - Ax \cdot dtc - Bx \cdot dtc - Ex \cdot dtc & Bx \cdot dtc \\ 0 & Cx \cdot dtc & 1 - Cx \cdot dtc - Fx \cdot dtc \end{bmatrix}$$

$$Gr = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 - Ax \cdot dtc - Bx \cdot dtc - Ex \cdot dtc \\ 0 & Cx \cdot dtc \end{bmatrix}$$

この式 (16) がヒータコントローラ 22の制御処理のアルゴリズムで実際に用いる制御対象のモデル式である。ここで、この式 (16) 中 15 の n はヒータコントローラ 22の制御処理の周期 dtc の番数を示すも

 \mathcal{L}_{C}

のである。

このモデル式を用いてヒータコントローラ 2 2 の制御処理のアルゴリズム(最適予見制御のアルゴリズム)は次のように構築されている。前記式(16)のモデル式に対して、素子温度T₀₂の目標値RがMrステップ後(ヒータコントローラ 2 2 の制御処理の周期 dtc のMr 倍の時間後)の未来まで設定されており、また、外乱入力となる排ガス温度Tgd がMd ステップ後(ヒータコントローラ 2 2 の制御処理の周期 dtc のMd 倍の時間後)の未来まで判っているとする。尚、以下の説明では、Mr を目標値予見時間、Md を排ガス温度予見時間と称する。これらの予見時間Mr, Md は、ヒータコントローラ 2 2 の制御処理の1 周期 dtc を単位として表した整数値である。

このとき、次式(17)の評価関数 J0 の値を最小化するような制御入力 Δ SDUT(モデル式(16)における制御入力)を生成するコントローラが最適予見サーボコントローラとなる。

$$J0 = \sum_{n=-M+1}^{\infty} [X0^{T}(n) \cdot Q0 \cdot X0(n) + \Delta SDUT^{T}(n) \cdot H0 \cdot \Delta SDUT(n)] \cdot \cdots \cdot (17)$$

15

20

5

10

ここで、式(17)におけるMは、目標値予見時間Mr、排ガス温度 予見時間Md のうちのいずれか大きい方の値、すなわち、 $M=\max$ (Mr, Md)である。また、Q0, H0 は、それぞれ状態量ベクトルX0 の収束性、制御入力 Δ SDUT のパワー(大きさ)を調整するための重み行列である。この場合、X0 は 3 次のベクトルであるので、Q0 は 3 行 3 列の対角行列である。また、 Δ SDUT はスカラーであるので、H0 もスカラーである。尚、本実施形態では、ヒータ1 3 による電力消費を少なくするために、Q0 は例えば単位行列(全ての対角成分が「1」である

10

15

対角行列)に設定する一方、H0 は行列Q0 の対角成分に比して大きな値(例えば1000)に設定されている。また、前記目標値予見時間M r 及び排ガス温度予見時間M に関しては、本実施形態では、ヒータコントローラ 20 の制御処理の周期を $300\sim500$ msec として、M r は、例えば20 に設定され、M d は例えば10 に設定されている。

前記式(17)の評価関数の値を最小化する制御入力 Δ SDUT は、次式(18)によって与えられる。この場合、本実施形態では、排ガス温度 T gd に関しては、その T gd が M d ステップ後の未来まで現在値に維持されるとする。

$$\Delta \, SDUT(n) = F0 \cdot X0(n) + \sum_{i=1}^{Mr} \left[Fr0(i) \cdot R0(n+i) \right] + Fdt \cdot \Delta \, Tgd(n) \quad \cdots \cdots (18)$$

この式(18)の右辺第1項のFO は3次の行ベクトル(FsO, FeO, FxO)、右辺第2項(Σ の項)のFrO(i)(i=1, 2, …, Mr)はそれぞれ2次の行ベクトル(FrO1(i), FrO2(i))、右辺第3項のFdtはスカラーであり、それぞれ、次式(19-1)~(19-3)により与えられる。

F0=(Fs0, Fe0, Fx0)
=-[H0+G^T·P·G]⁻¹·G^T·P·Φ(19-1)
Fr0(i)=(Fr01(i), Fr02(i)) (但し、i=1, 2, ..., Mr)
=-[H0+G^T·P·G]⁻¹·G^T·(
$$\zeta^{T}$$
)ⁱ⁻¹·P·Gr(19-2)
Fdt= $\sum_{i=0}^{Md}$ {-[H0+G^T·P·G]⁻¹·G^T·(ζ^{T})ⁱ·P·Gd}(19-3)

これらの式 (19-1) ~ (19-3) 中のPは次式 (20-1) の

 $\theta = \theta$

リカッチの方程式を満たす行列(この場合3行3列の行列)であり、 なは次式(20-2)により与えられる行列(この場合3行3列の行列)である。

$$P = Q0 + \Phi^{\mathsf{T}} \cdot P \cdot \Phi$$

$$-\Phi \cdot P \cdot G \cdot [H0 + G^{\mathsf{T}} \cdot P \cdot G]^{-1} \cdot G^{\mathsf{T}} \cdot P \cdot \Phi \cdot \cdots (20 - 1)$$

$$\zeta = \Phi + G \cdot F0 \cdot \cdots (20 - 2)$$

5 尚、式(19-1)~(19-3)並びに式(20-1)、(20-2)中のG, Gr, Gd, Φは前記式(16)の但し書きで定義されたものである。また、HO, QOは前記式(17)の評価関数JOの重み行列(但し、この場合HOはスカラー)である。

ここで、前記式(18)の右辺第2項(Σ の項)をFrO、RO の成分 10 (前記式(19-2)並びに式(16)の但し書きを参照)を用いて書き直し、それをさらに整理すると、次式(21)が得られる。

$$\sum_{i=1}^{Mr} \left[Fr0(i) \cdot R0(n+i) \right] = \sum_{i=0}^{Mr} \left[Fr(i) \cdot \Delta R(n+i) \right] \cdot \cdots \cdot (21)$$

但し、
$$Fr(i) = \begin{cases} Fr02(1) & :i=0 \\ Fr01(i) + Fr02(i+1) : i=1, 2, \cdots, Mr-1 \\ Fr01(Mr) & :i=Mr \end{cases}$$

この式(21)を式(18)に代入すると共に、式(18)の右辺第 15 1項をFO、XOの成分(前記式(19-1)並びに式(16)の但し 書きを参照)を用いて書き直すことにより、前記式(18)は、次式 (22)により表される。

$$\Delta SDUT(n) = Fs0 \cdot e(n) + Fe0 \cdot \Delta e(n) + Fx0 \cdot \Delta Tht(n)$$

$$+ \sum_{i=0}^{Mr} [Fr(i) \cdot \Delta R(n+i)] + Fdt \cdot \Delta Tgd(n) \cdots (22)$$

このとき、ヒータコントローラ 2 2 が生成すべき基本制御入力 SDUT(n)は、その初期値 SDUT(0)に Δ SDUT(1)、 Δ SDUT(2)、 … …、 Δ SDUT(n)を累積加算したものであるから、上記式(2 2)により、次式(2 3)が得られる。

$$SDUT(n) = Fs0 \cdot \sum_{j=1}^{n} e(j) + Fe0 \cdot e(n) + Fx0 \cdot Tht(n)$$

$$+ \sum_{i=0}^{Mr} [Fr(i) \cdot R(n+i)] + Fdt \cdot Tgd(n)$$

$$- Fe0 \cdot e(0) - Fx0 \cdot Tht(0)$$

$$- \sum_{i=0}^{Mr} [Fr(i) \cdot R(0+i)] - Fdt \cdot Tgd(0) + SDUT(0)$$

$$- \cdots (23)$$

そして、この式(23)の初期値項、すなわち、式(23)の第6項(FeO・e(O)の項)~第10項(SDUT(O)の項)を全て「0」とする10 ことで、ヒータコントローラ22に実際に生成させる基本制御入力SDUT(n)を算出するための式が次式(24)の通り得られる。

$$SDUT(n) = Fs0 \cdot \sum_{j=1}^{n} e(j) + Fe0 \cdot e(n) + Fx0 \cdot Tht(n)$$
$$+ \sum_{i=0}^{Mr} [Fr(i) \cdot R(n+i)] + Fdt \cdot Tgd(n) \quad \cdots (24)$$

この式(24)が、ヒータコントローラ22によりヒータ13を制御 15 するための基本制御入力 SDUT(n)(基本デューティ)を最適予見制御

10

のアルゴリズムにより逐次算出するための演算式である。この式(24)の第1項から第3項まで(Σ e(j)を含む項~Tht(n)を含む項まで)は、素子温偏差eやヒータ温度Tht に応じた制御入力成分(フィードバック成分。以下、この成分を最適F/B成分Uopfb と称する)である。より詳しくは、第1項及び第2項は、素子温偏差eに応じた制御入力成分であり、第3項は、ヒータ温度Tht に応じた制御入力成分である。また、式(24)の右辺第4項(Σ Fr(i)・R(n+i)の項)は目標値Rに応じた制御入力成分(フィードフォワード成分。以下、この成分を最適目標値F/F成分Uopfr と称する)であり、第5項(Tgd(n)を含む項)は排ガス温度Tgd(Σ Cれは制御対象に対して外乱として機能する)に応じた制御入力成分(フィードフォワード成分。以下、この成分を最適外乱 Σ F/F成分 Σ Fのf付を称する)である。

ここで、式(24)により求められる基本制御入力 SDUT(n)(基本デューティ)は、前述したように、バッテリ電圧 VB が基準値 SVB に 15 一定に維持されている場合に、素子温度 To2 を目標値 R に制御するために要求される制御入力(デューティ)である。このため、ヒータコントローラ 2 2 は、その制御処理のサイクルタイム(周期)毎に式(24)により算出した基本制御入力 SDUT(n)を、さらに、次式(25)に示す如く、バッテリ電圧 VB の現在値 VB(n)の 2 乗値と、前記基準値 NVB の 2 乗値との比 NVB²/VB(n)² によって補正することにより、バッテリ電圧 VB によらずに素子温度 To2 を目標値 R に制御し得る制御入力 DUT(n)を逐次算出する。

$$DUT(n) = \frac{NVB^{2}}{VB(n)^{2}} \cdot SDUT(n) \qquad \cdots (25)$$

10

15

20

そして、ヒータコントローラ 2 2 は、その制御入力 DUT(n)、すなわちデューティ DUT(n)を所定の範囲内(0 % \leq DUT(n) \leq 1 0 0 %)に制限した上で、そのデューティ DUT(n)のパルス電圧を図示しないヒータ通電回路に付与することにより、ヒータ 1 3 への供給電力を調整する。

上述のように式(24)及び式(25)により制御入力としてのデューティ DUT を求めるヒータコントローラ22は、それをブロック線図で表現すると、図7に示すようになる。

尚、本実施形態では、Md ステップ後の未来まで排ガス温度Tgd が現在値に維持されるとしたため、式 (24)の右辺第5項のFdt がスカラーとなるが、未来の各ステップでのTgd を検出もしくは推定可能な場合には、それらのTgd を使用して制御入力 DUT を求めるようにすることもできる。この場合には、Fdt は式 (19-3)の{ }内の要素(Md+1個の要素)からなるベクトルとなる。より具体的には、現在からMd ステップ後までの排ガス温度Tgd の時系列データをTgd(n),Tgd(n+1),…,Tgd(n+Md)とおいたとき、式 (24)の右辺第5項は、式 (19-3)の{ }内の要素(Md+1個の要素)からなるベクトルと、排ガス温度Tgd の時系列データTgd(n),Tgd(n+1),…,Tgd(n+Md)を要素とするベクトルとの内積(スカラー積)で表される。そして、この内積は、Tgd(n)=Tgd(n+1)=…=Tgd(n+Md)としたときに、式 (24)の右辺第5項に一致するものとなる。

また、前記式(24)により基本制御入力 SDUT(n)を求めるために必要なFs0、Fe0、Fx0 は、前記式(19-1)に従ってあらかじめ 算出された値が用いられる。また、Fr(i)(i=0, 1, …, Mr)は、

10

15

20

25

前記式(21)及び式(19-2)に従ってあらかじめ算出された値が 用いられる。また、Fdt は前記式(19-3)に従ってあらかじめ算 出された値が用いられる。尚、これらの係数FsO、FeO、FxO、Fr(i)、 Fdt の値は必ずしも定義式通りの値を用いる必要ななく、シミュレー ションや実験を通じて適宜調整するようにしてもよい。さらには、素子 温度やヒータ温度等に応じて変更するようにしてもよい。

また、式(24)の演算に必要なヒータ温度Tht 及び排ガス温度Tgd は、それぞれ、前記素子温オブザーバ20により求められたヒータ温度Tht の推定値の最新値、前記排気温オブザーバ21により求められた排ガス温度Tgd の推定値の最新値が用いられる。

さらに、式(24)の演算に必要な素子温偏差 e は、前記素子温オブザーバ20により求められた素子温度 T₀₂の推定値の最新値と、前記目標値設定手段21により前記目標値予見時間 Mr 前のサイクルタイムで設定された目標値 R とから算出される。

10

15

r 前のサイクルタイムで目標値設定手段 2 1 が上記のように設定して記憶保持した値 R(n)である。また、上記のように記憶保持された目標値 R(n), R(n+1), …, R(n+Mr)が、前記式(2 4)の第 4 項(R(n+i)を含む Σ の項)の値を求めるために使用される。

次に、本実施形態の装置、特に前記センサ温度制御手段18の全体的 な処理を説明する。

まず、エンジン1の運転開始時(始動時)において、センサ温度制御 20 手段18は、前記排ガス温度Texg, Tga, Tgb, Tgc, Tgd、排気 管温度Twa, Twb, Twd、触媒温度Twc、素子温度To2、及びヒータ 温度Tht のそれぞれの推定値の初期値Texg(0), Tga(0), Tgb(0), Tgc(0), Tgd(0), Twd(0), Twd(0), To2(0), Tht(0)を 次のように設定する。すなわち、本実施形態では、エンジン1の運転停 25 止中にその停止時間を計時するようにしており、センサ温度制御手段18は、エンジン1の始動時にその直前の停止時間が所定時間(例えば2

10

2 6

時間)を超えているか否かを判断する。そして、停止時間>所定時間であるときには、排気通路 3 の内部やその管壁の温度がほぼ大気温度と同等になっていると考えられるので、センサ温度制御手段 18 は、上記初期値 T exg(0), T ga(0), T gb(0), T gc(0), T gd(0), T wa(0), T wb(0), T wd(0), T o2(0), T ht(0)を、エンジン 1 の始動時における大気温度 T_A の検出値に設定する。また、停止時間 \leq 所定時間である場合には、排気通路 3 の内部やその管壁の温度は、前回のエンジン 1 の運転停止後の余熱によって、大気温度よりもエンジン 1 の機関温度 T W(冷却水温)に近い温度になっていると考えられるので、センサ温度制御手段 18 は、上記初期値 1 exg(0), 1 Tgb(0), 1 Tgc(0), 1 Tgd(0), 1 Twa(0), 1 Twb(0), 1 Twd(0), 1 Tvd(0), 1 Tvd(0) 1 Tvd(0), 1 Tvd(0) 1 Tvd(0), 1 Tvd(0) 1 Tvd(0), 1 Tvd(0) 1 Tvd

そして、エンジン1が始動され、その運転が開始すると、センサ温度 15 制御手段18は、図8のフローチャートに示すメインルーチン処理を所 定のサイクルタイムで実行する。尚、このメインルーチンの実行周期は、 前記排気温オブザーバ19、素子温オブザーバ20の処理の周期 dt よ りも短く、従って、目標値設定手段21及びヒータコントローラ22の 処理の周期 dtcよりも短い。

20 センサ温度制御手段18は、まず、エンジン1の回転数 NE、吸気圧 PB、大気温度TA、及びバッテリ電圧 VB の検出値を取得し(STEP 1)、さらに前記目標値設定手段21及びヒータコントローラ22の処理の1周期分の時間 dtc をカウントするためのカウントダウンタイマ COPC の値を判断する(STEP2)。このカウントダウンタイマ COPC の値は、エンジン1の始動時に「0」に初期化されている。

そして、センサ温度制御手段18は、COPC=0である場合には、目

10

15

20

25

標値設定手段 2 1 及びヒータコントローラ 2 2 の制御処理の周期 dtc に相当するタイマ設定時間 TM1 を COPC の値として新たに設定した後 (STEP3)、 O_2 センサ 8 の素子温度 T_{O_2} の目標値 R を設定する処理と、ヒータ 1 3 のデューティ DUT を算出処理とを、それぞれ前記目標値設定手段 2 1 及びヒータコントローラ 2 2 により順次実行する(STEP4,5)。また、STEP2で COPC \neq 0 である場合には、センサ温度制御手段 1 8 は、STEP5で COPC の値をカウントダウンし、STEP4,5 の処理を省略する。従って、STEP4,5 の処理は、上記タイマ設定時間 TM1 により規定される周期 dtc で実行されることとなる。

上記STEP4,5の処理は、より具体的には次のように行われる。 まず、目標値設定手段21によるSTEP4の処理は、図9のフローチャートに示すように実行される。

また、STEP4-1で TSH>XTM である場合には、目標値設定手段21は、大気温度 T_A の現在の検出値(図8のSTPE1で取得されたもの)から、あらかじめ定められたデータテーブルに基づいて素子温度 T_{02} の目標値Rを設定する(STEP4-3)。ここで設定される目

10

標値Rは、大気温度 T_A が常温程度(例えば $T_A \ge 0$ $\mathbb C$)である場合には、基本的には750 $\mathbb C$ 以上の所定値(本実施形態では800 $\mathbb C$)である。但し、寒冷地でのエンジン1 の運転時等、大気温度 T_A が低いとき(例えば $T_A < 0$ $\mathbb C$)には、素子温度 T_{02} の目標値Rが800 $\mathbb C$ のような高温であると、ヒータ13 の温度が過剰に高温になりやすい。そして、本実施形態では、後述するヒータ13 の過熱防止処理によって、ヒータ13 の温度が過剰に高温になると、該ヒータ13 の故障を避けるために該ヒータ13 への通電は強制的に中止される。そこで、本実施形態では、STEP4-3では、大気温度 T_A が低い場合(例えば $T_A < 0$ $\mathbb C$)には、素子温度 T_{02} の目標値Rを通常の場合よりも多少低い値(例えば750 $\mathbb C$ \le $\mathbb R$ < 800 $\mathbb C$ となる値)に設定するようにしている。

尚、このSTEP4-3で設定される目標値 R は、STEP4-2で設定される目標値 R と同様、より詳しくは、現在から目標値予見時間 M r 後の目標値 R (n+Mr)である。

- 上記のようにSTEP4-2又は4-3で目標値R (=R(n+Mr)) を新たに設定した後、目標値設定手段21は、該目標値Rを目標値予見 時間Mr の期間分、記憶保持するためのMr+1個のバッファ RBF(0), RBF(1), ……, RBF(Mr)の値をSTEP4-4、4-5で更新する。 これにより、STEP4の処理が終了する。
- この場合、STEP4-4では、Mr個のバッファ RBF(j) (j=0, 1, …, Mr-1) に対して順番に、RBF(j)の値を RBF(j+1)の現在値に 更新する処理が実行される。尚、バッファ RBF(0)に今まで保持されて いた値は消去される。また、STEP4-5では、前記STEP4-2 又は4-3で新たに設定された目標値Rに、バッファ RBF(Mr)の値が 更新される。このように更新されるバッファ RBF(0), RBF(1), ……, RBF(Mr)の値は、それぞれ、前記式(24)の第4項のR(n), R(n+1),

… …, R (n+Mr)に相当するものとなる。尚、バッファ RBF(0),RBF(1), … …, RBF(Mr)の値は、エンジン1の始動時に所定の値(例えばSTEP4-2で設定する目標値)に初期化されている。

次に、ヒータコントローラ 2 2 による前記 S T E P 5 の処理は、図 1 0 のフローチャートに示すように実行される。この S T E P 5 の処理では、まず、前記素子温度 T_{02} の推定値の現在値 $T_{02}(n)$ と、前記バッファ RBF(0) (= R(n))、すなわち、目標値予見時間 Mr 前に目標値設定手段 2 1 により設定された目標値 R とからそれらの間の素子温偏差 e (n)= $T_{02}(n)$ - RBF(0)を算出する(S T E P 5 - 1)。

- 10 次いで、ヒータコントローラ 2 2 は、フラグ F/A, F/B の値を判断する (STEP5-2)。ここで、フラグ F/Aはデューティ DUT の後述するリミット処理において値が "0"、"1"に設定されるフラグであり、F/A=1は、デューティ DUT があらかじめ定めた所定の上限値あるいは下限値に強制的に制限されている状態を意味し、F/A=0はこのようなデューティ DUT の値の制限がなされていない状態(上限値>DUT>下限値)を意味する。また、フラグ F/B は、後述するヒータ13の過熱防止処理によりヒータ13への通電が強制的に遮断されている状態で "1"に設定されるフラグである。尚、フラグ F/A, F/B の値の初期値は、"0"である。
- 20 STEP5-2の判断で、F/A=F/B=0である場合には、ヒータコントローラ22は、前記式(24)の第1項のΣe(j)の現在値にSTEP5-1で新たに算出した偏差e(n)を加算する(STEP5-3)。これにより、偏差e(n)がヒータコントローラ22の処理のサイクルタイム dtc 毎に累積加算(積分)したものが求められる。尚、Σe(j)の25 初期値は"0"である。

また、STEP 5-2 の判断で、F/A=1 又は F/B=1 である場合に

10

15

20

25

 \mathcal{L}_{i}

は、デューティ DUT の現在値が通常的な正常値でないので、ヒータコントローラ 2 2 は、STEP 5 -4 の処理を省略して次のSTEP 5 -4 に進み、 Σ e (j)の値を現在値に保持する。

次いで、ヒータコントローラ22は、STEP5-1で求めた素子温 偏差 e (n)の現在値(最新値)やその累積加算値 Σ e (j)の現在値等を用 いて、前記式(24)及び式(25)の演算を行って、ヒータ13に対 する制御入力である DUT の今回値 DUT(n)を算出する(STEP5-4)。すなわち、STEP5-1で求めた偏差 e (n)の現在値と、その累 積加算値Σe(j)の現在値と、ヒータ温度Tht の推定値の現在値Tht(n) と、前記バッファ RBF(0), RBF(1), ……, RBF(Mr)の現在値(= R (n), R(n+1), ……, R(n+Mr)) と、排ガス温度Tgd(Oっセンサ8の 配置箇所での排ガス温度)の推定値の現在値Tgd(n)と、あらかじめ定 められた係数 F s O, F e O, F x O, F r (i) (i = 0, 1, ……, Mr), F dt の値とから、前記式(24)により、基本デューティ SDUT(n)を算 出する。さらに、この基本デューティ SDUT(n)を、バッテリ電圧 VB の現在値(図8のSTEP1で取得した最新値)を用いて、式(25) により補正することによりデューティ DUT(n)を算出する。尚、エンジ ン1の始動後、最初にSTEP5-4の処理を行う際(前記排気温オブ ザーバ19及び素子温オブザーバ20の処理が未だ実行されていない段 階)に必用となるヒータ温度Tht の推定値の初期値Tht(0)と排ガス温 度Tgd の推定値の初期値Tgd(0)とは、前述の通り、エンジン1の運転 開始時(始動時)の大気温度TAあるいは機関温度 TW に設定されてい る。そして、それらの初期値 Tht(0), Tgd(0)が式(24)の演算に用 いられる。また、両オブザーバ19,20の処理が実行された後には、 それらのオブザーバ19,20がそれぞれの処理で求めた推定値の最新 値が式(24)の演算に用いられる。

10

15

次いで、ヒータコントローラ 2 2 は、STEP 5 -4で算出したデューティ DUT(n)のリミット処理をSTEP 5 -5 ~ 5 -1 1 で実行する。すなわち、デューティ DUT(n)が所定の下限値(例えば 0 %)よりも小さいか否かを判断し(STEP 5 -5)、DUT(n)<下限値である場合には、DUT(n)の値を強制的にその"下限値"に設定し直す(STEP 5 -6)。そして、このとき、前記フラグ F/A(STEP 5 -2で使用するフラグ)の値を"1"に設定する(STEP 5 -7)。

また、DUT(n) \geq 下限値である場合には、さらに、デューティ DUT(n) が所定の上限値(例えば100%)よりも大きいか否かを判断する(STEP5-8)。このとき DUT(n) > 上限値である場合には、DUT(n)の値を強制的にその"上限値"に設定し直す(STEP5-9)。また、このとき、前記フラグ F/Aの値を"1"に設定する(STEP5-10)。尚、下限値 \leq DUT(n) \leq 上限値である場合には、DUT(n)の値は維持され、前記フラグ F/Aの値は"0"に設定される(STEP5-11)。以上によりヒータコントローラ 2 2 によるSTEP5の処理は終了する。

図8のメインルーチンの処理に戻って、センサ温度制御手段18は、次に、STEP7~13に示す処理を実行する。この処理は、ヒータ13の過熱防止のための処理であり、まず、STEP7において、ヒータ20温度Thtの推定値の現在値(最新値)があらかじめ定められた所定の上限値 THTLMT (例えば930℃)以上であるか否かが判断される。この場合、本実施形態では、基本的には、Tht≥THTLMTとなった場合に、ヒータ13の損傷等を防止するために、該ヒータ13への通電を強制的に遮断する。但し、外乱等の影響で、Thtの推定値の値が一時25的に上記上限値 THTLMT以上に上昇することも考えられる。そこで、本実施形態では、Tht≥THTLMTとなる状態が所定時間(例えば3秒。

20

25

以下、ヒータ OFF 遅延時間という)以上、継続した場合に、ヒータ13の通電を遮断することとする。

このため、前記STEP7で、ThtてHTLMT である場合には、センサ温度制御手段18は、上記ヒータ OFF 遅延時間を計時するためのカウントダウンタイマ TMHTOFF の値を上記ヒータ OFF 遅延時間に相当する所定値 TM2 に設定しておく (STEP8)。そして、この場合には、ヒータ13の通電は遮断しないので、センサ温度制御手段18は、前述したフラグ F/B (図10のSTEP5-2で使用するフラグ)の値を"0"に設定する (STEP9)。

一方、STEP 7でTht≥THTLMT である場合には、センサ温度制御手段18は、カウントダウンタイマ TMHTOFF の値を"1"だけカウントダウンした後 (STEP10)、さらに、このカウントダウンタイマ TMHTOFF の値が"0"になったか否か、すなわち、Tht≥ THTLMT の状態のまま、前記ヒータ OFF 遅延時間 TM2 が経過したか15 否かを判断する (STEP11)。

このとき $TMHTOFF \neq 0$ である場合には、前記STEP9でフラグF/B の値を"0"に設定する。また、TMHTOFF = 0 である場合には、デューティ DUT のの現在値を強制的に"0"に設定し直し(STEP12)、さらに、フラグF/B の値を"1"に設定する(STEP13)。

尚、STEP9でフラグ F/B の値が"0"に設定された場合には、センサ温度制御手段18は、デューティ DUT の現在値(前記STEP5の処理で算出された最新値)に従ってパルス電圧を図示しないヒータ通電回路に付与し、該デューティ DUT に応じた電力で該ヒータ13に通電させる。また、STEP18でフラグ F/B の値が"1"に設定された場合には、センサ温度制御手段18は、ヒータ13の通電回路にパルス電圧を付与せず、これにより、該ヒータ13への通電を遮断する。

10

15

上述のようにしてSTEP7~STEP13に係わる処理(ヒータ13の過熱防止処理)を実行した後、センサ温度制御手段18は、次に、前記排気温オブザーバ19及び素子温オブザーバ20の処理の1周期分の時間 dt をカウントするためのカウントダウンタイマ COBS の値を判断する(STEP14)。このカウントダウンタイマ COBS の値は、エンジン1の始動時に「0」に初期化されている。

そして、センサ温度制御手段 1.8 は、COBS=0 である場合には、排気温オブザーバ 1.9 及び素子温オブザーバ 2.0 の処理の周期 dt に相当するタイマ設定時間 TM3 (これはSTEP3の TM1 よりも短い)をCOBS の値として新たに設定した後 (STEP15)、排ガス温度 Tgd (O_2 センサ 8 の配置箇所近傍の排ガス温度)を推定する処理と、素子温度 T_{O2} を推定する処理(ヒータ温度 T ht の推定処理を含む)とをそれぞれ、排気温オブザーバ 1.9 及び素子温オブザーバ 2.0 により実行する (STEP16)。また、STEP14で $COBS\neq0$ である場合には、センサ温度制御手段 1.8 は、STEP17で COBC の値をカウントダウンし、STEP15, 1.6 の処理を省略する。従って、STEP16 の処理は、上記タイマ設定時間 TM3 により規定される周期 dt で実行されることとなる。以上説明した処理が図 8.0 メインルーチンの処理である。

上記STEP16の処理は、より具体的には、図11のフローチャートに示すように行われる。すなわち、センサ温度制御手段18は、まず、排気温オブザーバ19により、STEP16-1~STEP16-6の処理を順次実行し、O2センサ8の配置箇所近傍での排ガス温度Tgdの推定値を求める。STEP16-1では、エンジン1の回転数 NE及び吸気圧 PB の現在の検出値(前記STEP1で取得された最新値)を用いて前記式(7)により流速パラメータVgが求められる。尚、この

10

15

流速パラメータVg の値は、エンジン1 の過回転等により前記式(7)の算出結果が"1"を越えたような場合には、強制的にVg=1 に設定される。

次いで、排気温オブザーバ19は、前記式(1)に基づいてエンジン 1の排気ポート2での排ガス温度Texg の推定値を算出する(STEP 16-2)。すなわち、エンジン1の回転数 NE 及び吸気圧 PB の現在 の検出値から所定のマップにより基本排ガス温度 TMAP(NE, PB)を求 め、さらに、この TMAP(NE, PB)と、排ガス温度Texg の推定値の現 在値Texg(k-1)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-2で求 められた値)と、あらかじめ定められた係数Ktex の値とを用いて前記 式(1)の右辺の演算を行う。これにより、排ガス温度Texgの新たな 推定値Texg(k)が算出される。尚、本実施形態では、エンジン1のアイ ドリング運転時と、フュエルカット中においては、式(1)の演算に用 いる基本排ガス温度TMAP を、それぞれの運転状態に対応してあらか じめ定めた所定値に設定するようにしている。また、排ガス温度Texg の推定値は、前述のようにエンジン1の運転開始時(始動時)に、その 時に検出された大気温度TA又は機関温度 TW が初期値Texg(0)として 設定されており、エンジン1の運転開始後、初めて式(1)の演算を行 うときには、その初期値Texg(0)がTexg(k-1)の値として用いられる。

次いで、排気温オブザーバ19は、前記式(5-1)、(5-2) に基づいて前記部分排気通路3aでの排ガス温度Tga の推定値及び排気管温度Twa の推定値を算出する(STEP16-3)。すなわち、排ガス温度Tga の推定値の現在値Tga(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-3で求められた最新値)と、排気管温度Twa の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-3で求められた最新値)と、前記STEP16-2で先に算出した排ガス温度Texg

15

さらに、排ガス温度Tga の推定値の現在値Tga(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-3で求められた最新値)と、排気管温度Twa の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-3で求められた最新値)と、あらかじめ定められたモデル係数Ba,

10 C a の値及び排気温オブザーバ 1 9 の処理の周期 dt の値とを用いて前記式(5-2)の右辺の演算を行うことで、排気管温度 T wa の新たな推定値 T wa(k+1)を求める。

尚、排ガス温度 T ga 及び排気管温度 T wa の推定値は、前述のようにエンジン1の運転開始時(始動時)に、その時に検出された大気温度 T A 又は機関温度 T W がそれぞれの初期値 T ga(0), T wa(0)として設定されており、エンジン1の運転開始後、初めて式(5-1), (5-2) の演算を行うときには、それらの初期値 T ga(0), T wa(0)がそれぞれ T ga(0), T wa(0)がそれぞれ T ga(0), T wa(0)の値として用いられる。

次いで、排気温オブザーバ19は、前記式(6-1)、(6-2) に基 20 づいて前記部分排気通路3bでの排ガス温度Tgb の推定値及び排気管温度Twb の推定値を算出する(STEP16-4)。すなわち、排ガス温度Tgb の推定値の現在値Tgb(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-4で求められた最新値)と、排気管温度Twb の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-4で求められた最新値)と、前記STEP16-3で先に算出した排ガス温度Tgaの推定値の現在値と、前記STEP16-1で算出した流速パラメータ

Α,

15

Vg の現在値と、あらかじめ定められたモデル係数 Ab の値及び排気温オプザーバ19の処理の周期 dt の値とを用いて前記式(6-1)の右辺の演算を行うことで、排ガス温度 Tgb の新たな推定値 Tgb(k+1)を求める。

5 さらに、排ガス温度Tgb の推定値の現在値Tgb(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-4で求められた最新値)と、排気管温度Twb の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-4で求められた最新値)と、あらかじめ定められたモデル係数Bb,Cbの値及び排気温オブザーバ19の処理の周期 dt の値とを用いて前10 記式(6-2)の右辺の演算を行うことで、排気管温度Twb の新たな推定値Twb(k+1)を求める。

尚、排ガス温度 T gb 及び排気管温度 T wb の推定値は、前述のようにエンジン1の運転開始時(始動時)に、その時に検出された大気温度 T A 又は機関温度 T W がそれぞれの初期値 T gb(0),T wb(0)として設定されており、エンジン1の運転開始後、初めて式(6-1),(6-2)の演算を行うときには、それらの初期値 T gb(0),T wb(0)がそれぞれ T gb(k-1),T wb(k-1)の値として用いられる。

次いで、排気温オブザーバ19は、前記式(8-1)、(8-2)に基づいて前記部分排気通路3cでの排ガス温度Tgcの推定値及び触媒温20 度Twcの推定値を算出する(STEP16-5)。すなわち、排ガス温度Tgcの推定値の現在値Tgc(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-5で求められた最新値)と、触媒温度Twcの推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-5で求められた最新値)と、前記STEP16-4で先に算出した排ガス温度Tgbの推定25 値の現在値と、前記STEP16-1で算出した流速パラメータVgの現在値と、あらかじめ定められたモデル係数Acの値及び排気温オブザ

10

15

ーバ19の処理の周期 dt の値とを用いて前記式(8-1)の右辺の演算を行うことで、排ガス温度Tgcの新たな推定値Tgc(k+1)を求める。

さらに、排ガス温度Tgc の推定値の現在値Tgc(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-5で求められた最新値)と、触媒温度Twc の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-5で求められた最新値)と、前記STEP16-1で算出した流速パラメータVg の現在値と、あらかじめ定められたモデル係数Bc, Cc, Dcの値及び排気温オブザーバ19の処理の周期 dt の値とを用いて前記式 (8-2) の右辺の演算を行うことで、触媒温度Twc の新たな推定値Twc(k+1)を求める。

次いで、排気温オブザーバ19は、前記式(9-1)、(9-2)に基づいて前記部分排気通路3dでの(O2センサ8の配置箇所近傍での)排ガス温度Tgdの推定値及び排気管温度Twdの推定値を算出する(S20 TEP16-6)。すなわち、排ガス温度Tgdの推定値の現在値Tgd(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-6で求められた最新値)と、排気管温度Twdの推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-6で求められた最新値)と、前記STEP16-5で先に算出した排ガス温度Tgcの推定値の現在値と、前記STEP16-1で算出した流速パラメータVgの現在値と、あらかじめ定められたモデル係数Adの値及び排気温オブザーバ19の処理の周期

 $\theta = 0$

5

20

25

dt の値とを用いて前記式(9-1)の右辺の演算を行うことで、排ガス温度 T gd の新たな推定値 T gd (k+1) を求める。

さらに、排ガス温度Tgd の推定値の現在値Tgd(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-6で求められた最新値)と、排気管温度Twd の推定値の現在値(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-6で求められた最新値)と、あらかじめ定められたモデル係数Bd,Cdの値及び排気温オブザーバ19の処理の周期 dt の値とを用いて前記式 (9-2) の右辺の演算を行うことで、排気管温度Twd の新たな推定値Twd(k+1)を求める。

次に、センサ温度制御手段18は、素子温オブザーバ20により、STEP16-7の処理を実行し、 O_2 センサ8の素子温度TO2 及びヒータ温度Tht の推定値を前記式(10-1)、(10-2)に基づいて求める。すなわち、素子温度TO2 の推定値の現在値TO2(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-7で求められた最新値)と、ヒータ温度Tht の推定値の現在値Tht(k)(前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-7で求められた最新値)と、前記STEP16-6で先に算出された排ガス温度Tgd の推定値の現在値Tgd(k)と、素子部10の内部の空気の温度TA'としての大気温度TA の検出値の現在値TA(k)(図8のSTEP1で取得した最新値)と、あらかじめ定められたモデル係数Ax、Bxの値及び素子温オブザーバ20の処理の周期 dt

10

15

20

(=排気温オブザーバ19の処理の周期)の値とを用いて前記式(10-1)の右辺の演算を行うことで、素子温度 T_{02} の新たな推定値 T_{02} (k+1)を求める。

さらに、素子温度 T_{02} の推定値の現在値 $T_{02}(k)$ (前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-7で求められた最新値)と、ヒータ温度Tht の推定値の現在値 $T_{16}(k)$ (前回のサイクルタイムにおけるSTEP16-7で求められた最新値)と、素子部10の内部の空気の温度 $T_{16}(k)$ 00円の大気温度 $T_{16}(k)$ 10回の現在値 $T_{16}(k)$ 10回のサイクルタイムにおけるSTEP1で取得した最新値)と、デューティ DUTの現在値 DUT(k)と、あらかじめ定められたモデル係数 $T_{16}(k)$ 10回の処理の周期 dtの値とを用いて前記式(10-2)の右辺の演算を行うことで、ヒータ温度 $T_{16}(k)$ 10回の力を求める。

尚、素子温度 T_{02} 及びヒータ温度Tht の推定値は、前述のようにエンジン1の運転開始時(始動時)に、その時に検出された大気温度 T_A 又は機関温度 TWがそれぞれの初期値 $T_{02}(0)$, Tht(0)として設定されており、エンジン1の運転開始後、初めて式(10-1), (10-2)の演算を行うときには、それらの初期値 $T_{02}(0)$, Tht(0)がそれぞれ $T_{02}(k-1)$, Tht(0)の値として用いられる。また、式(10-2)で用いるデューティ DUT(0)は、基本的には前述の00、00、01 に制限された場合(ヒータ13への通電を遮断する場合)には、その値が式(10-2)で用いられる。

以上説明したセンサ温度制御手段18の処理によって、 O_2 センサ8の素子温度 T_{O_2} が目標値Rに維持されるように O_2 センサ8のヒータ13への供給電力が制御される。この場合、エンジン1の運転開始直後や、大気温度 T_A がかなり低い場合を除いて、通常的には目標値Rが80

10

15

20

25

0 ℃に設定される。この結果、 O_2 センサ 8 の出力特性をエンジン 1 の空燃比制御(触媒装置 4 による良好な浄化性能を確保するための空燃比制御)に適した特性に安定に維持することができ、ひいては、その空燃比制御を良好に行って、触媒装置 4 の良好な浄化性能を確実に維持することができる。

そして、本実施形態では、ヒータ13に対する制御入力としてのデューティ DUT は、素子温度 T_{02} の推定値と目標値Rとの偏差(素子温偏差) eに応じた制御入力成分(式(24)の第1項及び第2項)をフィードバック成分として含むと共に、ヒータ温度T ht の推定値に応じた制御入力成分(式(24)の第3項)を含む。このため、素子温度 T_{02} が目標値Rに対して変動したときに、ヒータ13のデューティ DUT の過大な変動を抑えながら、素子温度 T_{02} を円滑に目標値Rに収束させることができる。尚、本実施形態では、ヒータ温度T ht に係わる ΔT ht を制御対象モデルの状態量としているため、ヒータ温度T ht の推定値に応じた制御入力成分はフィードバック成分としての意味をもつ。

さらに、本実施形態では、デューティ DUT は、素子温度 T_{02} の変動の外乱的な要因となる排ガス温度 T_{gd} の推定値に応じた制御入力成分、すなわち、前記最適外乱 F/F 成分 U_{opfd} をも含でいる。加えて、この最適外乱 F/F 成分 U_{opfd} に係る係数 F_{dt} は、現在の排ガス温度が前記排ガス温度予見時間 M_{d} 後まで継続するとして、予見制御のアルゴリズムにより決定される。このため、排ガス温度 T_{gd} の変動による素子温度 T_{o2} の変動を抑えつつ素子温度 T_{o2} を目標温度に制御することができる。特に、最適外乱 F/F 成分 U_{opfd} に係る係数 F_{dt} が予見制御のアルゴリズムに基づいて決定されているため、排ガス温度 T_{gd} の変動による素子温度 T_{o2} の変動を極力小さなものにすることができる。この結果、素子温度 T_{o2} の目標値 R_{o} の制御の安定性を効果的に高め、ひ

10

15

20

25

いては、 O_2 センサ 8 の出力特性の安定性を効果的に高めることができる。

さらに、デューティ DUT は、素子温度 T_{02} の目標値Rに応じた制御入力成分、すなわち、前記最適目標値F/F成分Uopfr成分をも含んでいる。しかも、その最適目標値F/F成分Uopfr成分は、予見制御のアルゴリズムによって、現在から前記目標値予見時間Mr後までの目標値Rに応じた制御入力成分とされている。このため、特に、目標値Rがエンジン1の運転開始直後の低温側温度(600℃)から通常の高温側温度(750℃~800℃)に切替ったときに、制御入力 DUTが一時的に(過渡的に)過剰に大きくなったり、素子温度 T_{02} が目標値Rに対してオーバーシュートを生じるのを防止することができる。これによっても、 O_2 センサ8の出力特性の安定性を効果的に高めることができる。

図12及び図13に本実施形態に係わるシミュレーション結果を示す。

図12は、エンジン1を搭載した車両を一定の速度で走行させた状態(エンジン1の定常運転状態)において、時刻 t 1 にて目標値 R を低温側の目標値(600℃)から、高温側の目標値(800℃)に切換えた場合におけるヒータ温度 T ht、素子温度 T $_{02}$ 、デューティ DUT の変化の様子を示したものである。図中、実線のグラフe,g,iがそれぞれ本実施形態のようにヒータ13を制御した場合におけるヒータ温度 T ht、素子温度 T $_{02}$ 、デューティ DUT の変化の様子を示している。また、破線のグラフ f,h,j はそれぞれ比較例におけるヒータ温度 T ht、素子温度 T $_{02}$ 、デューティ DUT の変化の様子を示している。この比較例は、式(24)から目標値 R に応じた最適目標値 F/F 成分 U opfr(式(24)の第4項)を除去した式を用いてデューティ DUT を求めてヒータ

同図12から明らかなように、本実施形態では、目標値Rに応じた最

13を制御するようにしたものである。

適目標値 F/F 成分U opfr をデューティ DUT が含むため、目標値R が切替ったときに、デューティ DUT が過大になるのを抑えることができると共に、ヒータ温度T ht や素子温度T O2 の過渡的なオーバシュートを抑制することができる。

5 また、図13は、エンジン1を搭載した車両を、同図の下部のグラフで示すように車速を変化させながら走行させた場合(エンジン1の運転状態を種々様々の運転状態に変化させた場合)における素子温度Tロッの変化の様子を示している。図中、実線のグラフρが本実施形態のようにヒータ13を制御した場合における素子温度Tロッの変化の様子を示している。また、破線のグラフαは比較例における素子温度Tロッの変化の様子を示している。また、破線のグラフαは比較例における素子温度Tロッの変化の様子を示している。この比較例は、式(24)から排ガス温度Tロッはに応じた最適外乱 F/F 成分Uoρfd(式(24)の第5項)を除去した式を用いてデューティ DUT を求めてヒータ13を制御するようにしたものである。

同図13から明らかなように、本実施形態では、排ガス温度Tgd に応じた最適外乱 F/F 成分Uopfd をデューティ DUT が含むため、排ガス温度Tgd の変化に伴う素子温度 T_{02} の変動幅を抑制することができる。

次に、本発明の第2実施形態を図14を参照して説明する。尚、本実 20 施形態は、前記第1の実施形態と一部の構成もしくは機能のみが相違す るものであるので、同一構成部分もしくは同一機能部分については、第 1実施形態のものと同一の参照符号を用いて詳細な説明を省略する。

本実施形態では、前記図1に示したコントロールユニット16のセン サ温度制御手段18は、その機能的手段として、図14のブロック図に こますように排気温オブザーバ19、素子温オブザーバ20、目標値設定 手段31、ヒータコントローラ32を備えている。ここで、排気温オブ

10

15

20

ザーバ19、素子温オブザーバ20は、前記第1実施形態のものと全く同一である。尚、本実施形態では、目標値設定手段31及びヒータコントローラ32の演算処理の周期は、前記第1実施形態における目標値設定手段21及びヒータコントローラ22の演算処理の周期と同一である。

目標値設定手段 3 1 は、 O_2 センサ 8 のヒータ温度 T ht の目標値 R 、を設定するものである。この場合、本願発明者等の知見によれば、ヒータ温度 T ht は、素子温度 T_{O2} との相関性が比較的高く、定常状態では素子温度 T_{O2} よりも一定温度だけ高いものとなる傾向がある。そこで、本実施形態では、目標値設定手段 3 1 は、前記第 1 実施形態で説明したように設定される素子温度 T_{O2} の目標値 R (前記図 9 の処理により設定される目標値 R)よりも所定値 DR (例えば 1 0 0 C)だけ高い値 R + DR を、ヒータ温度 T ht の目標値 R 、として設定するようにしている。尚、目標値設定手段 R R なの処理のサイクルタイム毎に設定する目標値 R が、その処理のサイクルタイム毎に設定する目標値 R が、この目標値予見時間 R の期間分の目標値 R が逐次更新されつつ記憶保持される。

ヒータコントローラ32は、ヒータ温度Thtが目標値R'に維持されるように、制御入力としてのデューティ DUT を逐次決定するものである。この場合、本実施形態では、第1実施形態のものと同様、ヒータコントローラ32は、最適予見制御アルゴリズムにより、基本デューティ SDUT を算出し、さらにその基本デューティ SDUT を、前記式(25)により、バッテリ電圧 VBに応じて補正することでデューティ DUTを生成するようにしている。

より具体的には、本実施形態では、ヒータ温度Tht とそれに対する 25 目標値R との偏差e と、その偏差e の所定時間毎の変化量 Δe (これは偏差e の変化速度に相当する)と、素子温度 T_{02} の所定時

PCT/JP2003/003956

 $2 = \mathfrak{g}$

間毎の変化量 ΔT_{02} (これは素子温度 T_{02} の変化速度に相当する)とに着目し、これらをヒータコントローラ 32 の制御対象に係わる状態量として、該制御対象のモデル式を導入している。

このモデル式は、偏差 e' (以下、ヒータ温偏差 e' という)を e' (n)= T ht(n)- R' (n)と定義したとき、前記第 1 実施形態の場合と同様の考え方によって、前記式 (11-1)、(11-2) に基づいて、次式 (26) により与えられる。

$$X1(n+1) = \Phi' \cdot X1(n) + G' \cdot \Delta SDUT(n) + Gd' \cdot \Delta Tgd(n) + Gr' \cdot R1(n+1)$$
 $\dots (26)$
但し、 $X1(n) = (e'(n), \Delta e'(n), \Delta To2(n))^T$
 $R1(n+1) = (\Delta R'(n+1), \Delta R'(n))^T$
 $G' = (0, Dx \cdot dtc, 0)^T$
 $Gd' = (0, 0, Ax \cdot dtc)^T$

$$\Phi' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 - Cx \cdot dtc - Fx \cdot dtc \\ 0 & Bx \cdot dtc \end{bmatrix} Cx \cdot dtc - Ex \cdot dtc$$

$$Gr' = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 - Cx \cdot dtc - Fx \cdot dtc \\ 0 & Bx \cdot dtc \end{bmatrix}$$

そして、本実施形態でヒータコントローラ32が求める基本制御入力 10 SDUT (バッテリ電圧 VB が基準値 NVB に等しいときの制御入力) は、 次式 (27) の評価関数 J1 を最小化するような Δ SDUT (式 (26) のモデル上での制御入力) を積分したものとして、式 (28) により与 えられる。

5

PCT/JP2003/003956

$$J1 = \sum_{n=-M+1}^{\infty} [X1^{T}(n) \cdot Q0 \cdot X1(n) + \Delta SDUT^{T}(n) \cdot H0 \cdot \Delta SDUT(n)] \cdot \cdots (27)$$

但し、M=max(Mr, Md)

SDUT(n)=Fs1•
$$\sum_{j=1}^{n} e'(j)$$
 +Fe1•e'(n)+Fx1•To2(n)
+ $\sum_{i=0}^{Mr} [Fr'(i)•R'(n+i)]$ +Fdt'•Tgd(n) ······(28)

ここで、式(28)の右辺の第1項〜第3項までの係数Fs1, Fe1, Fx1 と、第4項に係わる係数Fr'(i)(i=0, 1, …, Mr)と、第5項に係わる係数Fdt'は、それぞれ、次式(29-1)~(29-3)により与えられる係数である。

F1
$$\equiv$$
 (Fs1, Fe1, Fx1)
= $-[H0+G'^T \cdot P' \cdot G']^{-1} \cdot G'^T \cdot P' \cdot \Phi' \quad \cdots (29-1)$

$$Fr'(i) = \begin{cases} Fr12(1) & :i=0 \\ Fr11(i) + Fr12(i+1) : i=1, 2, \dots, Mr-1 & \dots \\ Fr11(Mr) & :i=Mr \end{cases}$$

Fdt' =
$$\sum_{i=0}^{Md} \{-[H0+G'^{T} \cdot P' \cdot G']^{-1} \cdot G'^{T} \cdot (\zeta'^{T})^{i} \cdot P' \cdot Gd'\}$$
(29-3)

但し、

5

10

$$P' = Q0 + \Phi'^{T} \cdot P' \cdot \Phi'$$

$$-\Phi' \cdot P' \cdot G' \cdot [H0 + G'^{T} \cdot P' \cdot G']^{-1} \cdot G'^{T} \cdot P' \cdot \Phi'$$

$$\xi' = \Phi' + G' \cdot F1$$

$$(Fr11(i), Fr12(i))$$

$$= -[H0 + G'^{T} \cdot P' \cdot G']^{-1} \cdot G'^{T} \cdot (\xi'^{T})^{i-1} \cdot P' \cdot Gr'$$

$$(i=1, 2, \dots, Mr)$$

尚、評価関数J1に係わる重み行列Q0、H0、並びに、目標値予見時間Mr及び排ガス温度予見時間Mdは、本実施形態では前記第1実施形態と同一としているが、第1実施形態とは異なる値を設定するようにしてもよい。また、式(28)の係数Fs1、Fe1、Fx1、Fr'(i)、Fdt'は、必ずしも式(29-1)~(29-3)の定義式通りの値を用いる必用はなく、実験やシミュレーションを通じて適宜調整した値を用いるようにしてもよい。さらには、ヒータ温度、素子温等に応じて変更してもよい。また、本実施形態では、前記第1実施形態と同様、排ガス温度TgdはMdステップ後の未来まで現在値に維持されるとしているが、未来の各時刻のTgdが検出もしくは推定可能な場合には、それらの値を用いて制御入力 DUT を求めるようにしてもよい(この場合には、Fdt'はベクトルとなる)。

10

15

20

25

前記式(28)が、本実施形態でヒータコントローラ32によりヒー タ13を制御するための基本制御入力 SDUT(n)を逐次算出するための 演算式である。すなわち、ヒータコントローラ32は、基本制御入力 SDUT(n)を該ヒータコントローラ32の制御処理のサイクルタイム(周 期)毎に式(28)により逐次算出する。そして、ヒータコントローラ 3 2 は、前記第 1 実施形態と同様に、この基本制御入力 SDUT(n)を、 前記式(25)によりバッテリ電圧 VB に応じて補正することにより、 デューティ DUT(n)を求める。尚、式(28)の右辺各項は、前記第 1 実施形態のものと同様の意味を持つ。すなわち、右辺の第1から第3項 まで (Σ e'(j)を含む項~T02(n)を含む項まで) は、ヒータ温偏差 e'や素子温度To2に応じた制御入力成分(最適制御アルゴリズムに 基づくフィードバック成分)である。より詳しくは、第1項及び第2項 は、ヒータ温偏差e'に応じた制御入力成分、第3項は素子温度To2 に応じた制御入力成分である。また、式(28)の右辺第4項(ΣF r'(i)・R'(n+i)の項)と、右辺第5項(Tgd(n)を含む項)とは、そ れぞれ目標値R、排ガス温度Tgd に応じた制御入力成分(予見制御ア ルゴリズムに基づくフィードフォワード成分)である。

ここで、式 (28) により基本制御入力 SDUT(n)を求めるために必要な素子温度 T_{02} 及び排ガス温度 T_{gd} は、それぞれ、前記素子温オブザーバ 20 により求められた素子温度 T_{02} の推定値の最新値、前記排気温オブザーバ 19 により求められた排ガス温度 T_{gd} の推定値の最新値が用いられる。

さらに、式(28)の演算に必要なヒータ温偏差 e 'は、前記素子温 オブザーバ20により求められたヒータ温度 Tht の推定値の最新値と、 前記目標値設定手段31により前記目標値予見時間 Mr 前のサイクルタ イムで設定された目標値 R 'とから算出される。

10

15

20

以上説明した以外の処理は、前記第 1 実施形態と同一である。かか る本実施形態では、O2センサ8のヒータ温度Thtが目標値R'に維持 されるように〇2センサ8のヒータ13への供給電力が制御される。こ の場合、エンジン1の運転開始直後や、大気温度TAがかなり低い場合 (T₄<0℃)を除いて、通常的には目標値R'は、素子部10の好適 な目標温度である800℃よりも所定値 DR (本実施形態では10 0 ℃) だけ高い温度 (9 0 0 ℃) に設定される。この結果、O2 センサ 8 の素子部 1 0 の温度 T₀₂ は、間接的に、ほぼ 8 0 0 ℃の温度に制御 されることとなる。このため、前記第 1 実施形態と同様に、O2 センサ 8の出力特性をエンジン1の空燃比制御(触媒装置4による良好な浄化 性能を確保するための空燃比制御)に適した特性に安定に維持すること ができ、ひいては、その空燃比制御を良好に行って、触媒装置4の良好 な浄化性能を確実に維持することができる。尚、エンジン1の運転開始 直後の所定時間は、素子部10の目標温度Rとしての低温側の温度(6 00℃)よりも上記所定値 DR だけ高い温度 (700℃) がヒータ13 の目標温度 R'として設定され、これにより、素子部 10 が急激な加熱 に伴う応力により損傷するのが防止される。さらに、大気温度TAが低 い場合 (T_A<0℃) には、素子部10の目標温度Rを750℃≦R< 800℃にすることに対応して、ヒータ13の目標温度R′は、85 0℃≤R′<900℃に設定され、これにより、ヒータ13が過熱状態 となるのが回避される。

また、本実施形態においては、ヒータ13に対する制御入力であるデューティ DUT は、ヒータ温度Tht の推定値と目標温度R'との偏差に応じた制御入力成分(前記式(28)の第1項(Σe'(j)を含む項)及び第2項(e'(n)を含む項))と、素子温度T₀₂の推定値に応じた制御入力成分(前記式(28)の第3項)とをフィードバック成分として含

む。加えて、本実施形態においても、予見制御のアルゴリズムを適用し、デューティ DUT には、排ガス温度Tgd に応じた制御入力成分(式(28)の右辺第5項のフィードフォワード成分)と、目標値R'に応じた制御入力成分(式(28)の右辺第4項のフィードフォワード成分)とが含まれる。この結果、前記第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。従って、ヒータ温度Thtを確実に所望の目標値R'に安定して制御することができる。

次に本発明の第3実施形態を説明する。尚、本実施形態は、前記第1 10 実施形態のものと、ヒータコントローラの処理のみ(具体的には、図1 0のSTEP5-4の処理)が相違するものであるので、前記第1 実 施形態と同一構成部分及び同一機能部分については、第1の実施形態と 同一の図面及び参照符号を用いて説明を省略する。

本実施形態では、ヒータコントローラ 2 2 は、素子温度 T_{02} と目標 15 値 R との偏差 e (素子温偏差 e)と、素子温度 T_{02} と、ヒータ温度T ht とを制御対象の状態量として、最適予見制御のアルゴリズムを用いて制御入力としての DUT を逐次生成するものである。この場合、該ヒータコントローラ 2 2 の処理のアルゴリズムは、次のように構築されている。まず、前記式 (11-1)、(11-2) をまとめると、次式 (30-1) をまるのの (30-2) が得られる。

 $Xz(k+1)=Az\cdot Xz(k)+Bz\cdot \Delta SDUT(k)+Ez\cdot \Delta Tgd(k)$ (30-1) $\Delta To_2(k)=Cz\cdot Xz(k)$ (30-2)

但し、 $Xz(k)=(\Delta To_2(k), \Delta Tht(k))^T$

Cz = (1, 0)

$$Az = \begin{bmatrix} 1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt & Bx \cdot dt \\ Cx \cdot dt & 1 - Cx \cdot dt - Fx \cdot dt \end{bmatrix}$$

$$Bz = (0, Dx \cdot dt)^{T}$$

$$Ez = (Ax \cdot dt, 0)^{T}$$

また、式(30-1)、(30-2)から、次式(31)が得られる。

 $\Delta To₂(k+1) = Cz \cdot Xz(k+1)$ $= Cz \cdot Az \cdot Xz(k) + Cz \cdot Bz \cdot \Delta SDUT(k) + Cz \cdot Ez \cdot \Delta Tgd(k)$ $\cdots (31)$

5 尚、この式(31)は、前記式(11-2)と同じ式であり、式(22-1)、(22-2)の但し書きで定義した行列Az及びベクトルBz、
 Ez、Czを用いて前記式(11-2)を書き改めたものである。

ここで、本実施形態では、前記式(12)により定義される前記素子温偏差 e の所定時間毎の変化量(偏差変化量) Δ e を、 Δ e (k+1) = e 10 (k+1) - e (k)により定義する。このとき、この定義式と、上記式(31)とから、次式(32)が得られる。

$$e(k+1) = e(k) + \Delta e(k+1)$$

$$= e(k) + (\Delta To_2(k+1) - \Delta R(k+1))$$

$$= e(k) + Cz \cdot Az \cdot Xz(k) + Cz \cdot Bz \cdot \Delta SDUT(k)$$

$$+ Cz \cdot Ez \cdot \Delta Tgd(k) - \Delta R(k+1) \qquad \cdots (32)$$

そして、この式 $(3\ 2)$ と、前記式 $(3\ 0-1)$ とまとめると、次式 $(3\ 3)$ が得られる。

$$X2(k+1) = \Phi 2 \cdot X2(k) + G2 \cdot \Delta SDUT(k) + Gd2 \cdot \Delta Tgd(k) + Gr2 \cdot \Delta R(k+1) + \cdots (33)$$

但し、 $X2(k)=(e(k), \Delta To_2(k), \Delta Tht(k))^T$

$$\Phi 2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt & Bx \cdot dt \\ 0 & 1 - Ax \cdot dt - Bx \cdot dt - Ex \cdot dt & Bx \cdot dt \\ 0 & Cx \cdot dt & 1 - Cx \cdot dt - Fx \cdot dt \end{bmatrix}$$

 $G2=(0, 0, Dx \cdot dt)^T$

 $Gd2=(Ax\cdot dt, Ax\cdot dt, 0)^T$

 $Gr2=(-1, 0, 0)^T$

この式(3 3)が、本実施形態におけるヒータコントローラ 2 2 の制 5 御対象モデルの基本式である。この制御対象モデルでは、制御対象の状態量は、素子温偏差 e と、素子温度 T_{02} の所定時間毎の変化量 ΔT_{02} と、ヒータ温度 T_{02} からなる状態量ベクトル X_{02} 2(k) = (e(k), ΔT_{02} (k), ΔT_{02} (k), ΔT_{03} (k), ΔT_{04} (k)) である。

但し、本実施形態では、前記第 1 実施形態と同様の理由によって、 10 ヒータコントローラ 2 2 の処理のサイクルタイムは、素子温オブザーバ 2 0 や排気温オブザーバ 1 9 の処理の周期よりも長いものとする。従っ て、本実施形態で実際に用いる制御対象モデルの式は、ヒータコントロ ーラ 2 2 の処理の周期 dtc と、その処理周期の番数 n とを用いて次式 (3 4)となる。

$$X2(n+1) = \Phi 2 \cdot X2(n) + G2 \cdot \Delta SDUT(n) + Gd2 \cdot \Delta Tgd(n) + Gr2 \cdot \Delta R(n+1) \cdot \cdots (34)$$

但し、 $X2(n)=(e(n), \Delta To2(n), \Delta Tht(n))^T$

$$\Phi_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 - Ax \cdot dtc - Bx \cdot dtc - Ex \cdot dtc & Bx \cdot dtc \\ 0 & 1 - Ax \cdot dtc - Bx \cdot dtc - Ex \cdot dtc & Bx \cdot dtc \\ 0 & Cx \cdot dtc & 1 - Cx \cdot dtc - Fx \cdot dtc \end{bmatrix}$$

G2= $(0, 0, Dx \cdot dtc)^T$ Gd2= $(Ax \cdot dtc, Ax \cdot dtc, 0)^T$ Gr2= $(-1, 0, 0)^T$

このモデル式 (34) に基づいて、最適予見制御アルゴリズムにより ヒータコントローラ 22 が求める基本制御入力 SDUT (バッテリ電圧 VB が基準値 NVB に等しいときの制御入力) は、前記第 1 実施形態と 同様の考え方にによって、次式 (35) の評価関数 J2 を最小化するよ うな Δ SDUT (式 (34) のモデル上での制御入力) を積分したものと して、式 (36) により与えられる。

J2=
$$\sum_{n=-M+1}^{\infty}$$
[X2^T(n)・Q0・X2(n)+ Δ SDUT^T(n)・H0・ Δ SDUT(n)] ·····(35)
但し、M=max(Mr, Md)

SDUT(n)=Fs2·
$$\sum_{j=1}^{n} e(j)$$
 +Fx2·To2(n)+Fx3·Tht(n)
+ $\sum_{i=1}^{Mr} [Fr2(i)\cdot R(n+i)]$ +Fdt2·Tgd(n)(36)

10

5

ここで、式(36)の右辺の第1項~第3項までの係数Fs2, Fx2, Fx3 と、第4項に係わる係数Fr2(i)(i=1, 2, …, Mr)と、第5項に係わる係数Fdt2 は、それぞれ、次式(37-1)~(37-3)

10

により与えられる係数である。

$$F2 \equiv (Fs2, Fx2, Fx3)$$

$$= -[H0+G2^{T} \cdot P2 \cdot G2]^{-1} \cdot G2^{T} \cdot P2 \cdot \Phi2 \qquad \cdots (37-1)$$

$$Fr2(i) = -[H0+G2^{T} \cdot P2 \cdot G2]^{-1} \cdot G2^{T} \cdot (\xi 2^{T})^{i-1} \cdot P2 \cdot Gr2$$

$$(i=1, 2, \cdots, Mr) \qquad \cdots (37-2)$$

$$Fdt2 = \sum_{i=0}^{Md} \{-[H0+G2^{T} \cdot P2 \cdot G2]^{-1} \cdot G2^{T} \cdot (\xi 2^{T})^{i} \cdot P2 \cdot Gd2\}$$

$$\cdots (37-3)$$

$$\text{但L},$$

$$P2 = Q0 + \Phi 2^{T} \cdot P2 \cdot \Phi 2$$

$$-\Phi 2 \cdot P2 \cdot G2 \cdot [H0+G2^{T} \cdot P2 \cdot G2]^{-1} \cdot G2^{T} \cdot P2 \cdot \Phi2$$

$$\xi 2 = \Phi 2 + G2 \cdot F2$$

尚、評価関数J2に係わる重み行列Q0、H0、並びに、目標値予見時間Mr 及び排ガス温度予見時間Md は、本実施形態では前記第1実施形態と同一としているが、第1実施形態とは異なる値を設定するようにしてもよい。また、式(36)の係数Fs2、Fx2、Fx3、Fr2(i)、F dt2 は、必ずしも式(37-1)~(237-3)の定義式通りの値を用いる必用はなく、実験やシミュレーションを通じて適宜調整した値を用いるようにしてもよい。さらには、ヒータ温度、素子温等に応じて変更してもよい。また、本実施形態では、前記第1 実施形態と同様、排ガス温度Tgd はMd ステップ後の未来まで現在値に維持されるとしているが、未来の各時刻のTgd が検出もしくは推定可能な場合には、それらの値を用いて制御入力 DUT を求めるようにしてもよい(この場合には、Fdt2 はベクトルとなる)。

15 前記式(36)が、本実施形態でヒータコントローラ32によりヒータ13を制御するための基本制御入力 SDUT(n)を逐次算出するための

ド成分)である。

5

10

15

20

25

演算式である。すなわち、ヒータコントローラ 2 2 は、基本制御入力 SDUT(n)を該ヒータコントローラ 2 2 の制御処理のサイクルタイム(周期)毎に式(3 6)により逐次算出する。そして、ヒータコントローラ 2 2 は、前記第 1 実施形態と同様に、この基本制御入力 SDUT(n)を、前記式(2 5)によりバッテリ電圧 VB に応じて補正することにより、デューティ DUT(n)を求める。尚、式(3 6)の右辺の第 1 から第 3 項まで(Σ e (j)を含む項~T ht(n)を含む項まで)は、素子温偏差 e や素子温度T o2、ヒータ温度T ht に応じた制御入力成分(最適制御アルゴリズムに基づくフィードバック成分)である。より詳しくは、第 1 項は素子温偏差 e に応じた制御入力成分、第 2 項は素子温度T o2 に応じた制御入力成分、第 3 項はヒータ温度T ht に応じた制御入力成分である。また、式(3 6)の右辺第4 項(Σ F r 2(i)・R (n+i)の項)と、右辺第5項(T gd(n)を含む項)とは、それぞれ目標値R、排ガス温度T gd に応じた制御入力成分(予見制御アルゴリズムに基づくフィードフォワー

ここで、式(36)により基本制御入力 SDUT(n)を求めるために必要な素子温度 T_{02} 及びヒータ温度 T_{11} は、それぞれ、前記素子温オブザーバ20により求められた素子温度 T_{02} の推定値の最新値、ヒータ温度 T_{11} の推定値の最新値が用いられ、式(36)の排ガス温度 T_{12} は、前記排気温オブザーバ19により求められた排ガス温度 T_{13} の推定値の最新値が用いられる。

さらに、式(36)の演算に必要な素子温偏差eは、前記素子温オブザーバ20により求められた素子温度To2の推定値の最新値と、前記目標値設定手段21により前記目標値予見時間Mr 前のサイクルタイムで設定された目標値R(n)とから算出される。また、式(36)の右辺第4項は、目標値設定手段21により前記目標値予見時間Mr 前のサイ

10

15

20

25

クルタイムより 1 サイクル後のサイクルタイムから、現在までに設定された目標値 R の時系列データ R (n+1)、 R (n+2)、 \cdots 、 R (n+Mr)を用いて算出される。

以上説明した以外の処理は、前記第 1 実施形態と同一である。より 詳しくは、本実施形態では、ヒータコントローラ22は、図10のST EP5-4において、式(36)、(37)により DUT(n)を求める。そ して、そのSTEP5-4の処理以外の処理は、前記第 1 実施形態と 全く同一である。かかる本実施形態においても、前記第 1 実施形態と 同様に、素子温度 To2 が目標値 R に制御されることとなる。この場合、 前記基本制御入力 SDUT は、前記第 1 実施形態と異なり、素子温偏差 e に直接的に比例した入力成分は含んでいないものの、特に、素子温度 T_{0} に応じた成分(式(36)の第2項)を含んでいる。このため、 エンジン1の運転開始直後や、目標値設定手段21により目標値Rが低 温側の目標値(本実施形態では600℃)から高温側の目標値(75 0℃~800℃)に切換えられた場合に、素子温度T02が目標値Rに 近づいていくときに、素子温度Tozが目標値Rに対してオーバシュー トを生じるのを効果的に防止することができる。尚、基本制御入力 SDUT、ひいてはデューティ DUT が、ヒータ温度Tht や、目標値R、 排ガス温度Tgd に応じた入力成分を含むことによる効果は、前記第 1 実施形態と同様である。

次に、本発明の第4実施形態を説明する。尚、本実施形態は、前記第2実施形態のものと、ヒータコントローラの処理のみが相違するものであるので、第2実施形態と同一構成部分及び同一機能部分については、第2実施形態と同一の図面及び参照符号(第2実施形態で援用した第1実施形態のものを含む)を用いて説明を省略する。

本実施形態は、前記第 2 実施形態で説明したヒータコントローラ 3

2 (図 1 4) の処理のみが、該第 2 実施形態と相違するものであり、前記第 3 実施形態で説明したような形態の最適予見制御アルゴリズムによりデューティ DUT を求めるものである。すなわち、本実施形態では、ヒータコントローラ 3 2 の制御対象の状態量を、ヒータ温度Tht と目標値 R , との偏差 (ヒータ温偏差) e , と、素子温度 T_{02} の所定時間毎の変化量 ΔT_{02} と、ヒータ温度Tht の所定時間毎の変化量 ΔT_{02} と、ヒータ温度Tht の所定時間毎の変化量 ΔT_{02} と、ヒータ温度Tht の所定時間毎の変化量 ΔT_{02} に、カーシャントローラ ΔT_{02} に

$$X3(n+1) = \Phi 3 \cdot X3(n) + G3 \cdot \Delta SDUT(n) + Gd3 \cdot \Delta Tgd(n) + Gr3 \cdot \Delta R'(n+1) \quad \cdots \quad (38)$$

但し、 $X3(n)=(e'(n), \Delta To2(n), \Delta Tht(n))^T$

$$\Phi_3 = \begin{bmatrix} 1 & \text{Cx-dte} & 1 - \text{Cx-dte} - \text{Fx-dte} \\ 0 & 1 - \text{Ax-dte} - \text{Bx-dte} & \text{Bx-dte} \\ 0 & \text{Cx-dte} & 1 - \text{Cx-dte} - \text{Fx-dte} \end{bmatrix}$$

G3= $(Dx \cdot dtc, 0, Dx \cdot dtc)^T$ Gd3= $(0, Ax \cdot dtc, 0)^T$ Gr3= $(-1, 0, 0)^T$

15

5

10

そして、本実施形態でヒータコントローラ32が求める基本制御入力 SDUT (バッテリ電圧 VB が基準値 NVB に等しいときの制御入力) は、 次式(39)の評価関数 J 3 を最小化するような Δ SDUT (式(38) のモデル上での制御入力)を積分したものとして、式(40) により与えられる。

J3=
$$\sum_{n=-M+1}^{\infty}$$
[X3^T(n)・Q0・X3(n)+ Δ SDUT^T(n)・H0・ Δ SDUT(n)] ……(39)
但し、M=max(Mr, Md)

5

SDUT(n)=Fs3·
$$\sum_{j=1}^{n} e'(j)$$
 +Fx4·To₂(n)+Fx5·Tht(n)
+ $\sum_{i=1}^{Mr} [Fr3(i)\cdot R'(n+i)]$ +Fdt3·Tgd(n)(40)

ここで、式(40)の右辺の第1項~第3項までの係数Fs3, Fx4, Fx5 と、第4項に係わる係数Fr3(i)(i=1, 2, …, Mr)と、第5 項に係わる係数Fdt3 は、それぞれ、次式(41-1)~(41-3) により与えられる係数である。

F3
$$\equiv$$
(Fs3, Fx4, Fx5)
= $-[H0+G3^{T}\cdot P3\cdot G3]^{-1}\cdot G3^{T}\cdot P3\cdot \Phi3$ (41-1)

Fr3(i) =
$$-[H0+G3^{T} \cdot P3 \cdot G3]^{-1} \cdot G3^{T} \cdot (\zeta 3^{T})^{i-1} \cdot P3 \cdot Gr3$$

(i=1, 2, ..., Mr)(41-2)

$$Fdt3 = \sum_{i=0}^{Md} \{-[H0 + G3^{T} \cdot P3 \cdot G3]^{-1} \cdot G3^{T} \cdot (\zeta 3^{T})^{i} \cdot P3 \cdot Gd3\}$$
(41-3)

但し、

5

10

$$P3 = Q0 + Φ3^{T} \cdot P3 \cdot Φ3$$

 $-Φ3 \cdot P3 \cdot G3 \cdot [H0 + G3^{T} \cdot P3 \cdot G3]^{-1} \cdot G3^{T} \cdot P3 \cdot Φ3$
 $ξ3 = Φ3 + G3 \cdot F3$

尚、評価関数J3に係わる重み行列Q0、H0、並びに、目標値予見時間Mr及び排ガス温度予見時間Mdは、本実施形態では前記第1実施形態と同一としているが、第1実施形態とは異なる値を設定するようにしてもよい。また、式(40)の係数Fs3、Fx4、Fx5、Fr3(i)、Fdt3は、必ずしも式(41-1)~(41-3)の定義式通りの値を用いる必用はなく、実験やシミュレーションを通じて適宜調整した値を用いるようにしてもよい。さらには、ヒータ温度、素子温等に応じて変更してもよい。また、本実施形態では、前記第1実施形態と同様、排ガス温度TgdはMdステップ後の未来まで現在値に維持されるとしているが、未来の各時刻のTgdが検出もしくは推定可能な場合には、それらの値を用いて制御入力 DUTを求めるようにしてもよい(この場合には、Fdt3はベクトルとなる)。

前記式(40)が、本実施形態でヒータコントローラ32によりヒー 15 夕13を制御するための基本制御入力 SDUT(n)を逐次算出するための 演算式である。すなわち、ヒータコントローラ32は、基本制御入力 SDUT(n)を該ヒータコントローラ32の制御処理のサイクルタイム(周

10

15

20

25

期)毎に式(40)により逐次算出する。そして、ヒータコントローラ 3 2 は、前記第 1 実施形態と同様に、この基本制御入力 SDUT(n)を、 前記式(25)によりバッテリ電圧 VB に応じて補正することにより、 デューティ DUT(n)を求める。尚、式(40)の右辺の第1から第 3 項 まで(Σ e'(j)を含む項~T ht(n)を含む項まで)は、ヒータ温偏差 e'や素子温度 T_{02} 、ヒータ温度T ht に応じた制御入力成分(最適制御アルゴリズムに基づくフィードバック成分)である。より詳しくは、 第 1 項はヒータ温偏差 e'に応じた制御入力成分、第 2 項は素子温度 T_{02} に応じた制御入力成分、第 3 項はヒータ温度T ht に応じた制御入力成分 成分である。また、式(40)の右辺第 4 項(Σ Fr 3(i)・R,'(n+i)の 項)と、右辺第 5 項(T gd(n)を含む項)とは、それぞれ目標値 R'、 排ガス温度T gd に応じた制御入力成分(予見制御アルゴリズムに基づくフィードフォワード成分)である。

ここで、式(40)により基本制御入力 SDUT(n)を求めるために必要な素子温度 T_{02} 及び排ガス温度 T_{gd} は、それぞれ、前記素子温オブザーバ20により求められた素子温度 T_{02} の推定値の最新値、前記排気温オブザーバ19により求められた排ガス温度 T_{gd} の推定値の最新値が用いられる。さらに、式(40)の演算に必要なヒータ温偏差 e'は、前記素子温オブザーバ20により求められたヒータ温度 T_{gd} かられたヒータ温度 T_{gd} が能力がある。 すれた目標値設定手段31により前記目標値予見時間Mr前のサイクルタイムで設定された目標値R'(n)とから算出される。 また、式(40)の右辺第4項は、目標値設定手段31により前記目標値予見時間Mr前のサイクルタイムより1サイクル後のサイクルタイムから、現在までに設定された目標値R'の時系列データR'(n+1)、R'(n+2)、…、R'(n+Mr)を用いて算出される。

以上説明した以外の処理は、前記第2実施形態と同一である。かかる

10

15

20

25

 C_{i}

本実施形態においても、前記第2実施形態と同様に、ヒータ温度 Tht が目標値 R に制御され、ひいては、素子温度 T_{02} が該目標値 R に対応した温度に制御されることとなる。この場合、前記基本制御入力 SDUT は、前記第2実施形態と異なり、ヒータ温偏差 e ・に直接的に比例した入力成分は含んでいないものの、特に、ヒータ温度 Tht に応じた成分(式(40)の第3項)を含んでいる。このため、エンジン1の 運転開始直後や、目標値設定手段 3 1 により目標値 R ・が低温側の目標値 (本実施形態では 7 00 $\mathbb C$) から高温側の目標値 $(850\mathbb C \sim 90\mathbb C)$ に切換えられた場合に、ヒータ温度 Tht が目標値 R ・に近づいていくときに、ヒータ温度 Tht が目標値 R ・に対してオーバシュートを生じるのを効果的に防止することができる。ひいては、素子温度 T O2 をヒータ温度 Tht の目標値 R ・に対応した温度に円滑に収束させることができる。また、基本制御入力 SDUT、ひいてはデューティ Tout が、ヒータ温度 Tout の目標値 Tout Tout

尚、以上説明した第 $1 \sim$ 第 4 実施形態では、排ガス温度 T gd を推定するようにしたが、例えば O_2 センサ 8 の近傍に、排ガス温度センサを設け、この排ガス温度センサにより排ガス温度 T gd を検出するようにしてもよい。また、 O_2 センサ 8 から離間した場所に排ガス温度センサが備えられている場合であっても、排気系のレイアウト等によって、その排ガス温度センサの検出温度が O_2 センサ 8 の近傍の排ガス温度 T gd とほぼ同等になるような場合には、その検出温度を O_2 センサ 8 の近傍の排ガス温度 T gd とほば同等になるような場合には、その検出温度を O_2 センサ 0 の近傍の排ガス温度 0 の排ガス温度 0 の値としてもよい。このように排ガス温度センサの検出温度を用いる場合にあっては、前記式(0 0 の排ガス温度 0 の値として、排ガス温度センサの検出値(最新値)を用いて、素子温度 0 の位として多温度 0 大能定する。さら

10

に、式(24)あるいは式(28)あるいは式(36)あるいは式(40)の排ガス温度Tgdの値として、排ガス温度センサの検出値(最新値)を用いて、基本デューティ SDUT を算出し、さらに式(25)によりデューティ DUT を算出するようにすればよい。

さらに、 O_2 センサ8から離間した場所に排ガス温度センサが備えられている場合で、その排ガス温度センサの検出温度が O_2 センサ8の近傍の排ガス温度Tgd と必ずしも同等にならないような場合には、排ガス温度センサの検出温度を用いて O_2 センサ8の近傍の排ガス温度Tgdを推定するようにすることも可能である。例えば、前記部分排気通路3bにおける排ガス温度Tgb を検出できる排ガス温度センサが備えられている場合には、前記式(8-1)における排ガス温度Tgb として検出値を用いることで、式(8)及び式(9)の演算により、 O_2 センサ8の近傍の排ガス温度Tgd を推定できる。尚、この場合には、式(1)、(5)、(6)の演算処理は不要となる。

15 また、前記第 1 及び第 2 実施形態では、素子温度 T O2 及びヒータ温度 Tht の両者を推定するようにしたが、いずれか一方、もしくは両者を温度センサにより直接的に検出するようにしてもよい。素子温度 T O2 を検出するようにした場合には、式 (10-2)の素子温度 T O2 の値として、該素子温度 T O2 の検出値を用いて、ヒータ温度 Tht を推定する。さらに、式 (24)あるいは式 (28)あるいは式 (36)あるいは式 (40)の演算におけるヒータ温度 Tht として、推定値を用いると共に、素子温度 T O2 の値として、該素子温度 T O2 の検出値を用いることで、デューティ DUT を算出するようにすればよい。また、ヒータ温度 Tht を検出するようにした場合には、式 (10-1)のヒータ温度 Tht の値として、該ヒータ温度 Tht の検出値を用いて、素子温度 T O2 を推定する。さらに、式 (24)あるいは式 (28)あるいは式

15

20

25

0 0

(36)あるいは式(40)の演算における素子温度 T_{02} として、推定値を用いると共に、ヒータ温度Tht の値として、該ヒータ温度Tht の検出値を用いることで、デューティ DUT を算出するようにすればよい。また、素子温度 T_{02} 及びヒータ温度Tht の両者を温度センサで検出するようにした場合には、式(24)あるいは式(28)あるいは式(36)あるいは式(40)の演算における素子温度 T_{02} 及びヒータ温度Tht の値として、それらの検出値を用いることで、デューティDUTを算出するようにすればよい。

また、前記第1及び第2実施形態では、最適予見制御のアルゴリズム により O_2 センサ8の素子温度 T_{O_2} 又はヒータ温度Tht を目標値R又は R に制御するようにしたが、本発明はこれに限られるものではない。

例えば予見制御のアルゴリズムを含まない通常的な最適制御のアルゴリズムにより制御入力 DUT を求めるようにしてもよい。この場合には、式(24)又は式(36)の右辺から、第4項(R(n+i)を含む項)と第5項(Tgd(n)を含む項)とを除去した式、あるいは、式(28)又は式(40)の右辺から、第4項(R'(n+i)を含む項)と第5項(Tgd(n)を含む項)とを除去した式によって、制御入力 DUT を逐次算出するようにすればよい。このようにした場合には、制御入力 DUT を求めるヒータコントローラは、式(17)あるいは式(27)あるいは式(35)あるいは式(39)でM=0としてなる評価関数J0又はJ1又はJ2又はJ3の値を最小化するように制御入力 DUT を求める最適サーボコントローラとなる。

あるいは、例えば、式(24)の右辺から、第3項(ヒータ温度Tht に応じた成分)、第4項(R(n+i)を含む項)及び第5項(Tgd(n)を含む項)のいずれか一つもしくは二つを除去した式によって、制御入力 DUT を算出するようにしてもよい。また、例えば式(28)の右辺か

10

5、第3項(素子温度T₀₂に応じた成分)、第4項(R'(n+i)を含む項)及び第5項(Tgd(n)を含む項)のいずれか一つもしくは二つを除去した式によって、制御入力 DUT を算出するようにしてもよい。また、例えば式(36)の右辺から、第3項(ヒータ温度Tht に応じた成分)、第4項(R(n+i)を含む項)及び第5項(Tgd(n)を含む項)のいずれか一つもしくは二つを除去した式によって、制御入力 DUT を算出するようにしてもよい。また、例えば式(40)の右辺から、第2項(素子温度T₀₂に応じた成分)、第4項(R'(n+i)を含む項)及び第5項(Tgd(n)を含む項)のいずれか一つもしくは二つを除去した式によって、制御入力 DUT を算出するようにしてもよい。また、例えば式(24)もしくは式(36)における素子温偏差 e に応じた成分や、式(28)もしくは式(40)におけるヒータ温偏差 e に応じた成分をPI制御則や、PID制御則によって求めるようにしてもよい。

また、前記各実施形態では、 O_2 センサ 8 の素子温度 T_{O2} を制御する 15 場合を例にとって説明したが、 O_2 センサ 8 以外の排ガスセンサ (例えば、前記広域空燃比センサ 9 や、排ガスの水分含有量に応じた出力を発生する湿度センサ等) についても本発明を適用することができることは 8 もちろんである。

また、内燃機関としては、通常のポート噴射式内燃機関、筒内直接噴 20 射型火花点火式内燃機関、ディーゼル機関等、さらには船外機用の内燃 機関等についても本発明を適用可能であることは言うまでも無い。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明は自動車、ハイブリッド車、船外機等に搭載さ 25 れる内燃機関の排気系に備えた排ガスセンサの温度を、該排ガスセンサ の出力特性の安定化等のために所望の温度に好適に制御し得る技術とし て有用である。

請 求 の 範 囲

- 1. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、
- 5 前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記素子 温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒー タへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、そ の制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒー タ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表 す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒー タ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴 とする排ガスセンサの温度制御装置。
- 2. 前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段を備 15 え、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、該排ガス温度データが 表す排ガスの温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲 第1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 3. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記目標温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 4. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 5. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触 25 する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度 制御装置であって、

15

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

- 10 6. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記目標温度に応じた 入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の排ガスセン サの温度制御装置。
 - 7. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 8. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記 20 素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記 ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、 その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒ ータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが 表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標 25 温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制 御装置。

25

- 9. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第8項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 10. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接 5 触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温 度制御装置であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、10 その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分と、含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

15 11. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を過熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段と、前記素子温度 データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへ の発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制 御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制 御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記素子温度データが表す素 子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温 度データが表すヒータの温度に応じた入力成分と、前記排ガス温度デー

2 = q

タが表す排ガスの温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力 成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

- 12.前記ヒータ制御手段が逐次生成する制御入力における前記排ガスの温度に応じた入力成分は、該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値とを含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより前記ヒータ制御手段が生成することを特徴とする請求の範囲第2項、第5項~第7項、及び第11項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 10 13.前記ヒータ制御手段は、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第12項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 14.前記ヒータ制御手段が逐次生成する前記目標温度に応じた入力成 分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来 値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入 力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより前記ヒータ 制御手段が生成することを特徴とする請求の範囲第3項、第6項、第8 項,第9項及び第11項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制 20 御装置。
 - 15. 前記ヒータ制御手段は、最適制御のアルゴリズムにより前記制御 入力を生成することを特徴とする請求の範囲第1項~第11項のいずれ か1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 16.前記ヒータ制御手段は、最適予見制御のアルゴリズムにより前記 25 制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第12項に記載の排ガ スセンサの温度制御装置。

15

25

- 17. 前記ヒータ制御手段は、最適予見制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第14項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 18. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接 動する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

- 19. 前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段を備え、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第18項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 20 20. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記目標温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第18項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 21. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第18項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 22. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接

10

20

触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温 度制御装置であって、

前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ドガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

- 23. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記目標温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の範囲第22項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 15 24. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の 範囲第22項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 25. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、

前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、

25 該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、

該目標温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

26. 前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分を含むことを特徴とする請求の 範囲第25項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。

27. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、

前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前 10 記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように 前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生 成し、その制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、 該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度デ ータが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、

- 15 該ヒータの温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。
 - 28. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御装置であって、
- 前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する手段と、前記 ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する手段と、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する手段と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その
 制御入力に応じてヒータを制御するヒータ制御手段とを備え、該ヒータ制御手段が生成する制御入力は、少なくとも前記ヒータ温度データが表

20

25

 ε_{C}

すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分とを含むことを特徴とする排ガスセンサの温度制御装置。

- 5 29. 前記ヒータ制御手段が逐次生成する制御入力における前記排ガス の温度に応じた入力成分は、該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後 の該排ガスの温度の未来値とを含む該排ガスの温度の時系列データに応 じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のア ルゴリズムにより前記ヒータ制御手段が生成することを特徴とする請求 10 の範囲第19項、第22項~第24項、及び第28項のいずれか1項に 記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 30. 前記ヒータ制御手段は、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第29項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 31.前記ヒータ制御手段が逐次生成する前記目標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより前記ヒータ制御手段が生成することを特徴とする請求の範囲第20項、第23項、第25項、第26項、及び第28項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 32. 前記ヒータ制御手段は、最適制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第18項~第28項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 33. 前記ヒータ制御手段は、最適予見制御のアルゴリズムにより前記

15

制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第29項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。

- 34. 前記ヒータ制御手段は、最適予見制御のアルゴリズムにより前記制御入力を生成することを特徴とする請求の範囲第31項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 35. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第1項、第5項、第8項、第10項、第11項、第18項、第22項、第25項、
- 10 第27項、及び第28項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 36. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第14項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
 - 37. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第31項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。
- 38.前記ヒータは、パルス幅制御(PWM制御)によってバッテリから通電することにより発熱する電熱ヒータであると共に、前記ヒータ制御手段が生成する制御入力は、前記パルス幅制御におけるデューティであり、該デューティを前記バッテリの電圧に応じて補正する手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第1項、第5項、第8項、第10項、第11項、第18項、第22項、第25項、第27項、及び第28項のい

ずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御装置。

10

15

20

2 = g

39. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

40. 前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得するステップをさらに備え、前記制御入力を生成するとき、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第39項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

41. 前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第39項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

42. 前記制御入力を生成するとき、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第39項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

25 43. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温

10

20

25

度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

44. 前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第43項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

45. 前記制御入力を生成するとき、前記素子温度データが表す素子部 15 の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生 成することを特徴とする請求の範囲第43項に記載の排ガスセンサの温 度制御方法。

46. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分

20

25

とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

47. 前記制御入力を生成するとき、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第46項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

48. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

49. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を過熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得しつつ、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記素子温度データが表

10

15

20

す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分と、前記排ガス温度 データが表す排ガスの温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた 入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴と する排ガスセンサの温度制御方法。

- 50. 前記制御入力に含ませた前記排ガスの温度に応じた入力成分は、 該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値と を含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入 力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成するこ とを特徴とする請求の範囲第40項、第43項~第45項、及び第49 項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 51. 前記予見制御のアルゴリズムは、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を生成するアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第50項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 52. 前記制御入力に含ませた前記目標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第41項、第44項、第46項,第47項及び第49項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 53. 前記制御入力を、最適制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第39項~第49項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 25 54. 前記制御入力を、最適予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第50項に記載の排ガスセンサの温度制御方

法。

10

15

20

55. 前記制御入力を、最適予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第52項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

5 5 6 . 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得しつつ、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

57. 前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得するステップをさらに備え、前記制御入力を生成するとき、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第56項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

- 58. 前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分を さらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請 求の範囲第56項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 25 59. 前記制御入力を生成するとき、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として

20

い生成することを特徴とする請求の範囲第56項に記載の排ガスセンサ の温度制御方法。

60. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す 排ガス温度データとを逐次取得しつつ、前記ヒータ温度データが表すヒ ータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギ ーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒ ータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なく とも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差 に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じ た入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴 とする排ガスセンサの温度制御方法。

- 15 61. 前記制御入力を生成するとき、前記目標温度に応じた入力成分を さらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請 求の範囲第60項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
 - 62. 前記制御入力を生成するとき、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする請求の範囲第60項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
 - 63. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、
- 25 前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得しつつ、前記ヒ ータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記

10

ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、 その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力 を生成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度 と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力 成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする 排ガスセンサの温度制御方法。

64. 前記制御入力を生成するとき、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む制御入力を前記制御入力としてい生成することを特徴とする請求の範囲第63項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

6 5. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、

前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得しつつ、前記ヒ ータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記 ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、 その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力 を生成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度 と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該ヒータの温度に応じた 20 入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴と する排ガスセンサの温度制御方法。

- 66. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度制御方法であって、
- 25 前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒ ータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取

得しつつ、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成し、その制御入力に応じてヒータを制御するステップを備え、前記制御入力を生成するとき、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分とを含む制御入力を前記制御入力として生成することを特徴とする排ガスセンサの温度制御方法。

- 10 67.前記制御入力に含ませた前記排ガスの温度に応じた入力成分は、 該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値と を含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入 力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第57項、第60項~第62項、及び第66 項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
 - 68. 前記予見制御のアルゴリズムは、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を生成するアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第67項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 20 69. 前記制御入力に含ませた前記目標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第58項、第61項、第63項、第64項、及び第66 項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
 - 70.前記制御入力を、最適制御のアルゴリズムにより生成することを



特徴とする請求の範囲第56項~第66項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

- 71. 前記制御入力を、最適予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第67項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
 - 72. 前記制御入力を、最適予見制御のアルゴリズムにより生成することを特徴とする請求の範囲第69項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 73. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後 10 期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第39項、第43項、第46項、第48項、第49項、第56項、第60項、第63項、第65項、及び第66項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 15 74. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第52項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 75. 前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後 20 期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温 度よりも低い温度に設定されることを特徴とする請求の範囲第69項に 記載の排ガスセンサの温度制御方法。
- 76.前記ヒータは、パルス幅制御(PWM制御)によってバッテリから通電することにより発熱する電熱ヒータであると共に、前記生成する 15 制御入力は、前記パルス幅制御におけるデューティであり、該デューティを前記バッテリの電圧に応じて補正するステップを備えたことを特徴

10

15

20

25

とする請求の範囲第39項、第43項、第46項、第48項、第49項、第56項、第60項、第63項、第65項、及び第66項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御方法。

77. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

78. 前記温度制御用プログラムは、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムをさらに含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていること

10

15

20

25

を特徴とする請求の範囲第77項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

79. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第77項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

80. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第77項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

81. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分と

10

15

20

25

2 - p

を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。82.前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第81項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

83.前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第81項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

84. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されているこ

10

15

20

25

ē

とを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

85.前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第84項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

86. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該素子部の温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。87. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であ

って、

5

10

15

20

前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記素子温度データが表す素子部の温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムのアルゴリズムは、クなくとも前記素子温度データが表す素子部の温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記ヒータ温度データが表す非ガスの温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

88.前記制御入力に含まれる前記排ガスの温度に応じた入力成分は、該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値とを含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第78項、第81項~第83項、及び第87項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

89. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記排ガスの温 25 度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一で あるとして前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成さ

10

れていることを特徴とする請求の範囲第88項に記載の排ガスセンサの 温度制御用プログラムの記録媒体。

- 90.前記制御入力に含まれる前記目標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第79項、第82項、第84項,第85項及び第87項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 91. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、最適制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第77項~第87項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 92. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、最適予見制御の 15 アルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第88項に記載の排ガ スセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
 - 93. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、最適予見制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第90項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 20 94. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
- 25 前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データとを逐次取得する処理を

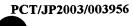
10

15

 \mathcal{L}_{i}

前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記素子温度データが表す素子部の温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

- 95.前記温度制御用プログラムは、前記排ガスの温度を表す排ガス温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムをさらに含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、該排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第94項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 96. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に 20 応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第94項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 97. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記ヒータ温度 データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入力 25 を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とす る請求の範囲第94項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの



記録媒体。

5

10

15

98. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように該ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

- 20 99. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記目標温度に 応じた入力成分をさらに含む前記制御入力を前記コンピュータに生成さ せるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第98項に記載 の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。
- 100. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記ヒータ温 25 度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入 力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴と

10

15

20

2 - 6

する請求の範囲第98項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

101. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度デ ータを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、 前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるよう に前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次 生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラム と、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに 実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴ リズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記 目標温度との偏差に応じた入力成分と、該目標温度に応じた入力成分と を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されて いることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。 102.前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記ヒータ温 度データが表すヒータの温度に応じた入力成分をさらに含む前記制御入 力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴と する請求の範囲第101項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラ ムの記録媒体。

103. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに 25 接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの 素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制

10

御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記温度制御用プログラムは、前記ヒータの温度を表すヒータ温度データを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、該ヒータの温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

- 15 104. 内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの素子部の温度を制御するための処理をコンピュータに実行させる温度制御用プログラムを記憶保持したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
- 前記温度制御用プログラムは、前記素子部の温度を表す素子温度データと前記ヒータの温度を表すヒータ温度データと前記排ガスの温度を表す排ガス温度データとを逐次取得する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムと、前記ヒータ温度データが表すヒータの温度が所定の目標温度になるように前記ヒータへの発熱用エネルギーの供給量を規定する制御入力を逐次生成する処理を前記コンピュータに実行させる制御入力生成プログラムと、その制御入力に応じてヒータを制御する処理を

20

25

前記コンピュータに実行させるプログラムとを含み、前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、少なくとも前記ヒータ温度データが表すヒータの温度と前記目標温度との偏差に応じた入力成分と、前記排ガス温度データが表す排ガスの温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分と、前記目標温度に応じた入力成分とを含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

105.前記制御入力に含まれる前記排ガスの温度に応じた入力成分は、 該排ガスの温度の現在値と第1所定時間後の該排ガスの温度の未来値と を含む該排ガスの温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入 力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制御入 力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第95項、第98項~第100項、及び第1 04項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの 記録媒体。

106. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記排ガスの温度の第1所定時間後までの未来値が、該排ガスの温度の現在値と同一であるとして前記制御入力を前記コンピュータに生成させるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第105項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

107.前記制御入力に含まれる前記目標温度に応じた入力成分は、該目標温度の現在値と第2所定時間後における該目標温度の未来値とを含む該目標温度の時系列データに応じた入力成分であり、その入力成分を含む前記制御入力を前記コンピュータに生成させる前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、予見制御のアルゴリズムであることを特徴

25



とする請求の範囲第96項、第99項、第101項、第102項、及び 第104項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラ ムの記録媒体。

108. 前記制御入力生成用プログラムのアルゴリズムは、最適制御の 5 アルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第94項~第104項 のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒 体。

109. 前記制御入力生成用プログラムのアルゴリズムは、最適制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第105項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

110. 前記制御入力生成用プログラムのアルゴリズムは、最適制御のアルゴリズムであることを特徴とする請求の範囲第107項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

111.前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度が、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第77項、第81項、第84項、第86項、第87項、第94項、第98項、第101項、第103項、及び第104項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

112. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記内燃機関の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度が、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第90項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

113. 前記制御入力生成プログラムのアルゴリズムは、前記内燃機関

PCT/JP2003/003956

の始動後、第3所定時間が経過するまでの始動直後期間における前記目標温度は、該始動直後期間の経過後における目標温度よりも低い温度に設定されるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第107項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

5 114.前記ヒータは、パルス幅制御(PWM制御)によってバッテリから通電することにより発熱する電熱ヒータであると共に、前記制御入力生成プログラムにより前記コンピュータに生成させる前記制御入力はは、前記パルス幅制御におけるデューティであり、前記温度制御用プログラムは、前記制御入力生成プログラムにより生成させた該デューティ10 を前記バッテリの電圧に応じて補正する処理を前記コンピュータに実行させるプログラムをさらに含むことを特徴とする請求の範囲第77項、第81項、第84項、第86項、第87項、第94項、第98項、第101項、第103項、及び第104項のいずれか1項に記載の排ガスセンサの温度制御用プログラムの記録媒体。

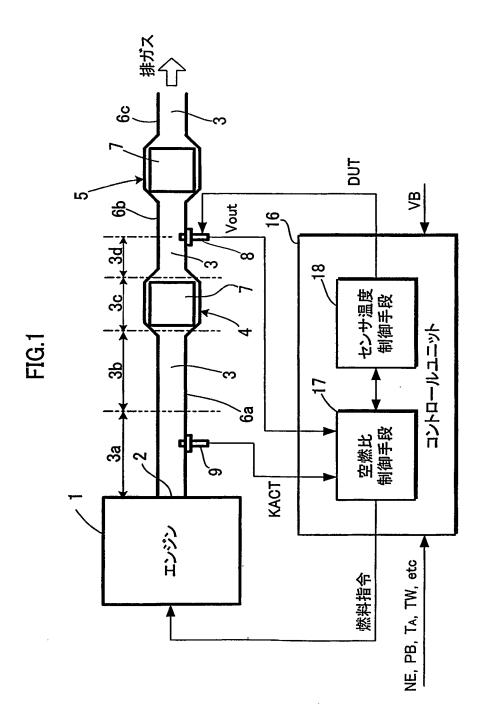


FIG.2

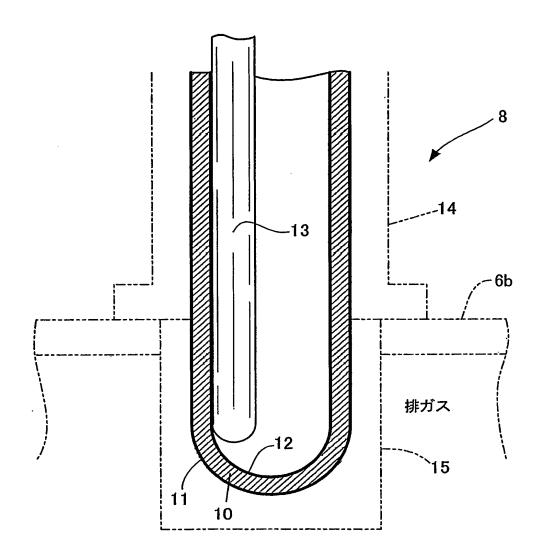
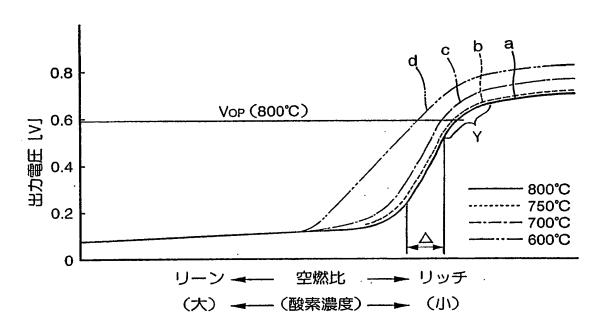
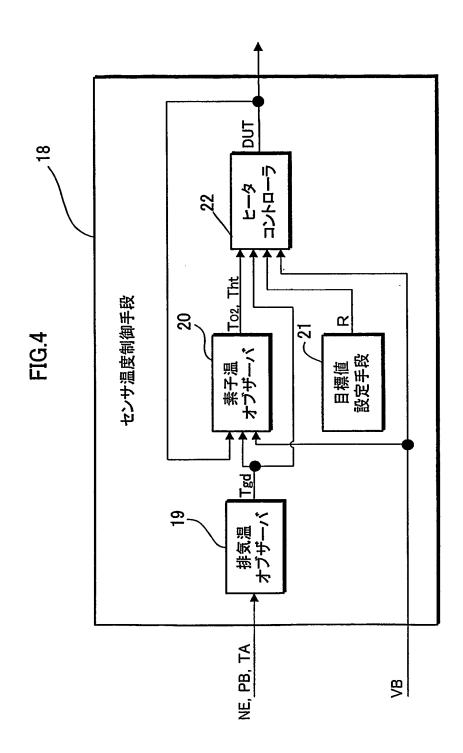
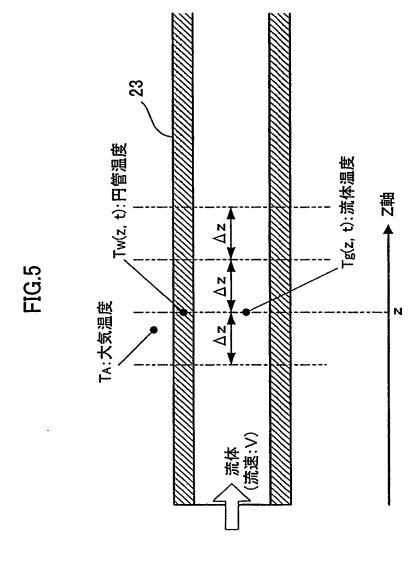


FIG.3

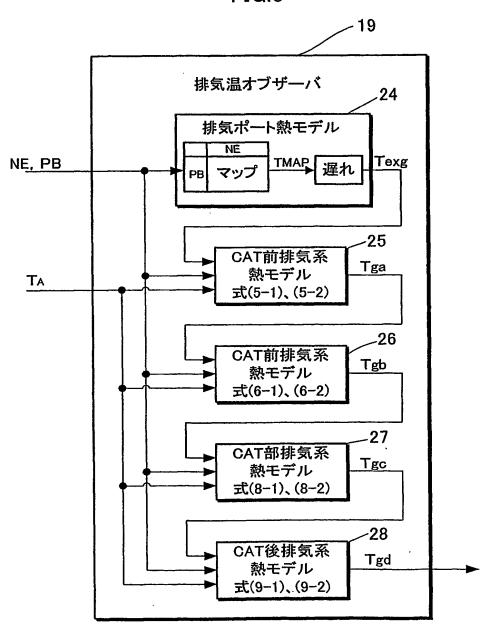


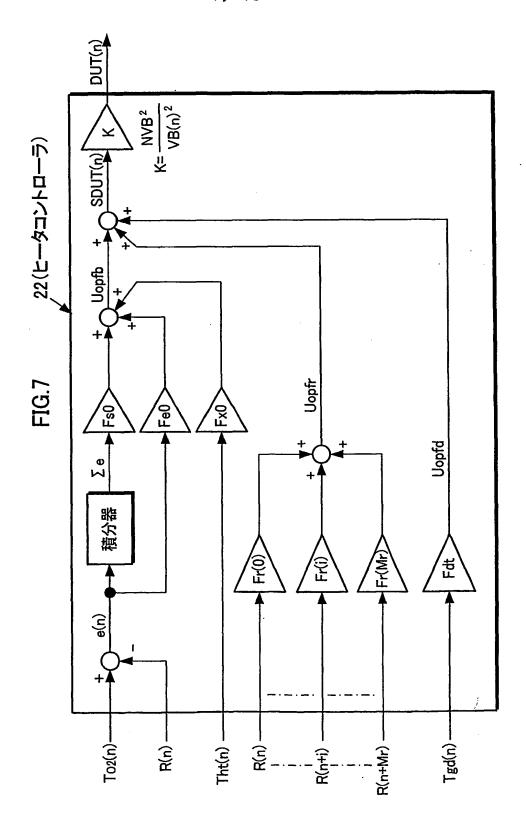




r,

FIG.6





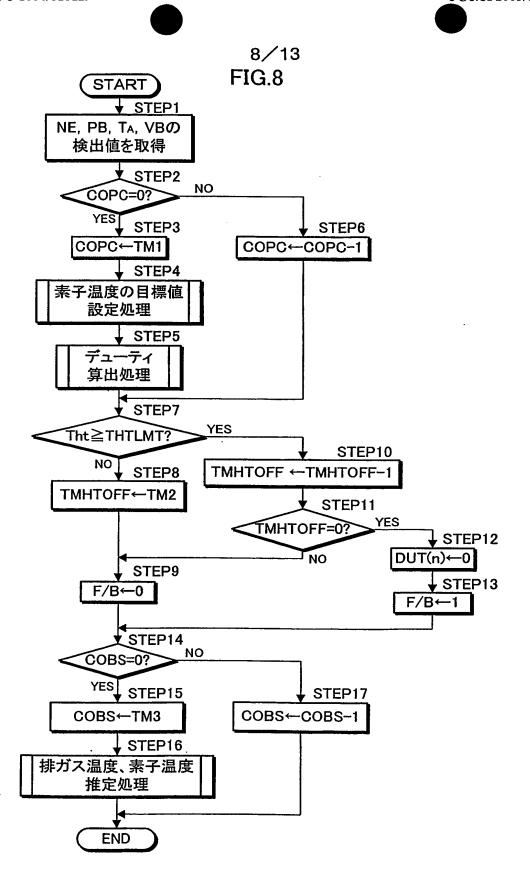


FIG.9

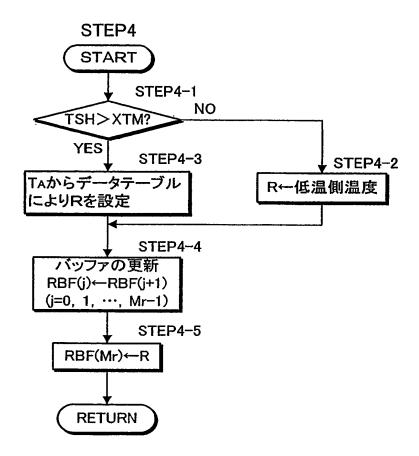




FIG.10

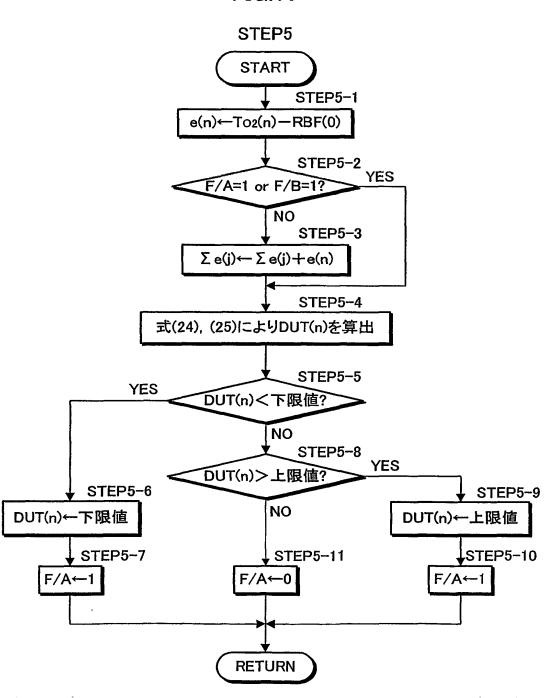


FIG.11

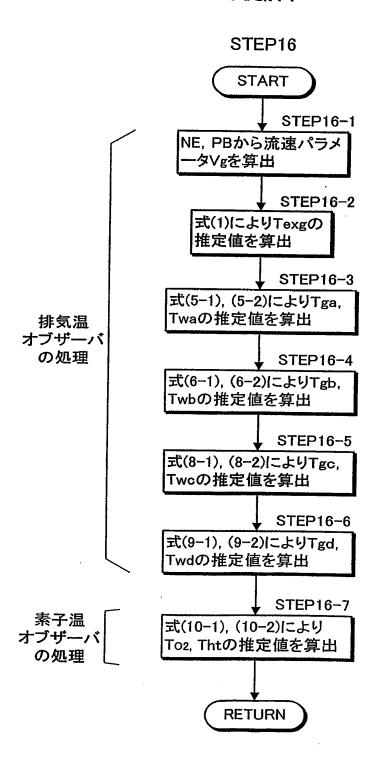


FIG.12

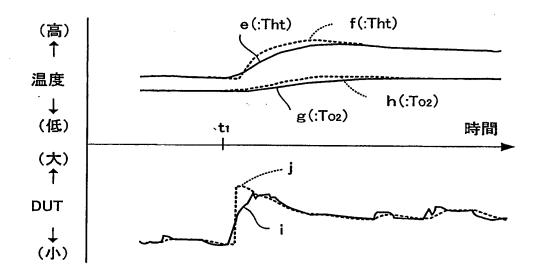
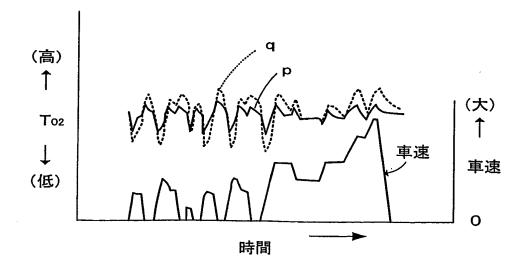
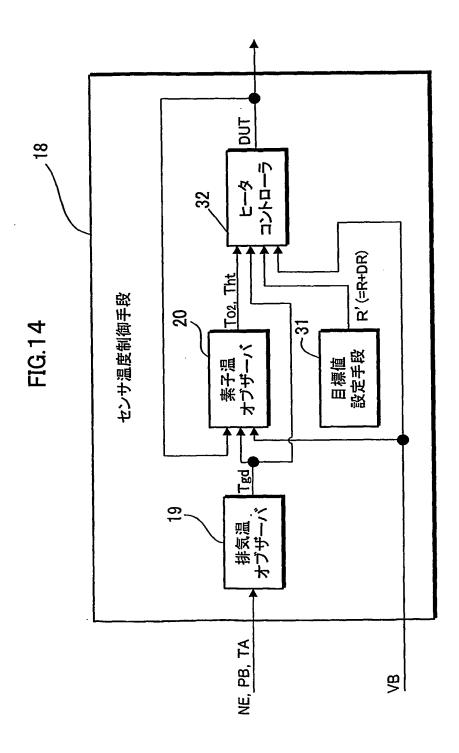


FIG.13





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PJP03/03956

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G01N27/409, 27/419, 27/41, F02D41/14			
INC.C1 GUIN2//409, 2//419, 2//41, FUZD41/14			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01N27/409, 27/419, 27/41, F02D41/14			
INC.C1 GUIN2//409, 2//419, 2//41, FU2D41/14			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are in	ncluded in the fields searched		
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shina			
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2003 Jitsuyo Shinan Torok	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical	able, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage	s Relevant to claim No.		
A JP 1-172745 A (Honda Motor Co., Ltd.),	1-114		
07 July, 1989 (07.07.89), Full text; all drawings			
(Family: none)			
A Microfilm of the specification and drawings ann	exed 1-114		
to the request of Japanese Utility Model Applica			
No. 72561/1983 (Laid-open No. 72561/1985)			
(Nissan Motor Co., Ltd.), 22 May, 1985 (22.05.85),			
Full text; all drawings			
(Family: none)			
	:		
X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.			
	er the international filing date or ict with the application but cited to		
considered to be of particular relevance understand the principle or t	heory underlying the invention ance; the claimed invention cannot be		
date considered novel or cannot b	e considered to involve an inventive		
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevant	ance; the claimed invention cannot be		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more or	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
means combination being obvious to a person skilled in the art "6" document published prior to the international filing date but later "6" document member of the same patent family than the priority date claimed			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
30 June, 2003 (30.06.03) 22 July, 2003			
30 dane, 2003 (30.08.03) 22 daily, 2003	onal search report (22.07.03)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			



C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 119911/1984(Laid-open No. 34469/1987) (Nissan Motor Co., Ltd.), 03 March, 1986 (03.03.86), Full text; all drawings (Family: none)	1-114	
A	JP 2000-249677 A (Suzuki Motor Corp.), 14 September, 2000 (14.09.00), Full text; all drawings (Family: none)	1-114	
E,A	JP 2003-65999 A (Denso Corp.), 05 March, 2003 (05.03.03), Full text; all drawings (Family: none)	1-114	
А	JP 7-167830 A (Robert Bosch GmbH.), 04 July, 1995 (04.07.95), Full text; all drawings & DE 4106308 A1	1-114	
A	JP 8-278279 A (Nippondenso Co., Ltd.), 22 October, 1996 (22.10.96), Full text; all drawings & EP 695983 A2 & US 5719778 A1 & KR 242812 B	1-114	
A	JP 2003-97323 A (Hitachi, Ltd.), 03 April, 2003 (03.04.03), Full text; all drawings (Family: none)	1-114	
A .	JP 2001-324469 A (Unisia Jecs Corp.), 22 November, 2001 (22.11.01), Full text; all drawings & DE 10124129 A & US 2002-8100 A1	1-114	
A	JP 10-10074 A (Toyota Motor Corp.), 16 January, 1998 (16.01.98), Full text; all drawings & DE 19726601 A & US 5752493 A1	1-114	
A	JP 2000-292407 A (Toyota Motor Corp.), 20 October, 2000 (20.10.00), Full text; all drawings & US 2002-3831 Al	1–114	



Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
bookies they relate to subject matter not required to be sometice by this radiority, manery.
\cdot
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
ortale data no managete montalona out on the bottom out, spoomount.
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
(See extra sheet.)
·
1
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.
2. X As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.

Continuation of Box No. II of continuation of first sheet (1)

The inventions of the claims are classified into ten groups of inventions listed below according to their technical features.

- I. Claims 1-4, 39-42, 77-80
- II. Claims 5-7, 43-45, 81-83
- III. Claims 8-9, 46-47, 84-85
- IV. Claims 10, 48, 86
- V. Claims 11-17, 49-55, 87-93
- VI. Claims 18-20, 56-59, 94-97
- VII. Claims 22-24, 60-62, 98-100
- VIII. Claims 25, 26; 63, 64; 101, 102
- IX. Claims 27, 65, 103
- X. Claims 28-38, 66-76, 104-114

The technical feature common to the ten groups of inventions is temperature control of an exhaust gas sensor disposed in an exhaust gas passage of an internal combustion engine and having an element part in contact with the exhaust gas flowing through the exhaust gas passage and a heater for heating the element part.

However, the international search has revealed that this common technical feature is not novel since it is disclosed in the documents cited in this international search report.

Consequently, the common feature is not a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, since it makes no contribution over the prior art.

Therefore, there is no feature common to all the claims.

Since there exists no other common feature which can be considered as a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, no technical relationship within the meaning of PCT Rule 13 between the different inventions can be seen.

Consequently, it appears that the ten groups of inventions I to X do not satisfy the requirement of unity of invention.

Int. Cl G01N27/409, 27/419, 27/41, F02D41/14

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ G01N27/409, 27/419, 27/41, F02D41/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1994-2003年 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

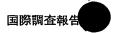
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 1-172745 A(本田技研工業株式会社) 1989.07.07 全文、全図 (ファミリーなし)	1–114
A	日本国実用新案登録出願58-72561号(日本国実用新案登録出願公開60-72561号)の願書に添付した明細書及び及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(日産自動車株式会社)1985.05.22 全文、全図 (ファミリーなし)	1-114

× C欄の続きにも文献が列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出版	順 「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了した日 30.06.03	国際調査報告の発送日 22.07.03
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 黒田 浩一 2 J 9218
郵便番号100-8915 東京都千代田区館が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3251



C (続き).	関連すると認められる文献	7,
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	日本国実用新案登録出願59-119911号(日本国実用新案登録出願公開61-34469号)の願書に添付した明細書及び及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(日産自動車株式会社)1986.03.03 全文、全図 (ファミリーなし)	1-114
A	JP 2000-249677 A(スズキ株式会社) 2000.09.14 全文、全図 (ファミリーなし)	1-114
E, A	JP 2003-65999 A(株式会社デンソー) 2003.03.05 全文、全図 (ファミリーなし)	1-114
A	JP 7-167830 A(ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト ミツト ベシュレンクテル ハフツング) 1995.07.04 全文、全図 & DE 4106308 A1	1-114
A	JP 8-278279 A(日本電装株式会社) 1996.10.22 全文、全図 & EP 695983 A2 & US 5719778 A1 & KR 242812 B	1-114
A	JP 2003-97323 A(株式会社日立製作所) 2003.04.03 全文、全図 (ファミリーなし)	1-114
A	JP 2001-324469 A(株式会社ユニシアジェックス) 2001.11.22 全文、全図 & DE 10124129 A & US 2002-8100 A1	1-114
A	JP 10-10074 A(トヨタ自動車株式会社) 1998.01.16 全文、全図 & DE 19726601 A & US 5752493 A1	1-114
A	JP 2000-292407 A(トヨタ自動車株式会社) 2000.10.20 全文、全図 & US 2002-3831 A1	1-114

	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条成しなか	第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作った。
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 🗌	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
з. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に过	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
別	J紙参照
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. 🗵	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	至手数料の異識の申立てに関する注意] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
Ī	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

第Ⅱ欄の続き

請求の範囲に記載の発明はその技術的特徴から、以下の10の発明群に分類されると認める。

- I. 請求の範囲1-4、39-42、77-80
- Ⅱ. 請求の範囲5-7、43-45、81-83
- Ⅲ. 請求の範囲8-9、46-47、84-85
- IV. 請求の範囲10、48、86
- V. 請求の範囲11-17、49-55、87-93
- VI. 請求の範囲18-20、56-59、94-97
- WI. 請求の範囲22-24、60-62、98-100
- WII. 請求の範囲25-26、63-64、101-102
- IX. 請求の範囲27、65、103
- X. 請求の範囲28-38、66-76、104-114

上記10の発明群に共通の技術的事項は、内燃機関の排気通路に配置され、該排気通路を 流れる排ガスに接触する素子部と該素子部を加熱するヒータとを有する排ガスセンサの温度 制御である。

しかしながら、調査の結果、この共通の技術事項は、この国際調査報告で引用したいずれの文献にも開示されているから、新規でないことが明らかとなった。

結果として、上記共通の技術事項は、先行技術の域を出ないから、PCT規則13.2の 第2文の意味において、この共通事項は特別な技術的特徴ではない。

それ故、上記発明群全てに共通の技術的事項はない。

PCT規則13.2の第2文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通事項は存在しないので、それらの相違する発明群の間にPCT規則13の意味における技術的関連を見いだすことはできない。

よって、上記I-Xの10の発明群は、相互に発明の単一性を満たしていないことが明らかである。